



อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราซาวนิค

INFRASONIC DETECTOR



นายภาณุมาศ บำรุง

รหัส 51364446

นายอัครเดช แย้มนิยม

รหัส 51364576

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ.....๕๔.๘.๒๕๕๕.....
เลขทะเบียน..... ๑๖๐๖๙๙๔๘.....
ผู้รับ.....
หมายเหตุ.....
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๘๔๑๗๙
๒๕๘๔.

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีการศึกษา ๒๕๕๔



ใบรับรองโครงการวิศวกรรม

หัวข้อโครงการ	อุปกรณ์ตรวจคุณลักษณะอินฟราโซนิก		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภาณุมาศ จำครี	รหัส 51364446	
	นายอัครเดช แย้มนิยม	รหัส 51364576	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2554		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร อนุมัติให้ โครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

.....ที่ปรึกษาโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุ่ง)

.....กรรมการ

(ดร. อัครพันธ์ วงศ์กังแหง)

.....กรรมการ

(อาจารย์เศรษฐา ตั้งคำวานิช)

หัวข้อโครงการ	อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราไซนิค		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายภานุมาศ บำรุง	รหัส 51364446	
	นายอัครเดช แย้มนิยม	รหัส 51364576	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ชนบดีเคลินรุ่ง		
สาขาวิชา	วิศวกรรมไฟฟ้า		
ภาควิชา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์		
ปีการศึกษา	2554		

บทคัดย่อ

โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราไซนิคที่เกิดจากแผ่นดินไหวเป็นส่วนสำคัญ เพื่อช่วยในการเตือนภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ โดยใช้ไมโครโฟน WM-61A รับสัญญาณเสียงและผ่านวงจรกรองความถี่ให้อยู่ในช่วง 0.1-20 Hz ในตัวอุปกรณ์เราได้ใช้ไอซี LT1014 2 ตัว (Op-Amp 8 ตัว) ในการกรองความถี่ใช้งานในช่วง 0.1-20 Hz รวมถึงภาคขยาย การอินทิเกรเตอร์ เนื่องจากการรับคลื่นอินฟราไซนิกของไมโครโฟนรับได้ไม่ดีในช่วงความถี่ 0.1-12 Hz จึงจำเป็นต้องซักเชยการตอบสนองความถี่ให้กับไมโครโฟนด้วย ชิ้นผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะวัดความถี่ 0.1-20 Hz ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณคลื่นอินฟราไซนิกจากอุปกรณ์ตรวจจับนี้จะถูกนำไปแสดงเป็นสัญญาณจากเครื่องออสซิลโลสโคปหรือเครื่องวัดสัญญาณต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์การเกิดขึ้นของคลื่นอินฟราไซนิกต่อไป

Project title	Infrasonic Detector	
Name	Mr. Panumaas Khamsri	ID. 51364446
	Mr. Accaradet Yamniyom	ID. 51364576
Project advisor	Assistant Professor Yongyut Chonbodeechalermroong, Ph.D.	
Major	Electrical Engineering	
Department	Electrical and Computer Engineering	
Academic	year 2011	

Abstract

This project is created for developing the infrasonic wave detectors for faster warning to the people in disaster areas, by using the WM-61A microphone for receiving the audio sound and passing through the filter in the range of frequency 0.1-20 Hz. This device uses two LT1014 ICs (8 Op-Amps) with the band pass frequency of 0.1-20 Hz, the audio signal amplifier and integrator circuits due to the weak response of the microphone in the range 0.1-12 Hz. Therefore, to add up the frequency response is also required to the microphone. As a result, the frequency of 0.1-20 Hz is measured effectively.

The infrasonic wave from the detector is then showed as a signal on the oscilloscope or the other instruments for further analysis.

กิตติกรรมประกาศ

ทางคณะผู้จัดทำโครงการ “อุปกรณ์ตรวจดักลืนอินฟราโซนิก” ขอขอบคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ชนบดีเกลิมรุ่ง ที่ให้ความช่วยเหลือในโครงการนี้ให้สามารถ
ดำเนินไปได้ด้วยดี โดยให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการตลอด ทั้งให้ความเอื้อเพื่อทั้งด้าน<sup>อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ อีกทั้งอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ให้
คำแนะนำและช่วยเหลือในครั้งนี้</sup>

นายภานุมาศ จำรัส
นายอัครเดช แย้มนิยม



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๒
กิตติกรรมประกาศ.....	๓
สารบัญ.....	๔
สารบัญตาราง.....	๕
สารบัญรูป.....	๖

บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
-------------------	---

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	๒
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	๓
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ.....	๔
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ.....	๕
1.6 งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....	๖

บทที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	๓
---------------------------------	---

2.1 ประการณ์ทางธรรมชาติ.....	๔
2.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง.....	๗
2.2.1 ตัวต้านทาน.....	๗
2.2.2 ตัวเก็บประจุ.....	๑๐
2.2.3 ไคโอด (diode).....	๑๑
2.2.4 օอปแอมป์ (Op-Amp).....	๑๒
2.2.5 คอนเดนเซอร์ไมค์ (Condenser Microphones).....	๑๔
2.3 วงจรพื้นฐาน.....	๑๕
2.3.1 วงจรขยายแบบอินทิเกรต (Ideal Integrating Amplifier).....	๑๕
2.3.2 วงจรอินทิเกรเตอร์ (Practical Integrator circuit).....	๑๖

2.3.3 วงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter).....	17
2.3.4 วงจรกรองความถี่สูง (High Pass Filter).....	19
2.3.5 วงจรกรองความถี่เป็นช่วง (Band Pass Filter).....	20
2.3.6 วงจรขยายเบนรวมสัญญาณ (Summing Amplifier).....	22
 บทที่ 3 วิธีการออกแบบการทดลอง.....	24
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	24
3.1.1 เครื่องตรวจจับคลื่นอินฟราเรด.....	24
3.1.2 เครื่องขยายเสียงความถี่ 0.07Hz-100kHz.....	25
3.2 หลักการทั่วไป.....	26
3.3 วิธีการออกแบบ.....	27
3.3.1 ศึกษาวงจรภาคจ่ายไฟ (power supply)	27
3.3.2 โครงสร้างแสดงการต่ออุปกรณ์แบบละเอียด	28
3.4 การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off ในส่วนต่างๆ.....	29
3.4.1 วงจร Summing.....	29
3.4.3 วงจรอินทิเกรเตอร์ (Integrator circuit).....	30
3.4.2 วงจร Band Pass Filter ในตำแหน่ง U2B.....	33
 บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	35
4.1 ระบบการทำงาน.....	35
4.1.1 ภารรับสัญญาณเสียง.....	35
4.1.2 ภาคประมวลผล.....	35
4.1.3 ภาคกำเนิดสัญญาณเสียง.....	36
4.2 วิธีทำการทดลองและผลการทดลอง.....	37
4.2.1 การวัดผลตอบสนองความถี่ของเครื่อง Stereo integrated amplifier.....	37
4.2.2 การวัดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ร่วมกับภาคประมวลผล ของเครื่อง Stereo integrated amplifier.....	39
4.2.3 การวัดผลตอบสนองความถี่ของเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge.....	41

4.2.4 การวัดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ร่วมกับภาคประมวลผล ของเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge.....	43
4.2.5 การทดสอบการกระแสเพื่อนของคอกล้าม.....	44
4.2.6 การทดสอบการตอบสนองของไมโครโฟน WM-61A.....	48
4.2.7 ผลการตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรด.....	49
4.2.8 ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดที่ผ่านการซ่อมแซม ผลงานไมโครโฟนแล้ว (ใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณแบบ Bridge).....	65
 บทที่ 5 สรุปผล.....	 71
5.1 สรุปผลของโครงงาน.....	71
5.2 ปัญหาที่พบ.....	72
5.2.1 ปัญหาทางด้านแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง.....	72
5.2.2 ปัญหาทางด้านตัวขยายสัญญาณ.....	72
5.2.3 ปัญหาทางด้านไมโครโฟน.....	72
5.3 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ.....	72
5.3.1 แก้ไขปัญหาทางด้านแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง.....	72
5.3.2 แก้ไขปัญหาทางด้านตัวขยายสัญญาณ.....	72
5.3.3 แก้ไขปัญหาทางด้านไมโครโฟน.....	73
5.4 แนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติม.....	73
เอกสารอ้างอิง.....	74
ภาคผนวก.....	75

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ.....	2
4.1 ผลตอบสนองความถี่เครื่อง Stereo integrated amplifier.....	37
4.2 แสดงลายละเอียดสำ้าโพงที่ใช้ในการทดสอบ.....	39
4.3 ตารางผลการทดสอบสำ้าโพง.....	41
4.4 ผลตอบสนองความถี่เครื่องขยายเสียงแบบ Bridge.....	42
4.5 ค่าแรงดันอินพุตที่ทำให้สำ้าโพงกระเพื่อมขึ้นที่ 4 mm. โดยมีค่ากลางที่ 5.5 mm.	47
4.6 แสดงการทดสอบการตอบสนองของไมโครโฟน WM-61A.....	48
4.7 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรรวมสัญญาณ.....	50
4.8 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจร Band Pass Filter.....	52
4.9 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A.....	55
4.10 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B.....	58
4.11 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2B.....	61
4.12 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของอุปกรณ์ Infrasonic detector.....	64
4.13 แสดง V_{out} (V_{p-p}) ที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดโดยการซัดเชิงการตกของไมโครโฟน กำหนดให้สำ้าโพงกระเพื่อมเท่ากันคือ 4 mm. โดยที่ไมโครโฟนห่างจากสำ้าโพงระยะ 20, 50 และ 80 cm.....	68

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แผ่นดินไหวที่ชานฟรานซิสโกเมื่อ พ.ศ. 2449.....	3
2.2 ความเสียหายของอาคารจากแผ่นดินไหวที่โภเบ เมื่อ พ.ศ. 2538.....	3
2.3 แสดงตำแหน่งแผ่นดินไหว.....	6
2.4 ชนิดตัวถ่านหก.....	8
2.5 ตัวเก็บประจุ.....	10
2.6 ตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ.....	10
2.7 ໄໂໂອດເທິບກັບສັງລັກຢືນຂອງໄໂໂອດແບນສາກົ່ງຕັວນໍາ.....	11
2.8 ໄໂໂອດນິດຕ່າງໆ.....	11
2.9 ກາຟຄຸນສົມບັດເພາະຂອງກະຮະແສແລະແຮງດັນຂອງຮອຍຕ່ອ p-n ຂອງໄໂໂອດ.....	12
2.10 ແສດງສັງລັກຢືນອັປແອນປີ.....	13
2.11 Condenser Microphone.....	14
2.12 ວົງຈະຍາຍແບນອິນທີເກຣຕ.....	15
2.13 ວົງຈະອິນທີເກຣເຕອຣ.....	16
2.14 ພຸດຕອນສັນອົງຂອງວົງຈະ Integrator.....	17
2.15 ລັກຢະບາດຂອງວົງຈະຮອງຄວາມດີຕໍ່າ.....	18
2.16 ກາຟທີ່ຂອງກະຮະຮອງຄວາມດີຕໍ່າ.....	19
2.17 ລັກຢະບາດຂອງວົງຈະຮອງຄວາມດີສູງ.....	19
2.18 ກາຟທີ່ຂອງກະຮະຮອງຄວາມດີສູງ.....	20
2.19 ລັກຢະບາດຂອງວົງຈະຮອງຄວາມດີເປັນຫົວ.....	20
2.20 ກາຟທີ່ຂອງກະຮະຮອງຄວາມດີເປັນຫົວ.....	22
2.21 ວົງຈະຮັມສັງຄູາລົດໃຫ້ອອບື່ແອນປີ.....	22
3.1 Block Diagram ແສດງຫລັກກາທ໌ກໍານົດທ້າໄປ.....	26
3.2 ວົງຈະກາຄຈ່າຍໄຟ (power supply).....	27
3.3 ແສດງລາຍງານແບນລະເລືດ.....	28
3.4 ແສດງວົງຈະຮັມສັງຄູາ.....	29

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.5 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U1D.....	30
3.6 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U2A.....	31
3.7 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U1B.....	32
3.8 วงจร Band Pass Filter.....	33
4.1 ไมโครโฟน Panasonic WM-61A.....	35
4.2 ภาคจ่ายไฟ (Power supply).....	36
4.3 แมงวังจรประมวลผลสัญญาณ.....	36
4.4 ผลตอบสนองของเครื่อง Stereo integrated amplifier.....	38
4.5 แสดงการทดสอบลำโพง.....	39
4.6 ตัวอย่างการทดสอบลำโพงยีห้อ Obom.....	40
4.7 แสดงการทำสอบเครื่องเคาะสัญญาณเวลา.....	40
4.8 การต่อเครื่องขยายสัญญาณ Stereo integrated amplifier กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลา.....	40
4.9 ผลตอบสนองความถี่เครื่องขยายเสียงแบบ Bridge.....	43
4.10 วงจรเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge.....	44
4.11 แสดงการทดสอบลำโพง.....	44
4.12 ตัวอย่างการทดสอบลำโพงยีห้อ Anaba.....	45
4.13 ขั้นตอนการทดสอบลำโพง.....	45
4.14 ลักษณะการผ่าดินสอทางค้านหัวและท้ายของดินสอ.....	46
4.15 การติดดินสอบนคอกระดูก.....	46
4.16 การติดกระดายกับไม้บรรทัดเหล็ก.....	46
4.17 ขั้นตอนที่ทดสอบลำโพงยังไม่กระเพื่อม.....	47
4.18 ทำการวัดการกระเพื่อมของคอกระดูก.....	47
4.19 ผลการกระเพื่อมของคอกระดูก.....	47
4.20 การตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน WM-61A แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความถี่กับ V_{out}	50

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.21 ผลตอบสนองความถี่ของรวมสัญญาณที่ได้จากโปรแกรม Pspice.....	52
4.22 แสดงผลตอบสนองความถี่ของรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง.....	52
4.23 ผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1D ที่ได้จากโปรแกรม Pspice.....	54
4.24 แสดงผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1D ที่ได้จากการทดลอง.....	55
4.25 ผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A ที่ได้จากโปรแกรม Pspice	57
4.26 แสดงผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A ที่ได้จากการทดลอง....	58
4.27 ผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice.....	60
4.28 แสดงผลตอบสนองความถี่ของร่องอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B ที่ได้จากการทดลอง....	61
4.29 ผลตอบสนองความถี่ของร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice....	63
4.30 แสดงผลตอบสนองความถี่ของร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B ที่ได้จากการทดลอง.....	64
4.31 ผลตอบสนองของอุปกรณ์ Infrasonic detector.....	66
4.32 แสดงการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิก.....	67
4.33 ตัวอย่างแสดงลักษณะการตรวจไมโครโฟนห่างจากตัวลำโพง.....	67
4.34 สัญญาณทางเวลาที่ความถี่ 9 Hz โดยไมโครโฟนห่างจากลำโพงระยะ 50 cm.	68
4.35 ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิก แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ กับ V_{out} (V_{pp}) โดยไมโครโฟนกับลำโพงห่างกัน 20, 50 และ 80 cm.	70

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ปัจจุบันเหตุการณ์ที่โลกเราได้ประสบกับวิกฤติการณ์ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงมากมายในปัจจุบัน โลกก็ยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จัดเป็นกระบวนการธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของพลังงาน โดยเกิดขึ้นทั้งใน บรรยากาศบนผิวโลก พื้นโลก พื้นสมุทร รวมถึงในชีวิณฑ์ (Biosphere) ด้วย มีตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่ไม่รุนแรงและเกิดขึ้นเสมอๆ ไปจนถึงเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัตร้ายแรงและเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าภัยธรรมชาติต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินภัยธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่มนุษย์ก็มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยภัยธรรมชาติครั้งล่าสุด ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด คือภัยไฟป่าที่เผาไหม้ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา น้ำหนักไฟเผาไหม้ต่อวันประมาณ 8.6 ริกเตอร์ที่ภาวะสูmatra ประเทศอินโดนีเซีย มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงใต้พื้นทะเล 33 กิโลเมตร ห่างจากเมืองบันดา อะจะห์ ของจังหวัดอะจะห์ ทางตอนเหนือของเกาะสูmatra 495 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงภาคใต้ของไทย และบางพื้นที่ของกรุงเทพ ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงภาระทางการท่องเที่ยวในไทยอีกด้วย

จากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแห่งนั้น หลายครั้งเห็นได้ว่าการเตือนภัยทำได้ล่าช้า จนเป็นเหตุให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้คิดและพยายามสร้างอุปกรณ์ ตรวจจับคลื่นอินฟราโซนิค (infrasonic) ที่สามารถตรวจจับได้เร็วขึ้น เพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้เร็วขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาคลื่นอินฟราโซนิค
2. เพื่อศึกษาเครื่องมือตรวจวัดคลื่นอินฟราโซนิค
3. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราโซนิค

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. เป็นการศึกษาคุณลักษณะของคลื่นอินฟราโซนิค
2. เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราโซนิค เพื่อการใช้งานตามรูปแบบงาน

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

รายละเอียด	ปี 2554							ปี 2555			
	ม.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย
1.รวมรวมข้อมูล	←	→									
2.ศึกษาและออกแบบการ ทำงานของเครื่องตรวจจับ อินฟราไซนซ์					←	→					
3.จัดทำอุปกรณ์และทำการ ทดลองเครื่องตรวจจับอิน ฟราไซนซ์					←	→					
4.จัดทำรายงานและสรุปผล การทดลอง								←	→		

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

1. เพื่อเป็นการพัฒนาอุปกรณ์เดือนกับ
2. เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้บางมีประสิทธิภาพ

1.6 งบประมาณในการดำเนินโครงการ

รายจ่าย 1. ค่าจัดทำเอกสาร	200	บาท
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน	1,500	บาท
3. ค่าจัดทำรูปเล่มโครงการ	200	บาท
4. อื่นๆ	100	บาท
รวม	2,000	บาท

หมายเหตุ : ขออนุญาตถัวเฉลี่ยทุกรายการ

รายรับ ค่าดำเนินการโครงการจากคณะ 2,000 บาท

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากแนวคิดของผู้จัดทำในการสร้าง ตัวตรวจจับคลื่น Infrasonic โดยใช้ในโทรศัพท์ WM-61A 4 ตัวเพื่อรับคลื่น Infrasonic ในช่วงความถี่ 0.1-20 Hz ผ่านวงจรกรองสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณและ Integrator เพื่อลด noise จากสัญญาณความถี่อื่นที่เข้ามา และนำคลื่นที่ได้จากเครื่องตรวจจับมาเปรียบเทียบและส่งไปปั๊มเครื่องรับสัญญาณเดือนกัยอื่นๆ เนื่องจากโครงงานนี้เป็นตัวตรวจจับคลื่นความถี่ต่ำ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวคลื่นสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงแรงดึงดูดโลก คลื่นความถี่ต่ำที่เกิดจากแผ่นดินไหวจะเคลื่อนที่ผ่านไปทั้งๆ ที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนผิวโลกยังปกติเหมือนเดิมรวมถึงพฤติกรรมสัญชาติญาณของสัตว์บางชนิดที่สามารถบอกได้ถึงหันตัวที่เข้ามาโดยไม่รู้ตัว จึงออกล่าวนหุญภัยพื้นฐานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

2.1 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

แผ่นดินไหว

นิยาม กัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพ แผ่นดินไหวจากธรรมชาติ



รูปที่ 2.1 แผ่นดินไหวที่ชานฟรานซิสโกเมื่อ พ.ศ. 2449



รูปที่ 2.2 ความเสียหายของอาคารจากแผ่นดินไหวที่โภเบ เมื่อ พ.ศ. 2538

แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรรมสีพิบัติกัยชนิดหนึ่ง ส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปัลคลปัลอยพลังงานเพื่อระบายน้ำความเครียด ที่สะสมไว้ภายในโลกอุกมาอย่างจับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเดือนภายในภายในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างของโลก มีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ อยู่เสมอ (คุณการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก) แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อความดันขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไป ภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อย ในบริเวณของเขตของแผ่นเปลือกโลก ที่ที่แบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็นธรรมภูภาค (lithosphere) เรียก แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณของเขตของแผ่นเปลือกโลกนี้ว่า แผ่นดินไหวระหว่างแผ่น (interplate earthquake) ซึ่งเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่า แผ่นดินไหวภายในแผ่น (intraplate earthquake)

แผ่นดินไหวจากการกระทำของมนุษย์

มีทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิด การทำเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนไถลร่อง เส้นทาง การทำงานของเครื่องจักรกล การจราจร รวมถึงการเก็บขยะนิวเคลียร์ไว้ได้ดิน เป็นต้น

- การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอาจพบปัญหาการเกิดแผ่นดินไหว เมื่อจากน้ำหนักของน้ำในเขื่อนกระตุ้นให้เกิดการปัลคลปัลอยพลังงาน ทำให้สภาวะความเครียดของแรงในบริเวณน้ำเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งทำให้แรงดันของน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดพลังงานด้านทานที่สะสมตัวในชั้นหิน เรียกแผ่นดินไหวลักษณะนี้ว่า แผ่นดินไหวท้องถิ่น ส่วนมากจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 5-10 กิโลเมตร ขนาดและความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะปกติ รายงานการเกิดแผ่นดินไหวในลักษณะเช่นนี้เกยบมีที่ เขื่อนสูญญาร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2488 แต่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย เขื่อนการนิบา ประเทศซินบัวเว เมื่อ พ.ศ. 2502 เขื่อนคริมสต้า ประเทศกรีซ เมื่อ พ.ศ. 2506 และครั้งที่มีความรุนแรงครั้งหนึ่งเกิดจากเขื่อนกอบน่า ในประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2508 ซึ่งมีขนาดถึง 6.5 ริกเตอร์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 180 คน
- การทำเหมืองในระดับลึก ซึ่งในการทำเหมืองจะมีการระเบิดหิน ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นได้
- การสูบน้ำใต้ดิน การสูบน้ำใต้ดินจำนวนมากมาใช้มากเกินไป รวมถึงการสูบน้ำหนักและแก๊สธรรมชาติ ซึ่งอาจทำให้ชั้นหินที่รองรับเกิดการเคลื่อนตัวได้
- การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ได้ดิน ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการทดลองระเบิด ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดผลกระทบต่อชั้นหินที่อยู่ใต้เปลือกโลกได้

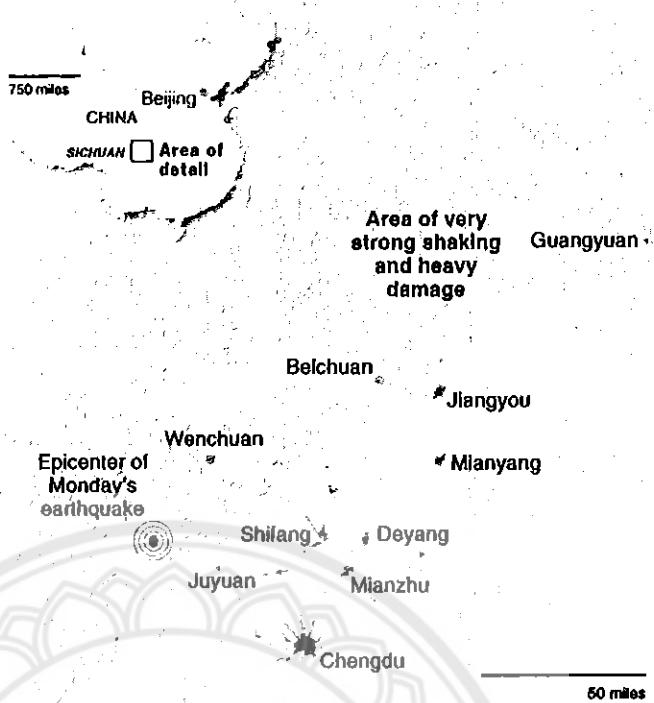
ສັງລູາມສົ່ນາມືໃນຂໍ້ມູນເສີຍງວມຄົ່ນຕໍ່ຕຳ

สัญญาณคลื่นแผ่นดินไหวความยาวพิเศษที่อาจเกิดขึ้นจากสีนามิจากสถานีชั่ยผิ่ง รวมถึงความเป็นไปได้ในการตรวจวัดสีนามิจากแผ่นดินถล่มใต้ทะเล อย่างไรก็ตาม การติดตามในระยะยาว (0.1 sps) จากสถานีมาตรฐานเครือข่ายแผ่นดินไหวทั่วโลก พบว่ามีหลักหลายปัญหานาในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ดังนั้นเราจึงหันมาด้านหาสัญญาณสีนามิจาก ข้อมูลเสียงความถี่ต่ำ เพราะคลื่นเสียงความถี่ต่ำเดินทางได้เร็วกว่าสีนามิ การสังเกตการณ์ ตรงนี้สามารถดำเนินการได้กับการตีอนกับสีนามิล่วงหน้าได้

ในการสังเกตการณ์คลื่นสีนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ณ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยข้อมูลแผ่นดินไหวจากเกาะ Ocean Island หรือตามสถานีชัยฟ์ร์ระยะทาง 80 กิโลเมตร คลื่นสีนามารถเห็นได้เมื่อ ส่วนประกอบแนวราบ (horizontal components) ของคลื่นอยู่ใน ความเวลาหากว่า 1000 วินาที ซึ่งคาดว่าเกิดจากความเรียงของพื้นผิวนานกว่าหนักของสีนามิ การ แผนที่ของระดับน้ำเหนือนอกุญย์กลางการสั่นสะเทือนสามารถทำให้เกิดคลื่น เสียงความถี่ต่ำที่ ความเวลาระหว่าง 300 ถึง 600 วินาที ซึ่งพบได้จากการเฝ้าสังเกตคลื่นความถี่ต่ำเหล่านี้รอบ มหาสมุทรอินเดีย เราจึงประสบความสำเร็จในการสังเกตสัญญาณเสียงความถี่ต่ำจากส่วนประกอบ แนวราบ ของคลื่นจากสถานีแผ่นดินไหว ความเร็วของคลื่นสีนามิในน้ำลึกอยู่ที่เกิน 260 เมตรต่อ วินาที ส่วนความเร็วของคลื่นเสียงความถี่ต่ำอยู่ที่เกิน 330 เมตรต่อวินาที เราคำนวณพิจารณาถึง ศักยภาพในการใช้ส่วนที่แตกต่างนี้ในการเตือนภัยสีนามิ ล่วงหน้า ผลลัพธ์ที่ได้ยืนยันถึงความ เป็นไปได้ในการใช้เครื่องข่ายแผ่นดินไหวทั่วโลกที่ มีอยู่แล้วในการเฝ้าสังเกตสีนามิและ สัญญาณเสียงความถี่ต่ำที่เกิดจากสีนามิ โดยตรง

พฤติกรรมของสัตว์ต่อการเกิดแผ่นดินไหว

ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 หนึ่งแผนค้าที่ศูนย์เพาะเลี้ยงแพนค้าวูลอง ณ ตลาดเสคอนวัน โกลด์เมืองเหลืองตุชชิ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว ก็เริ่มแสดงพฤติกรรมผิดปกติ “ที่แรกนั้นแพนค้าดูซึ้งกึ่งชา ไม่ได้แค่ค่านิดหน่อย” ได้แอน เอ็ทกินส์ นักห้องเที่ยวที่อยู่ที่วูลองพอดีเล่า “แล้วอยู่ดีๆ แพนค้าก็ถูกเดินวนไปมา อบกรองไม่ยอมหยุด เมื่อได้มองข้อนกลับไปคิดแล้ว สงสัยว่าแพนค้าคงต้องรู้แน่เลยว่ากำลังมีสิ่งผิดปกติก็เป็นข้อ”



รูปที่ 2.3 แสดงตำแหน่งแผ่นดินไหว

แผนด้า ตัวเต็มวัย 86 ตัวที่วุลอกนั้นปลดภัยคี ไม่ได้รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหว ส่วนถูกแผนด้านนั้นถูกขย้ำไปที่เมืองชาวัน ซึ่งปลดภัยกว่า รายงานของสัตว์ซึ่งแสดงพฤติกรรมผิดปกติ่อนเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นมีอยู่หลายครั้ง ครั้งล่าสุดที่มีพยานเห็นเหตุการณ์บันทึกอ้างว่า ครั้งเกิดชีวนิปปี พ.ศ. 2549 นั้น ช้างที่ແสนชาบฝัง ประเทศรีลังกาต่างก็หวีคร้อง แล้ววิ่งหนีขึ้นที่สูง ส่วนสัตว์ในสวนสัตว์ก็วิ่งกลับเข้าหอ กกในจังหวะก่อนที่คลื่นชีวนิจจะมาในครั้งนั้นมีผู้คนตายกว่า 150,000 คน ในขณะที่รายงานการตายของสัตว์นั้นมีน้อยมาก จึงทำให้หลายคนคิดว่าสัตว์อาจมีสัญชาติญาณรู้ล่วงหน้าอีกด้วย

สัตว์หลบ藏นั้นมีประสิทธิภาพสัมผัสที่ไวกว่าคนมาก เช่น ภูนี้สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของเหยือซึ่งอยู่ในโพรงหอยได้ดี ส่วนช้างนั้นก็สามารถสืบสารผ่านทางแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงความถี่ต่ำกว่าที่มนุษย์สามารถได้ยิน (infrasonic) ซึ่งคลื่นความถี่ต่ำนี้สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าความถี่สูง ช้างจึงสามารถสัมผัสและ “ได้ยิน” ถึงแรงสั่นสะเทือนของโขลงช้างที่อยู่ห่างออกไปถึง 32 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ดร. ไรส์ ก็เตือนว่าอย่าเพิ่งค่วนสรุปใดๆ จากพฤติกรรมผิดแปลกไปของแผนด้าครั้งนี้ “มันเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจ แต่หากอยากรู้ว่าแผนด้านนั้นตอบสนองต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจริงหรือ ไม่ เราต้องรู้พฤติกรรมตามปกติของแผนด้านมากกว่านี้” แต่ในความเป็นจริงก็มีคิดว่าแผนด้านนั้นเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์มีการจด พฤติกรรมในกรุงเดลีจะละเอียดมากที่สุดในโลกแล้ว หากยังดูไม่ออกอีก ก็แนบจะไม่ต้องห่วงเพิ่งสัตว์ป่าใดๆ แต่สัตว์เดลีซึ่งอยู่กับมนุษย์อย่างใกล้ชิดกว่า นั้นอาจมีโอกาสสัมผัสพฤติกรรมได้มากกว่า

หลักฐานครั้งแรกที่ปรากฏของสัตว์ซึ่งเตือนภัยแผ่นดินไหว คือเมื่อ พ.ศ. 170 หนู ง และพังพอน ต่างวิ่งหนีออกจากเมืองเฉลิม อาณาจักรกรีก เพียงไม่กี่วันก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ นอกจากนั้นในครั้งอื่นๆ ก็มีบันทึก เช่น ไก่เหยุดวงไว้ ผึ้งแตกหนีออกจากกรุง สุนัขแห่าหอน ไม่ยอมหยุด หรือแสดงอาการอุกคลื่นสูกคลอนแต่จริงๆ แล้วสัตว์นั้นรู้สึกสัมผัสสิ่งใด ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่า ก่อนเกิดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั้นนักจะมีการสั่นไหวอยู่ ก่อน ซึ่งสัตว์อาจสามารถสัมผัส รู้สึกได้ หรืออีกทฤษฎีกกล่าวว่าอาจสัมผัสได้ด้วยปฏิกริยาทางไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปในอากาศ หรืออาจที่ถูกปล่อยของจากไฟฟ้า แม้จะมีความพยายามในการศึกษาการใช้สัตว์เป็นตัวชี้วัดแผ่นดินไหวมา กามา แต่สุคหัตย์แล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุป แอนดี้ มิเชล นักธรณีฟิสิกซ์ ซึ่งได้ศึกษาเรื่องนี้คิดว่า “เรา ไม่ได้เพียงคำนวณเด่าล้ำลือ แต่สัตว์นั้นก็แสดงปฏิกริยาตอบสนองต่อคลื่นสิ่งเหลือเกิน ทั้งความทิ่ว การปักป้องถิ่นอาศัย การสืบพันธุ์ การถูกใจเล่า ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะศึกษาแบบควบคุมปัจจัย ต่างๆ ที่จะตรวจวัดถ่วงหนักก่อนเกิดแผ่นดินไหว”

นักธรณีวิทยาส่วนใหญ่จึงไม่เชื่อในคำร่ำลือถึงพฤติกรรมที่ผิดปกติของสัตว์ก่อน เกิดแผ่นดินไหว โดยกล่าวว่ามันเป็นผลของสภาพวัสดุที่เรามุ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังเกิดแผ่นดินไหว คนก็พยายามงดจำสิ่งต่างๆ ที่เกิดว่าเป็นลายสังหาร แต่หากไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ก็คงไม่มีใคร เอะใจว่าพฤติกรรมสัตว์เหล่านั้นผิดปกติ

คลื่นเสียง

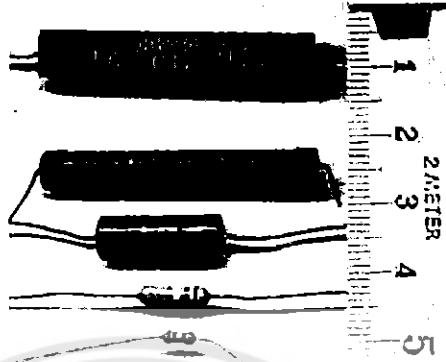
- คลื่นใต้เสียงหรือคลื่นอินฟราโซนิก (Infrasonic) เช่นคลื่นแผ่นดินไหว $f < 20 \text{ Hz}$ หูมนุษย์รับฟังไม่ได้ แต่รับรู้ได้
- คลื่นเสียง (Audible range) $20 \text{ Hz} < f < 20 \text{ kHz}$ หูมนุษย์รับฟังได้
- คลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic) $f > 20 \text{ kHz}$ หูมนุษย์รับฟังไม่ได้ แต่ สัตว์บางประเภทรับฟังได้

2.2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ตัวต้านทาน

ตัวต้านทาน หรือ รีซิสเตอร์ (อังกฤษ: resistor) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านิคสองขั้ว ที่สร้างความต่างศักย์ทางไฟฟ้าขึ้นก่อนขั้วทั้งสอง โดยมีสัดส่วนมากน้อยตามกระแสที่ไหลผ่าน อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ และปริมาณกระแสไฟฟ้า คือ ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า หรือค่าความต้านทาน หน่วยค่าความต้านทานไฟฟ้าตามระบบเอสไอ คือ โอห์ม อุปกรณ์ที่มีความต้านทาน

ค่า । โน๊ม หากมีความต่างศักย์ । โวลต์ไฟล์ห่าน จะให้กระแสไฟฟ้า । แอนเปอร์ ซึ่งเท่ากับการไฟล์ของประจุไฟฟ้า 1 คูลอนบ์ (ปริมาณ 6.241506×10^{18} elementary charge) ต่อวินาที ชนิดของตัวด้านท่าน



รูปที่ 2.4 ชนิดตัวด้านท่าน

ตัวด้านท่านชนิดต่าง ๆ

อาจจำแนกชนิดของตัวด้านท่านได้หลายวิธี อาทิ

- แบ่งตามความสามารถในการปรับค่า จำแนกได้ออกเป็น
 - ตัวด้านท่านที่มีค่าคงที่
 - ตัวด้านท่านแบบปรับค่าได้ (อาจจำแนกย่อยลงไปอีกว่า ปรับค่าได้โดยผู้ปรับ หรือ ปรับค่าได้ตามแสดงสว่าง อุณหภูมิ ฯลฯ)
- แบ่งตามชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ผลิตตัวด้านท่าน เช่น ตัวด้านท่านประเภทเซรามิก

ตัวด้านท่านแบบมีค่าคงที่

ตัวด้านท่านทั่วไปอาจมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก โดยที่มีสารตัวด้านทາโนอยู่ที่แกนกลาง หรือ เป็นพิล์มอยู่ที่ผิว และมีแกนโลหะตัวนำออกมายากไปทางทิ้งสองข้าง ตัวด้านท่านที่มีรูปร่างนี้ เรียกว่า ตัวด้านทานรูปร่างแบบ แยกเชือล คังในรูปค้านขวามือ ตัวด้านท่านใช้สำหรับกำลังสูงจะถูก ออกแบบให้มีรูปร่างที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี โดยมักจะเป็น ตัวด้านท่านแบบบคลวต ตัว ด้านท่านที่มักจะพับเห็นบนแผงวงจร เช่นคอมพิวเตอร์นั้น โดยปกติจะมีลักษณะเป็น ตัวด้านท่าน แบบประกอบผิวหน้า (surface-mount) ขนาดเล็ก และไม่มีขาโลหะตัวนำยื่นออกมา นอกจากนั้นตัว ด้านท่านอาจจะถูกรวมอยู่ภายใน อุปกรณ์วงจรรวม (IC - integrated circuit) โดยตัวด้านท่านจะถูก สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต และแต่ละ IC อาจมีตัวด้านท่านถึงหลาด้านตัวอยู่ภายใน

ตัวต้านทานปรับค่าได้

ตัวต้านทานปรับค่าได้ เป็นตัวต้านทาน ที่ค่าความต้านทานสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยอาจมีปุ่มสำหรับหมุน หรือ เลื่อน เพื่อปรับค่าความต้านทาน และบางครั้งก็เรียกว่า โพเทนติโอมิเตอร์ (potentiometers) หรือ รีโอสแตต (rheostats)

ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้มีพื้นแบบที่หมุนได้เพียงรอบเดียว จนถึง แบบที่หมุนแบบเป็นเกลียวได้หลายรอบ บางชนิดมีอุปกรณ์แสดงนับรอบที่หมุน เนื่องจากตัวต้านทานปรับค่าได้นี้ มีส่วนของโลหะที่ขัดสีสักครึ่ง บางครั้งจึงอาจขาดความนำเชื่อมดี ในตัวต้านทานปรับค่าได้รุ่นใหม่ จะใช้วัสดุซึ่งทำการผลิตโดยทันทันต่อการสักครึ่งจากการขัดสี และ กัดกร่อน

- รีโอสแตต (rheostat) : เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้มี 2 ขา โดยที่ขาหนึ่งถูกยึดตายตัว ส่วนขาที่เหลือเลื่อนไปมาได้ ปกติใช้สำหรับส่วนที่มีปริมาณกระแสสูง
- โพเทนติโอมิเตอร์ (potentiometer) : เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ ที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยเป็นปุ่มปรับความดัง สำหรับเครื่องขยายเสียง

ตัวต้านทานชนิดพิเศษอื่น ๆ

- วาไรสเตอร์โลหะออกไซด์ (metal oxide varistor-MOV) เป็นตัวต้านทานที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีค่าความต้านทาน 2 สถานะ คือ ค่าความต้านทานสูงมากที่ ความต่างศักย์ต่ำ (ต่ำกว่าค่าความต่างศักย์กระแสตื้น) และ ค่าความต้านทานต่ำมากที่ ความต่างศักย์สูง (สูงกว่าความต่างศักย์กระแสตื้น) ใช้ประโยชน์ในการป้องกันวงจร เช่น ใช้ในการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่าลงเสาไฟฟ้า หรือใช้เป็น สนับเบอร์ ในวงจรตัวเหนี่ยวนำ
- เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามระดับอุณหภูมิ แบ่งเป็นสองประเภท คือ
 - ตัวต้านทานที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นบวก (PTC - Positive Temperature Coefficient) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความต้านทานมีค่าสูงขึ้นตาม มีพนใช้ในวงจรเครื่องรับโทรศัพท์ โดยต่ออุปกรณ์กับ ชุดควบคุม สนามแม่เหล็ก (demagnetizing coil) เพื่อป้องกันกระแสในช่วงเวลาสั้น ๆ ให้กับชุดควบคุมขณะเปิดโทรศัพท์ นอกจากนั้นแล้ว ตัวต้านทานประเภทนี้ยังมีการออกแบบเฉพาะเพื่อใช้เป็น ฟิวส์ (fuse) ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เรียกว่า โพลีสวิตช์ (polyswitch)
 - ตัวต้านทานที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นลบ (NTC - Negative Temperature Coefficient) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าความต้านทานมีค่าลดลง ปกติใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ
- เซนเซอร์ (sensistor) เป็นตัวต้านทานที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ มีค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นลบ ใช้ในการชดเชยผลของการเปลี่ยนอุณหภูมิ ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

- แอลดีอาร์ (LDR : Light Dependent Resistor) ตัวด้านหน้าปรับค่าตามแสงทั้งหมด ยิ่งมีแสงทั้งหมดมากเท่าไร มีความด้านหน้าต่ำ
- ลวดตัวน้ำ ลวดตัวนำทุกชนิด ยกเว้น ชูปเปอร์คอนเดกเตอร์ (superconductor) จะมีความด้านหน้าซึ่งเกิดจากเนื้อวัสดุที่ใช้ทำลวดนั้น โดยจะขึ้นกับ ภาคตัดขวางของลวด และ ค่าความนำไฟฟ้าของเนื้อสาร

2.2.2 ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ (Capacitor) หรือ ตัว C เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าไว้ที่ตัวมันและคงประจุไฟฟ้าอອกรมา ตัวเก็บประจุ จะมีหน่วยเป็น F (ฟาร์ค) ซึ่งตัวเก็บประจุเองจะแบ่งชนิดออกเป็น ตัวเก็บประจุแบบมีขี้ว และ ตัวเก็บประจุแบบไม่มีขี้ว



ค่าประจำตัวของตัวเก็บประจุ

ค่าความจุ ตัวเก็บประจุจะมีค่าความจุซึ่งแตกต่างกัน ไป เช่น 10uF, 1uF เป็นต้น ซึ่งถ้าตัวเก็บประจุตัวใดมีค่าความจุมาก แสดงว่าตัวเก็บประจุนั้นสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากกว่านั้นเอง (การอ่านค่า และการแปลงหน่วยของตัวเก็บประจุสามารถอ่านได้ที่บ่อกความเรื่อง การอ่านค่า แปลงค่า R และ ตัว C)

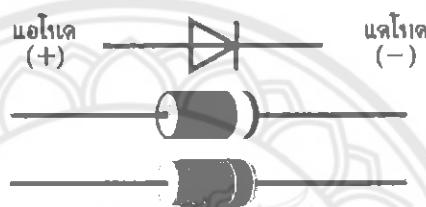
ค่าหน่วงดัน ตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะหน่วงดัน ได้จำกัด การใช้งานจะต้องดูค่าว่าตัวเก็บประจุนั้นสามารถหน่วงดัน ได้เท่าไร เช่น 10uF 16V และว่าตัวเก็บประจุตัวนี้สามารถใช้งานที่หน่วงดันได้ไม่เกิน 16V เป็นต้น



รูปที่ 2.6 ตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ

2.2.3 ไดโอด (diode)

ไดโอด (อังกฤษ: diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดสองข้าว ที่ออกแบบและควบคุมพิเศษ การไฟฟ้าในหลอดของประจุไฟฟ้า มันจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกันการไหลในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อถูกล่าว์ถึงไดโอด มักจะหมายถึงไดโอดที่ทำงานจากสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor diode) ซึ่งก็คือผลึกของสารกึ่งตัวนำที่ต่อ กันได้ขั้วทางไฟฟ้าสองข้าว ส่วนไดโอดแบบหลอดสูญญากาศ (Vacuum tube diode) ถูกใช้เฉพาะทางในเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงบางประเภท เป็นหลอดสูญญากาศที่ประกอบด้วยขั้วอิเล็กโทรดสองข้าว ซึ่งจะถูกแต่งตัวนำ (plate) และแคโทด (cathode)



รูปที่ 2.7 ไดโอดเทียบกับลักษณะของไดโอดแบบสารกึ่งตัวนำ

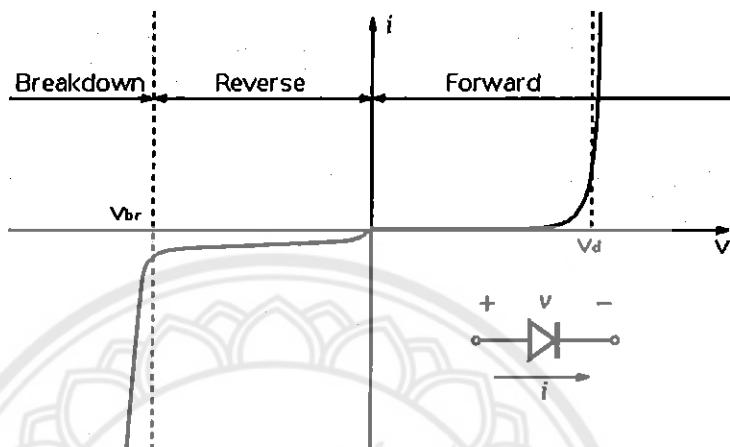


รูปที่ 2.8 ไดโอดชนิดต่างๆ

ส่วนใหญ่เราจะใช้ไดโอดในการขอนให้กระแสไฟฟ้าไปในทิศทางเดียว โดยขอนให้กระแสไฟฟ้าไหลในทางเดียวหนึ่ง ส่วนกระแสที่ไหลทิศทางตรงข้ามกันจะถูกกัน ดังนั้นจึงอาจถือว่าไดโอดเป็นวัสดุตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้เป็นเรียงกระแสไฟฟ้าในวงจรภาคจ่ายไฟ เป็นต้น

คุณลักษณะเฉพาะของกระแสและแรงดัน

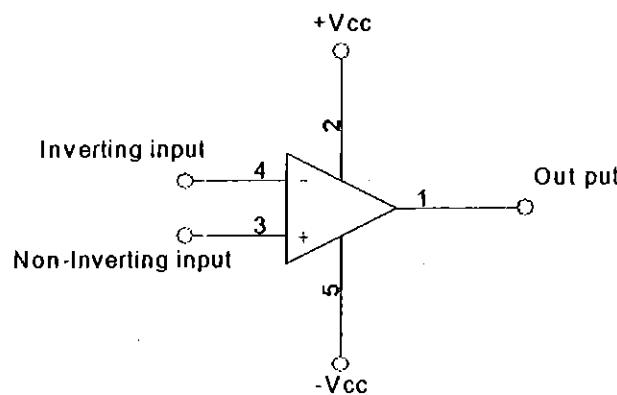
พฤติกรรมของไคโอดแบบสารกึ่งตัวนำในวงจรจะก่อให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะของกระแสและแรงดัน (current-voltage characteristic) หรือเรียกว่ากราฟ I-V (กราฟค้านล่าง) รูปร่างของเส้นโค้งถูกกำหนดจากส่วนประจุผ่านเขตปลดพาราห์ (depletion region หรือ depletion layer) ซึ่งอยู่ในรอยต่อ p-n



รูปที่ 2.9 กราฟคุณสมบัติเฉพาะของกระแสและแรงดันของรอยต่อ p-n ของไคโอด

2.2.4 ออปแอมป์ (Op-Amp)

ออปแอมป์ (Op-Amp) เป็นชื่อย่อสำหรับเรียกวิธีการขยายที่มีจาก Operating Amplifier เมื่อวงจรขยายแบบต่อตระกูล (Direct coupled amplifier) ที่มีอัตราการขยายสูงมากใช้การป้อนกลับแบบคงที่ควบคุมลักษณะการทำงาน ทำให้ผลการทำงานของวงจรไม่ขึ้นกับพารามิเตอร์ภายในของอปแอมป์ วงจรภายในประกอบด้วยวงจรขยายที่ต้องอนุกรมกัน ภาคคือ วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลด้านทางเข้า วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียลภาคที่สอง วงจรลีนารีดีบบ์และวงจรขยายกำลังด้านทางออก สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอปแอมป์จะเป็นรูปสามเหลี่ยม ไอซีอปแอมป์เป็นไอซีที่แตกต่างไปจากลิเนียร์ไอซีทั่วๆ ไปคือไอซีอปแอมป์มีขาอินพุท 2 ขา เรียกว่าขาเข้าไม่กัลบันเฟส (Non-Inverting Input) หรือ ขา + และขาเข้ากัลบันเฟส (Inverting Input) หรือขา - ส่วนทางค้านอ ก้มีเพียงขาเดียว เมื่อสัญญาณป้อนเข้าขาไม่กัลบันเฟสสัญญาณทางค้านออกจะมีเฟสตรงกับทางค้านเข้า แต่ถ้าป้อนสัญญาณเข้าที่ขาเข้ากัลบันเฟส สัญญาณทางออกจะมีเฟสต่างไป 180 องศา จากสัญญาณทางค้านเข้า



รูปที่ 2.10 แสดงสัญลักษณ์อปเปอเรนปี

คุณสมบัติของอปเปอเรนปีในทางอุดมคติ

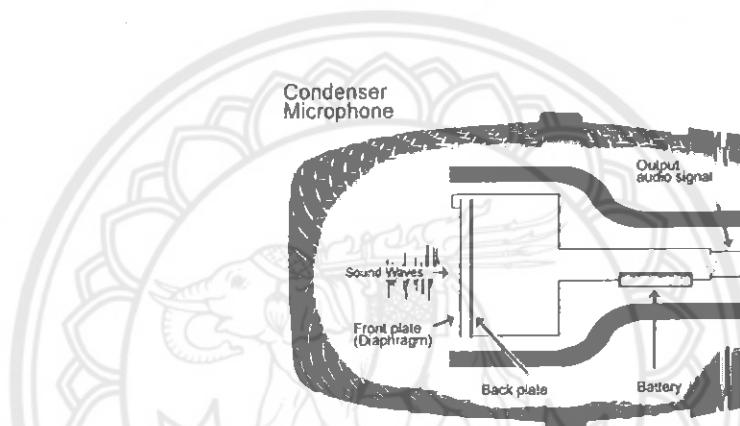
1. อัตราขยายมีค่าสูงมากเป็นอนันต์หรือ อนพินิต ($AV = \infty$)
2. อินพุทอิมพีเดนซ์มีค่าสูงมากเป็นอนันต์ ($Z_i = \infty$)
3. เอาท์พุทอิมพีเดนซ์มีค่าต่ำมากเท่ากับศูนย์ ($Z_o = 0$)
4. ความกว้างของแบบดิจิต (Bandwidth) ในการขยายสูงมาก ($BW = \infty$)
5. สามารถขยายสัญญาณได้ทั้งสัญญาณ AC และ DC
6. การทำงานไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ

เมื่อศึกษาคุณสมบัติของอปเปอเรนปีในอุดมคติแล้วพบว่า อปเปอเรนปีได้รวมข้อดีของวงจรขยายไว้ได้อย่างครบถ้วน เมื่อจากมีอัตราขยายเป็นอนันต์และสามารถขยายสัญญาณได้ทั้งไฟกระแสสลับและไฟกระแสตรง การนำไปใช้งานในบางครั้งเมื่อต้องการลดอัตราการขยายก็สามารถทำได้โดยการป้อนกลับ (Feed Back) เพื่อมาลดอัตราการขยายลง และข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือ อิมพีเดนซ์ทางอินพุทมีอิมพีเดนซ์สูงมาก จึงทำให้เหมือนไม่มีกระแสอินพุท ให้ผลลัพธ์จะเป็นเช่นนี้ จึงทำให้วงจรทางอินพุทไม่โwall คงจะส่งกำลังในส่วนหน้า เช่นเดียวกันที่เอาท์พุทมีอิมพีเดนซ์เป็นศูนย์สามารถนำไปเชื่อมต่อกับวงจรอื่นได้

2.2.5 คอนเดนเซอร์ไมค์ (Condenser Microphones)

หลักการทำงานใช้ไดอะแฟร์ม (diaphragm) เป็นตัวรับเสียงเหมือนเดิมซึ่งมักทำจากแผ่นพลาสติกเคลือบทองบีดติดอยู่เหนือ blank plate (ทำจากเซรามิกเคลือบทอง) ซึ่งทำให้มีช่องว่างเล็กๆ เพื่อการเคลื่อนตัวไปมาซึ่งการเคลื่อนตัวที่ว่านี้จะทำให้แผ่นไดอะแฟร์ม (diaphragm) เคลื่อนที่เข้าหาก blank plate แตะกันทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปมาได้ด้วยไฟฟ้าที่มาจากการแหล่งกำเนิดที่เรียกว่าเฟนทอม (phantom) โดยผ่านตัวเก็บประจุ (capacitor) ซึ่งจะมีขั้นวนและลบอยู่ โดยขั้นวนและลบจะถูกต่อไว้ที่ไดอะแฟร์ม (diaphragm)

คนละแผ่น



รูปที่ 2.11 Condenser Microphone

ดังนั้นทุกครั้งที่ไดอะแฟร์ม (diaphragm) เคลื่อนที่เข้าหากันประจุไฟฟ้าก็จะถูกเหนี่ยวนำ และมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแรงของเสียงที่มากระทบไดอะแฟร์ม (diaphragm) นั่นเอง หากแรงมากไดอะแฟร์ม (diaphragm) ก็แตกกันนานขึ้นกระแสไฟฟ้าก็ไหลได้มากขึ้นตรงข้ามหากแตะกันเร็วๆ ให้ได้น้อยลงผลของการไหลนี้เองจะถูกส่งผ่านไปยังปรีแอมป์ (pre-amp) เพื่อขยายให้แรงพอที่จะป้อนเข้าสู่มิกเซอร์

เนื่องมาจากคอนเดนเซอร์ไมค์ใช้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยและต้องใช้ไฟมานเลี้ยงซึ่งมีตั้งแต่ 1.5 ไปจนถึง 48 โวลต์ (volts) ดังนั้นความไวต่อการรับเสียงซึ่งสูงมากและสามารถตอบสนองต่อเสียงได้รับรื่นคลอดย่านความถี่อีกด้วยจึงเหมาะสมสำหรับการบันทึกสัญญาณต่างๆ เช่น เสียงร้อง เครื่องดนตรีแบบออคูสติกหรือขับสัญญาณเสียงที่ไม่ดังมาก แต่ไม่เหมาะสมกับการบันทึกสัญญาณที่แรงมาก เช่นเสียงจากตู้แอมป์ตาร์ ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อไดอะแฟร์ม (diaphragm) ได้จ่าย

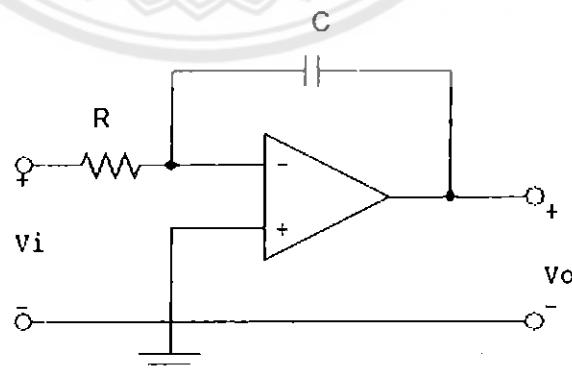
Microphone ไม่ว่าจะเป็น Dynamic หรือ Condenser จะมีทิศทางการรับเสียงอยู่หลายแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบตามความต้องการในการใช้งาน ทิศทางการรับเสียงหรือ Directional Pattern หรือเรียกว่า Polar Pattern จะมีอยู่หลักๆ 3 แบบคือ Omnidirectional ที่สามารถรับเสียงจากทุกทิศทางรอบ Microphone ได้ดังเท่ากันหมด Unidirectional จะรับเสียงจากด้านหน้าของ Microphone ได้ดังที่สุดส่วนเสียงที่อยู่ด้านข้าง Microphone จะเบาลง Bidirectional จะรับเสียงได้ดังที่สุดที่ด้านหน้าและด้านหลังของ Microphone และ Unidirectional ข้างแบ่งได้อีกเป็น Cardioid Supercardioid และ Hypercardioid

Proximity Effect เป็นผลที่เกิดกับ Microphone ที่มี Pattern แบบ Unidirectional และ Bidirectional โดยที่ Microphone จะมีเสียงความถี่ต่ำลงมากขึ้นเมื่อ Microphone เข้าใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากๆ Microphone บางตัวจะออกแบบให้มีปั๊ม Roll-Off เพื่อลด Proximity Effect ผลที่เกิดขึ้นจาก Proximity Effect อาจนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มเสียงความถี่ต่ำด้วยการตั้ง Microphone ให้ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียง

2.3 วงจรพื้นฐาน

2.3.1 วงจรขยายแบบอินทิเกรต (Ideal Integrating Amplifier)

สัญญาณเอาท์พุตของวงจรอินทิเกรต (Integrator) จะขึ้นอยู่กับการอินทิเกรต (Integral) บนเวลาของสัญญาณอินพุต ซึ่งจะมีค่าคงตัวเวลาของอาร์ซี (RC Time Constant) ของวงจรจะกำหนดฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) ของวงจรอินทิเกรต ดังรูป 2.12



รูปที่ 2.12 วงจรขยายแบบอินทิเกรต

ความสัมพันธ์ของวงจร

จาก

$$i_R = i_c \quad (2-1)$$

$$i_R = \frac{V_i}{R} \quad (2-2)$$

$$i_c = C \frac{dV_c}{dt} = -C \frac{dV_o}{dt} \quad (2-3)$$

แทนค่าสมการ (2-3) ลงในสมการ (2-2) เราจะได้

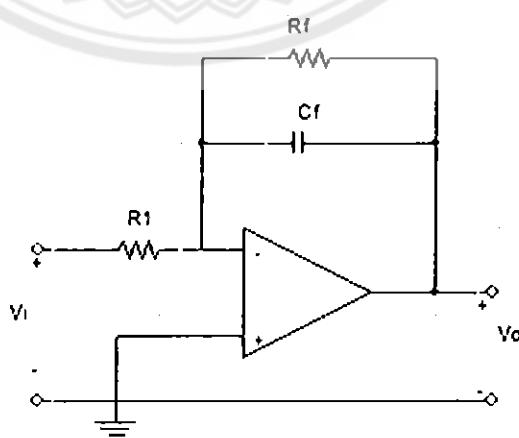
$$\frac{V_i}{R} = -C \frac{dV_o}{dt} \quad (2-4)$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_i dt \quad (2-5)$$

2.3.2 วงจรอินทิเกรเตอร์ (Practical Integrator circuit)

Op-Amp Integrator circuit คือวงจรใช้ IC อยู่ปัจจุบัน สร้างเป็นวงจร Integrator สัญญาณ แรงดันอินพุตที่เข้ามา สมการของแรงดันขาออกจะเป็นไปตามสมการของการ Integrator สัญญาณ แรงดันขาเข้า

ความสัมพันธ์ของความถี่สัญญาณขาเข้ากับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออก เช่นกันจึงต้องใช้ R_f ต่อกันกับ C_f เพื่อจำกัด (Low Frequency Resistor) เมื่อความถี่เปลี่ยนแปลง การทำงาน ถ้า $f_b > f_a$ วงจรทำงานเป็น Integrator และ ถ้า $f_b < f_a$ วงจรทำงานเป็น Inverting Amp



รูปที่ 2.13 วงจรอินทิเกรเตอร์

f_b คือความถี่ที่มีอัตราขยายเป็น 0 dB หาได้จาก

$$f_b = \frac{1}{2\pi R_1 C_f} \quad (2-6)$$

คำนวณความถี่คัดออก

$$f_a = \frac{1}{2\pi R_f C_f} \quad (2-7)$$

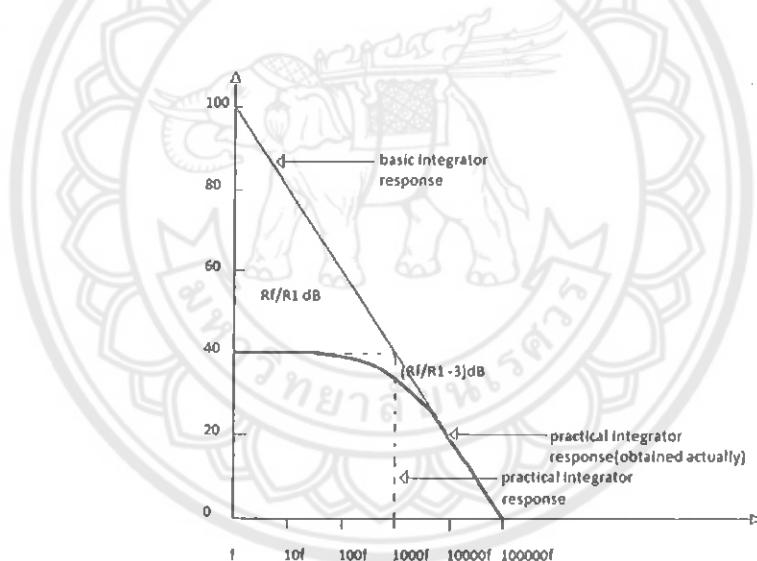
คำนวณอัตราขยาย

$$Av(\max) = \frac{R_f}{R_1} \quad (2-8)$$

ค่าความเวลาของสัญญาณเข้า

$$T \geq R_f C_f \quad (2-9)$$

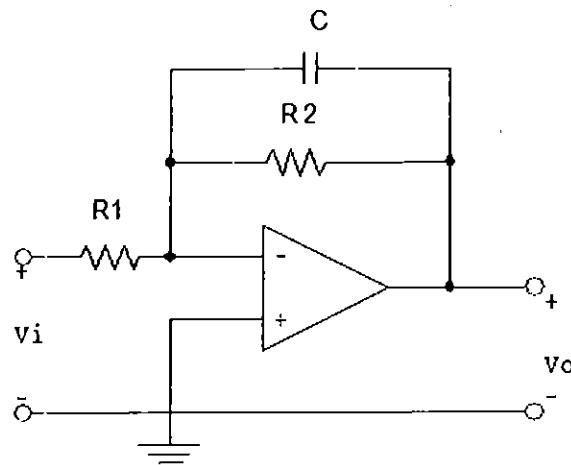
Frequency response



รูปที่ 2.14 ผลตอบสนองของวงจร Integrator

2.3.3 วงจรกรองความถี่ต่ำ (Low Pass Filter)

ในการใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์บางครั้ง เราต้องการให้สัญญาณบางความถี่ผ่านเข้าไปได้เท่านั้น โดยที่สัญญาณซึ่งมีความถี่น้อยกว่าจากนั้นจะถูกกำจัดออกไป ในวงจรกรองความถี่ต่ำนี้จะไม่ให้สัญญาณที่ความถี่สูงๆ ผ่านไปได้ ซึ่งจะเป็นคังรูป 2.15



รูปที่ 2.15 ลักษณะของวงจรกรองความถี่ต่ำ

สามารถหาอัตรายาของวงจรได้จาก

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2/R_1}{1+j\omega R_2 C} \quad (2-10)$$

แต่ค่าที่ได้บังเป็นจำนวนเชิงซ้อน ต้องทำการใส่ค่าสัมบูรณ์ให้กับ A_v

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + (\omega R_2 C)^2}} \quad (2-11)$$

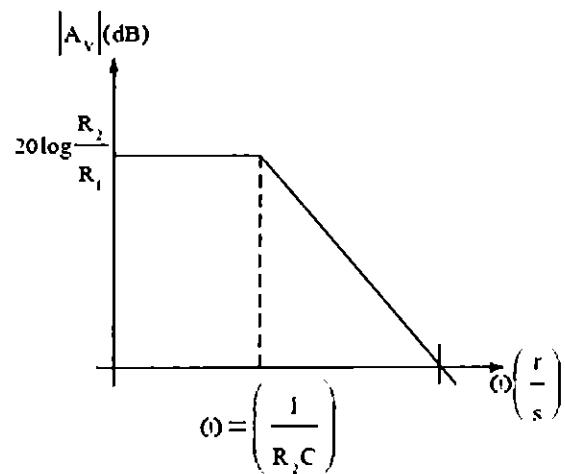
พิจารณาที่ความถี่ต่ำมาก ๆ จะได้ $R_2 C \omega \ll 1$ ดังนั้นสมการ (2-6) จะเป็น

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+0}} = \frac{R_2}{R_1} \quad (2-12)$$

พิจารณาที่ความถี่สูงมาก ๆ จะได้ $R_2 C \omega \gg 1$ ดังนั้นสมการ (2-6) จะเป็น

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\omega R_2 C} = \frac{1}{\omega R_1 C} \quad (2-13)$$

สามารถนำไปเขียนกราฟได้ โดยความถี่ต่ำ กราฟจะมีความชันเป็น 0 ส่วนความถี่สูงจะมีความชันเท่ากับ -20 dB/decade (อัตราขยายลดลง 20 dB ต่อความถี่ที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า) และเส้นทั้งสองตัดกันที่จุด $\omega = \frac{1}{R_2 C}$ และสามารถนำไปเขียนกราฟได้ดังรูป 2.16

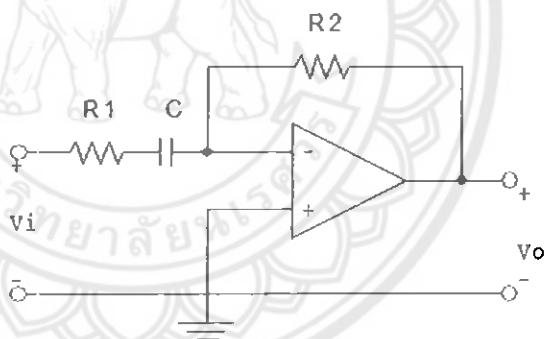


รูปที่ 2.16 กราฟของการกรองความถี่ต่ำ

2.3.4 วงจรกรองความถี่สูง (High Pass Filter)

วงจรกรองความถี่สูง เป็นวงจรที่กรองไม่ให้ความถี่ต่ำ ๆ ผ่านไปได้ ลักษณะของวงจรเป็น

ดังรูป 2.17



รูปที่ 2.17 ลักษณะของวงจรกรองความถี่สูง

หาอัตราบาขของวงจร ได้จาก

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2/R_1}{1+j/\omega R_1 C} \quad (2-14)$$

แต่ค่าที่ได้ ยังเป็นจำนวนเชิงซ้อน ต้องทำการใส่ค่าสัมบูรณ์ให้กับ A_v

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1 + (1/\omega R_1 C)^2}} \quad (2-15)$$

พิจารณาที่ความถี่ต่ำมาก ๆ จะได้ $R_2 C \omega \ll 1$ ดังนั้นสมการ (2-15) จะเป็น

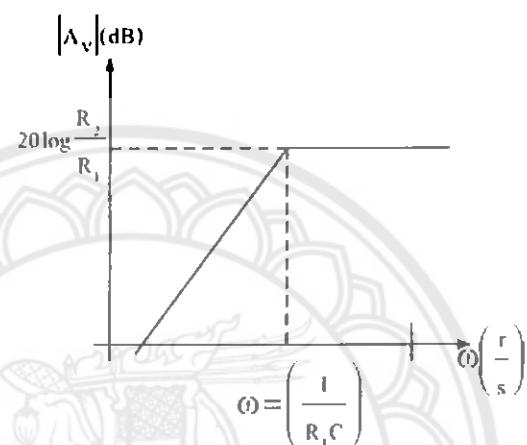
$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+0}} = \frac{R_2}{R_1} \quad (2-16)$$

พิจณาที่ความถี่สูงมาก ๆ จะได้ $R_2 C \omega \gg 1$ ดังนั้นสมการ (2-15) จะเป็น

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{1/\omega R_1 C} = \omega R_2 C \quad (2-17)$$

สามารถนำໄไปเขียนกราฟได้ โดยความถี่ต่ำ กราฟจะมีความชันเป็น $+20 \text{ dB/decade}$ ส่วน

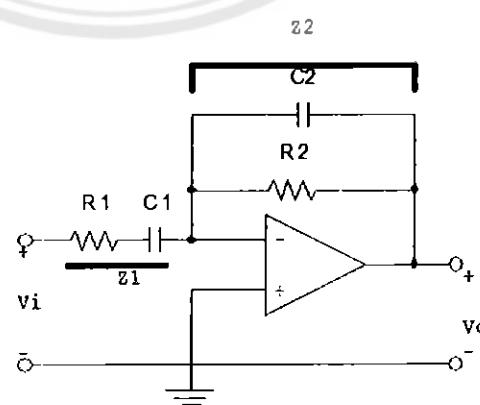
ความถี่สูงจะมีความชันเท่ากับ 0 และเส้นทั้งสองตัดกันที่จุด $\omega = \frac{1}{R_1 C}$ และสามารถนำไปเขียนกราฟได้ดังรูป 2.18



รูปที่ 2.18 กราฟของการกรองความถี่สูง

2.3.5 วงจรกรองความถี่เป็นช่วง (Band Pass Filter)

เป็นวงจรที่ยอมให้บางความถี่ผ่านไปได้เท่านั้น ซึ่งรวมทั้งวงจรกรองความถี่ต่ำและกรองความถี่สูงเข้าไว้ด้วยกัน มีลักษณะการต่อวงจรดังรูป 2.19



รูปที่ 2.19 ลักษณะของวงจรกรองความถี่เป็นช่วง

$$\text{โดยที่ } Z_1 = R_1 - \frac{j}{\omega C_1} \quad (2-18)$$

$$Z_1 = \frac{R_2}{1+j\omega R_2 C_2} \quad (2-19)$$

อัตราขยายของวงจรเป็น

$$A_v = \frac{-Z_2}{Z_1} \quad (2-20)$$

$$= \frac{-R_2/R_1}{(1+j\omega R_2 C_2)(1+\frac{j}{\omega C_1 R_1})} \quad (2-21)$$

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+(\omega R_2 C_2)^2} \times \sqrt{1+(\frac{1}{\omega C_1 R_1})^2}} \quad (2-22)$$

พิจารณาช่วงเป็นสามช่วง คือ ช่วงความถี่ระหว่าง ω_L และ ω_H , ช่วงความถี่สูง $\omega > \omega_H$

และช่วงความถี่ต่ำ $\omega < \omega_L$

ช่วงความถี่ระหว่าง ω_L และ ω_H (Mid-Frequency Range)

จะได้ $\omega R_2 C_2 \gg 1$ และ $(1/\omega R_1 C_1) \ll 1$ จะได้อัตราขยายเป็น

$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+0} \times \sqrt{1+0}} = \frac{R_2}{R_1} \quad (2-23)$$

ช่วงความถี่สูง $\omega > \omega_H$

จะได้ $(1/\omega R_1 C_1) \ll 1$ แต่ $\omega R_2 C_2$ จะได้เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง

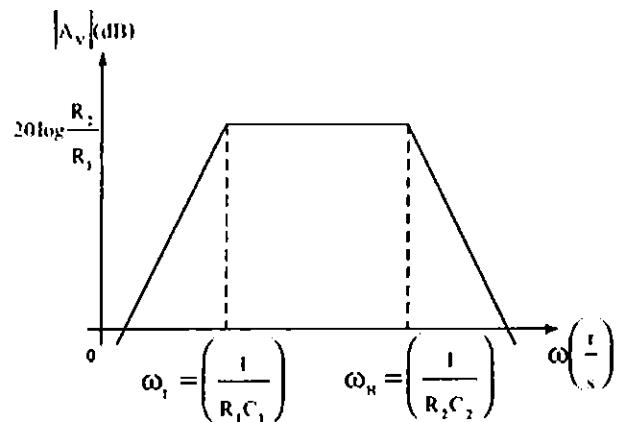
$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+(\omega R_2 C_2)^2} \times \sqrt{1+0}} = \frac{1}{\omega R_1 C_2} \quad (2-24)$$

ช่วงความถี่ต่ำ $\omega < \omega_L$

จะได้ $\omega R_2 C_2 \gg 1$ แต่ $(1/\omega R_1 C_1)$ เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่ง

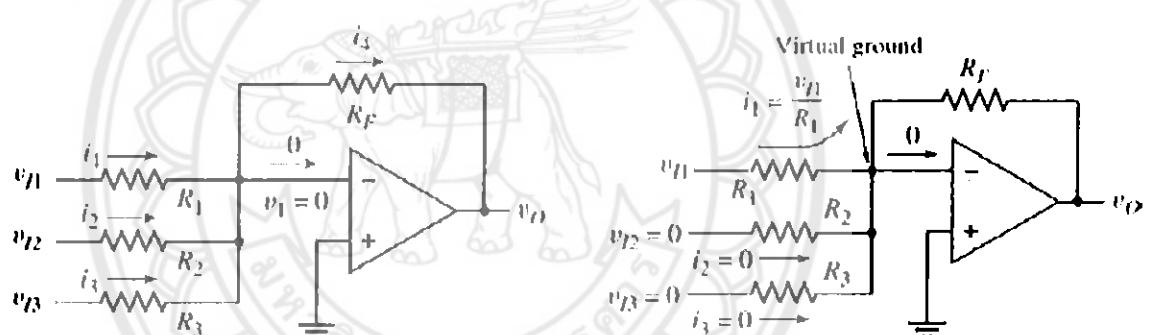
$$|A_v| = \frac{R_2/R_1}{\sqrt{1+0} \times \sqrt{1+(\frac{1}{\omega C_1 R_1})^2}} = \omega R_2 C_1 \quad (2-25)$$

เมื่อได้ความถี่ทั้งสามช่วง สามารถนำไปเขียนกราฟได้ดังรูป 2.20



รูปที่ 2.20 กราฟของการกรองความถี่เป็นช่วง

2.3.6 วงจรขยายแบบรวมสัญญาณ (Summing Amplifier)



รูปที่ 2.21 วงจรวัตสัญญาณโดยใช้อปีแอมป์

พิจารณา op-amp เป็น ideal ดังนั้นค่าความต้านทานขาเข้ามีค่าใกล้อนันต์เป็นเหตุให้พิจารณาว่ากระแสที่ไหลเข้า op-amp นั้นเป็นศูนย์ ดังนั้นกระแสที่เกิดจากแหล่งจ่าย V_{I1} , V_{I2} , V_{I3} นั้นผ่านไปยัง R_4 ทั้งหมด

$$i_4 = i_1 + i_2 + i_3 = \frac{V_{I1}}{R_1} + \frac{V_{I2}}{R_2} + \frac{V_{I3}}{R_3} \quad (2-26)$$

แรงดันขาออก

$$V_o = -R_F i_4 = -R_F \left(\frac{V_{I1}}{R_1} + \frac{V_{I2}}{R_2} + \frac{V_{I3}}{R_3} \right) \quad (2-27)$$

หากให้ค่าความต้านทาน $R_1 = R_2 = R_3 = R$ ดังนั้น

$$V_o = -R_F i_4 = -\frac{R_F}{R} (V_{I1} + V_{I2} + V_{I3}) \quad (2-28)$$

ซึ่งเห็นได้ว่าแรงดันขาออกนี้เป็นผลรวมของแรงดันขาเข้าที่มีอัตราขยายและกลับเฟส จึงเรียกว่า “วงจรขยายรวมสัญญาณแบบกลับเฟส” การประยุกต์การใช้งานของวงจรนี้ก็คือนำไปใช้ในการรวมสัญญาณที่เป็นแอนะล็อก



บทที่ 3

วิธีการออกแบบการทดลอง

หลังจากการศึกษาทฤษฎีและหลักการที่นำมาใช้กับโครงงานนี้ จากบทที่ผ่านมาสามารถนำ การประยุกต์ของหลักการดังกล่าวมาสร้างเป็นโครงงานที่สามารถใช้งานได้จริง

การดำเนินการของโครงงานนี้วางแผนไว้โดยรวม ออกแบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ภาค จ่ายไฟ (power supply) ให้กับส่วนหลักของวงจร โดยอาศัยการทำงานของไอซีแอลพี 2951 ทำงานร่วมกับไอซี 7660 สร้างแรงดันไฟฟ้า +7,+2 และ -7 โวลต์ ต่อมาร่วมกับที่สอง เป็นภาคของวงจรหลัก ทำการตรวจจับสัญญาณอินฟราโซนิก (infrasonic) เข้าทางไมโครโฟนจากนั้นผ่านตัวกรองความถี่ต่ำ (low-pass filter) โดยอาศัยการทำงานของไอซีแอลพี 1014 จากนั้นก็ขยายสัญญาณที่ได้โดยใช้ DIP Switcher

การวัดความถี่ต่ำในระดับ 0.1Hz-20Hz นั้นจำเป็นต้องสร้างเครื่องขยายเสียงให้ตอบสนองตามความถี่ที่เราใช้งานโดยใช้ไอซีเบอร์ TDA7294 สองตัวมาต่อแบบ Bridge ซึ่งให้กำลังวัตต์ถึง 150 วัตต์

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 เครื่องตรวจจับคลื่นอินฟราโซนิก

1. ไอซีทีแอลพีเบอร์ 1014	1 ตัว
2. ไอซีทีแอลเบอร์ 1355	1 ตัว
3. ไอซีทีพีเบอร์ 2951	1 ตัว
4. ไอซีทีแอลเบอร์ 7660	1 ตัว
5. ไคโอดเอนเบอร์ IN5819	1 ตัว
6. DIP Switcher	1 ตัว
7. ตัวต้านทาน ขนาด 3.3 กิโลโอห์ม	4 ตัว
ขนาด 330 กิโลโอห์ม	5 ตัว
ขนาด 5.1 กิโลโอห์ม	7 ตัว
ขนาด 82 กิโลโอห์ม	5 ตัว
ขนาด 1 เมกกะโอห์ม	6 ตัว
ขนาด 20.5 กิโลโอห์ม	1 ตัว

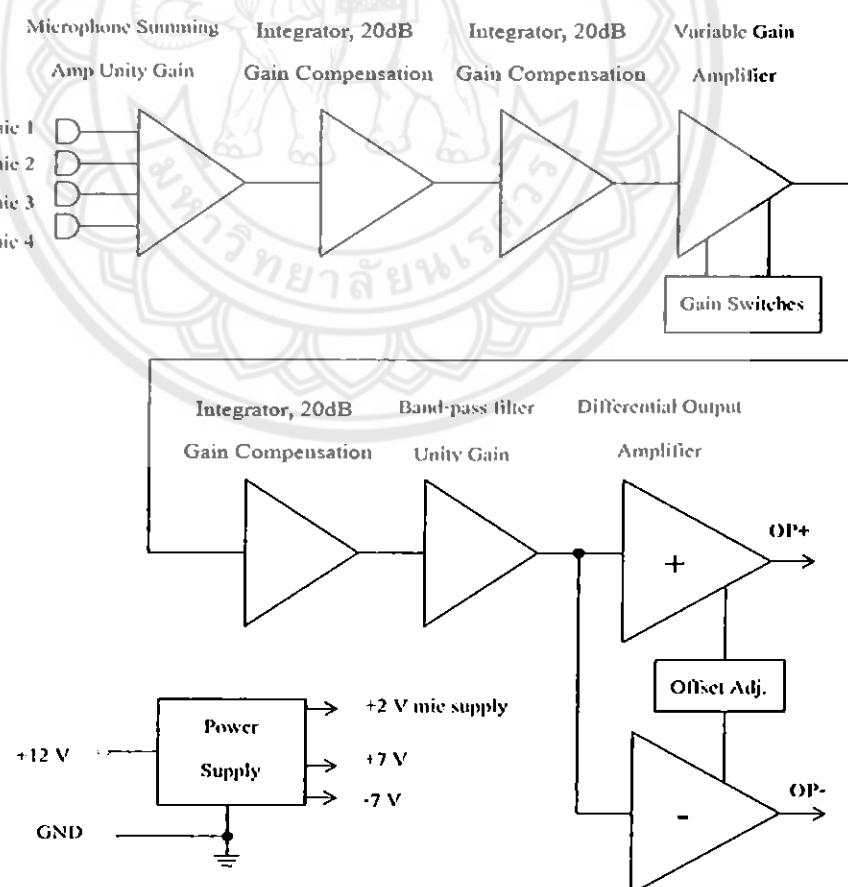
ขนาด 324 กิโลโ庾์	1 ตัว
ขนาด 5 กิโลโ庾์	1 ตัว
ขนาด 10 กิโลโ庾์	5 ตัว
ขนาด 510 กิโลโ庾์	1 ตัว
ขนาด 150 โอย์	2 ตัว
ขนาด 22 กิโลโ庾์	1 ตัว
ขนาด 100 กิโลโ庾์	1 ตัว
ขนาด 47 กิโลโ庾์	1 ตัว
8. ตัวเก็บประจุ ขนาด 10 ไมโครฟาร์ด	9 ตัว
ขนาด 6.8 นาโนฟาร์ด	1 ตัว
ขนาด 3.3 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
ขนาด 2.2 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
ขนาด 0.1 ไมโครฟาร์ด	6 ตัว
ขนาด 10 นาโนฟาร์ด	4 ตัว
9. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 100 กิโลโ庾์	1 ตัว
10. ไคโอดีบอร์ P6KE7V5A	2 ตัว
11. ไคโอดีบอร์ P6KE20(C)A	1 ตัว
12. Electret Condenser Microphone เบอร์ KECG2742PBL-A	4 ตัว
13. หน้อแปลง 12 โวลต์ 500-800mA	1 ตัว
14. สายสแตอริโอ	
15. สายไฟเส้นเล็ก	
16. หัวแร้งบัดกรีและตะกั่วเชื่อม	
17. กัตเตอร์	
18. คิมปลอกสายไฟ	

3.1.2 เครื่องขยายเสียงความถี่ 0.07Hz-100kHz

1. ไอซีบอร์ TDA7294	2 ตัว
2. ไอซีบอร์ LM7805	1 ตัว
3. ไอซีบอร์ LM7905	1 ตัว
4. หน้อแปลง 24 โวลต์ 1 A	1 ตัว
5. ตัวต้านทาน ขนาด 22 กิโลโ庾์	5 ตัว
ขนาด 680 โอย์	2 ตัว

ขนาด 20 กิโลโอล์ติม	1 ตัว
ขนาด 10 กิโลโอล์ติม	1 ตัว
ขนาด 30 กิโลโอล์ติม	1 ตัว
ขนาด 22 กิโลโอล์ติม	1 ตัว
6. ตัวเก็บประจุ ขนาด 0.22 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
ขนาด 2200 ไมโครฟาร์ด	6 ตัว
ขนาด 22 ไมโครฟาร์ด	6 ตัว
ขนาด 100 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
ขนาด 0.1 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
ขนาด 0.022 ไมโครฟาร์ด	2 ตัว
7. ไคโอดิเบอร์ร์ IN4002	8 ตัว
8. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 5 กิโลโอล์ติม	2 ตัว

3.2 หลักการทำงานทั่วไป

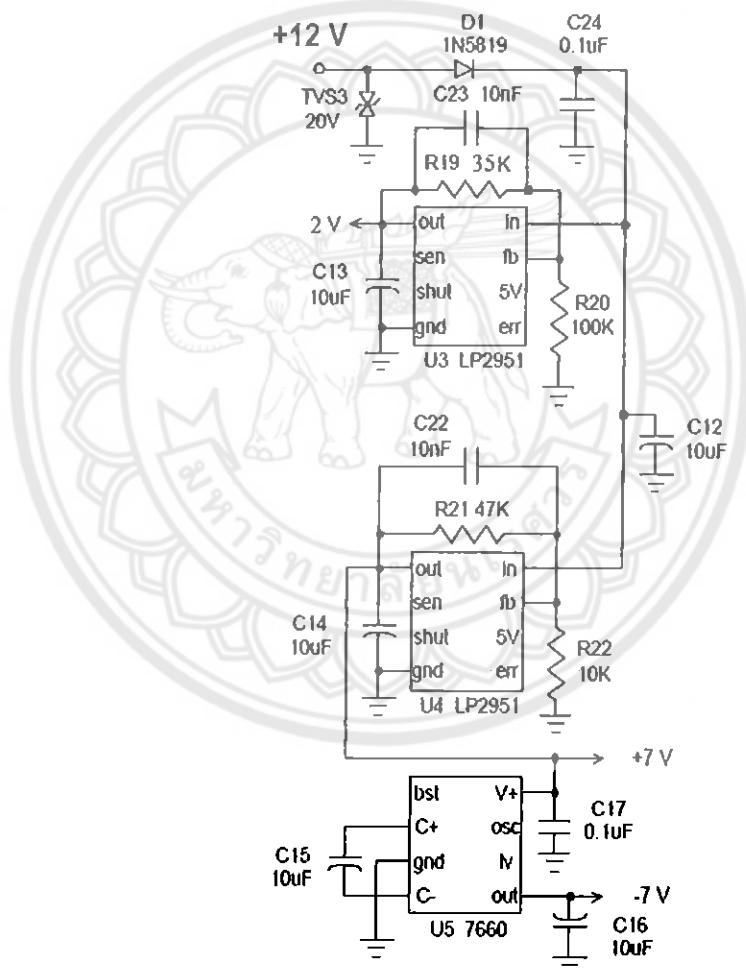


รูปที่ 3.1 Block Diagram แสดงหลักการทำงานทั่วไป

รูปที่ 3.1 เป็น Block Diagram แสดงให้เห็นการทำงานของอุปกรณ์โดยรวม มี Power supply สร้างแรงดันไฟเพื่อต่อไฟเลี้ยงให้กับอุปกรณ์ ส่วนในภาคของเครื่อง Infrasonic detector ใช้การรับสัญญาณจากอิเล็กตรโคลอนเดนเซอร์ใน โทรศัพท์ (electret condenser microphones) จากนั้นรวมสัญญาณด้วยวงจร Summing โดยกรองความถี่ให้อยู่ในช่วง 0.1-20 Hz ผ่านวงจรอินทิเกรเตอร์ (Integrator circuit) เพื่อชดเชยการตอบสนองความถี่ที่ต่ำลงของไมค์โทรศัพท์ จากนั้นเข้าภาคขยายสัญญาณแล้วได้สัญญาณออกมาน้ำที่ Output โดยที่ OP+ คือสัญญาณทางบวก OP- คือสัญญาณทางลบ

3.3 วิธีการออกแบบ

3.3.1 วงจรภาคจ่ายไฟ (power supply)

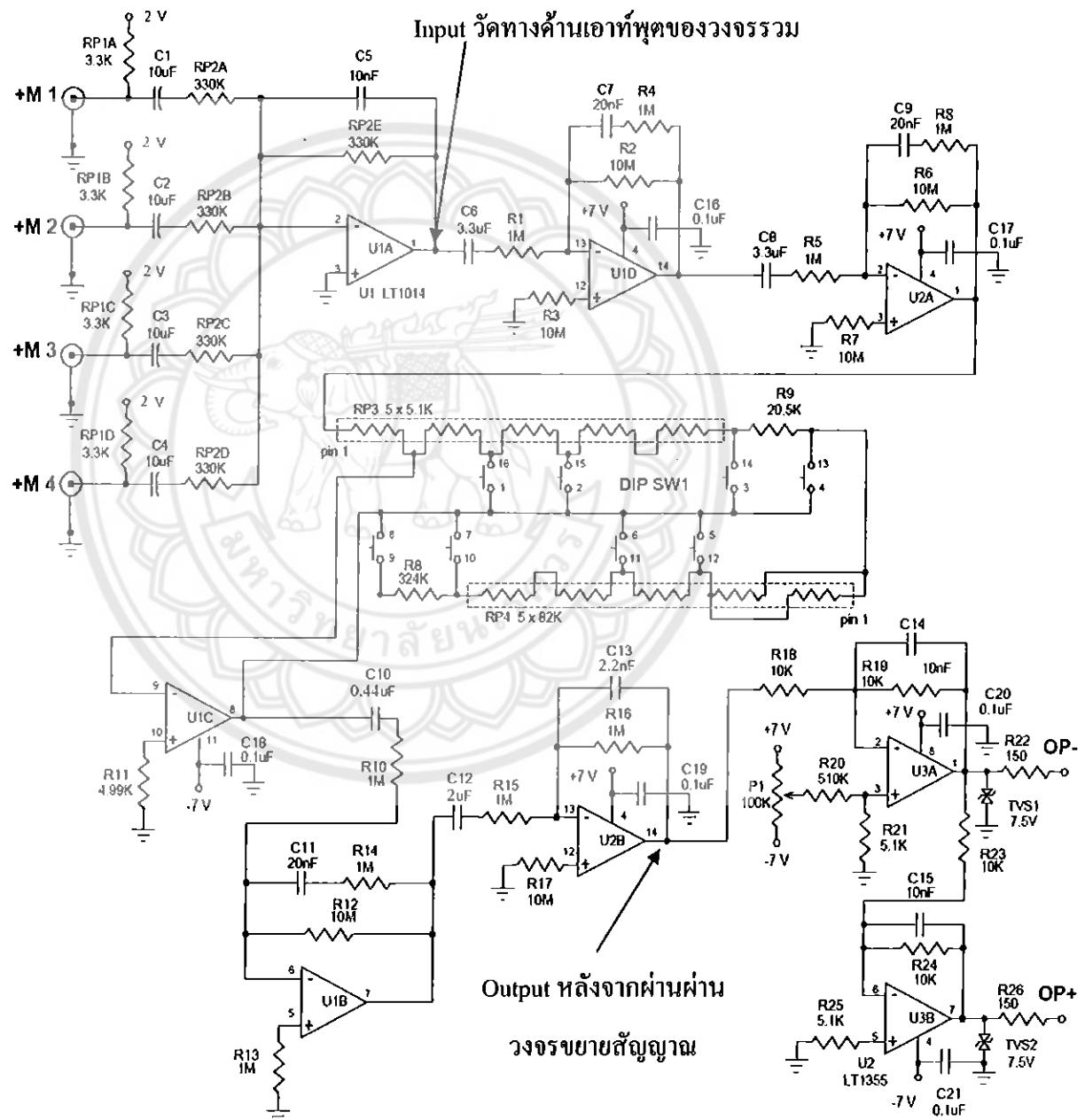


รูปที่ 3.2 วงจรภาคจ่ายไฟ (power supply)

จากรูปที่ 3.2 ข้างต้นเป็นการแสดงวงจรภาคจ่ายไฟ (power supply) ให้กับส่วนหลัก โดยอาศัยการทำงานของไอซีแอลพี 2951 ทำงานร่วมกับไอซี 7660 โดยป้อนแรงดัน +12 โวลต์ ให้กับ ไอซีแอลพี 2951 สามารถกำหนดค่าแรงดันเอาต์พุตได้จากตัวด้านหน้าที่นำมาต่อ กับ ไอซีแอลพี

2951 ส่วนไดโอดใช้เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านตัวมันในทิศทางเดียว ไอซี 7660 ทำหน้าที่แปลงไฟบวกให้เป็นไฟลบ เมื่อต่อวงจรตามรูปที่ 3.2 ไอซีแอลพี 2951 ในตัวที่ 1 จะได้แรงดันออกที่ขาที่ 1 (ขา out) เป็น 2 โวลต์ และไอซีแอลพี 2951 ในตัวที่ 2 แรงดันออกที่ขาที่ 1 (ขา out) เป็น 7 โวลต์ และเมื่อป้อนแรงดัน 7 โวลต์ ที่ขา V+ ของไอซี 7660 จะได้แรงดัน -7 โวลต์ที่ขาเอาต์พุท

3.3.2 โครงสร้างแสดงการต่ออุปกรณ์แบบละเอียด



รูปที่ 3.3 แสดงรายละเอียด

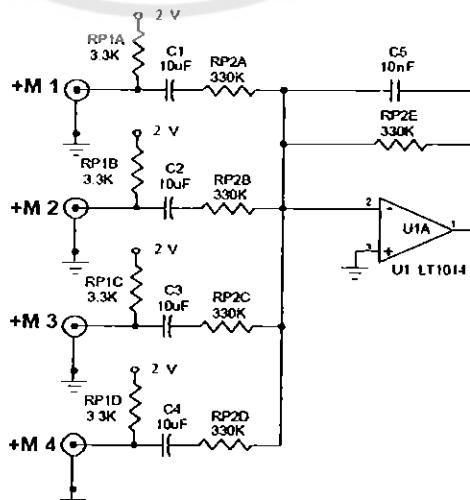
จากรูปที่ 3.3 ข้างต้นเป็นรูปการแสดงการต่อวงจรแบบละเอียดเพื่อช่วยให้สามารถต่อวงจร การเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง โดยจะแบ่งออกการทำงานเป็น 5 ส่วนหลักๆ ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้คือ

1. ส่วนแรกเป็นส่วนของการรับสัญญาณ Infrasonic (ความถี่ 0.1-20 Hz) โดยใช้ ไมโครโฟนตัวที่ 1 ถึง 4 เป็นเซนเซอร์
2. รวมสัญญาณเข้าด้วยกัน แล้วกรองความถี่ที่ให้ผ่านได้เฉพาะความถี่ที่ต้องการ(Band-pass-filter) ความถี่คัดオฟ 0.04และ20Hz เพื่อใช้ในส่วนของอินพุตของสัญญาณ
3. ภาคตัวกรองความถี่ที่ให้ผ่านได้เฉพาะความถี่ที่ต้องการ(Band-pass filter) รวมถึง วงจรอินทิเกรเตอร์(Integrator circuit) ทำการตรวจสอบสัญญาณที่ได้ด้วยเครื่องออส- ซิโลสโคป (Oscilloscope)
4. ภาคขยายสัญญาณเพื่อให้ได้สัญญาณที่แรงขึ้น เพื่อเตรียมส่งไปยังภาคเอาต์พุต ทำการ ตรวจสอบสัญญาณที่ได้ด้วยเครื่องออสซิโลสโคป (Oscilloscope)
5. สัญญาณภาคเอาต์พุตใช้เครื่องออสซิโลสโคป (Oscilloscope) วัดสัญญาณทางเวลา และทางความถี่

3.4 การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off ในส่วนต่างๆ

3.4.1 วงจร Summing

ในวงจรรวมสัญญาณนี้ เป็นการรวมสัญญาณที่ได้จากไมโครโฟนทุกตัวรับสัญญาณเข้ามา จากนั้นก่อผ่านวงจรกรองความถี่ในขั้นแรกด้วยเป็นวงจรกรองแบบ Band Pass Filter แสดงได้ดังรูป ที่ 3.4



รูปที่ 3.4 แสดงวงจรรวมสัญญาณ

การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off

$$\text{จากสมการ } f = \frac{1}{2\pi \times R \times C} \quad (3.1)$$

ดังนั้น เราจะได้ความถี่ cut-off ด้านต่ำ เท่ากับ

$$f_L = \frac{1}{2\pi \times R_{P2A} \times C_1} = \frac{1}{2\pi \times (330 \times 10^3) \times (10 \times 10^{-6})} = 0.04822 \text{ Hz}$$

และความถี่ cut-off ด้านสูง เท่ากับ

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times R_{P2E} \times C_5} = \frac{1}{2\pi \times (330 \times 10^3) \times (10 \times 10^{-9})} = 48.22877 \text{ Hz}$$

คำนวณหาอัตราขยายค่าแรงดันเอาต์พุต เกิดจากผลรวมของอัตราขยายสัญญาณอินพุตทั้งสี่

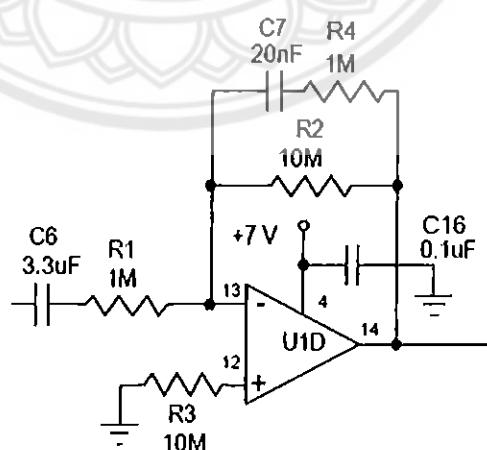
$$\begin{aligned} A_V(\max) &= R_{P2E} \left(\frac{1}{R_{P2A}} + \frac{1}{R_{P2B}} + \frac{1}{R_{P2C}} + \frac{1}{R_{P2D}} \right) \\ &= 330 \times 10^3 \left(\frac{1}{330 \times 10^3} + \frac{1}{330 \times 10^3} + \frac{1}{330 \times 10^3} + \frac{1}{330 \times 10^3} \right) \\ &= 4 \end{aligned}$$

หรือ

$$A_V(\max)(dB) = 20 \log(A_V) = 12 \text{ dB}$$

3.4.2 วงจรอินทิเกรเตอร์ (Integrator circuit)

ในตำแหน่ง U1D ใช้วงจรอินทิเกรเตอร์เพื่อช่วยในการซักเชยการตอบสนองความถี่ที่ต้องของไมโครโฟนแสดงดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U1D

การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off จากสมการ (3.1)

เราจะได้ความถี่ cut-off ด้านต่ำ เท่ากับ

$$f_L = \frac{1}{2\pi \times R_1 \times C_6} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (3.3 \times 10^{-6})} = 0.04822 \text{ Hz}$$

และความถี่ cut-off ด้านสูง เท่ากับ

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times R_2 \times C_7} = \frac{1}{2\pi \times (10 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 0.79577 \text{ Hz}$$

คำนวณหาอัตราขยาย

$$A_{V(\max)} = \frac{R_6}{R_5} = \frac{10 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 10$$

หรือ

$$A_{V(\max)}(dB) = 20 \log(A_V) = 20 \text{ dB}$$

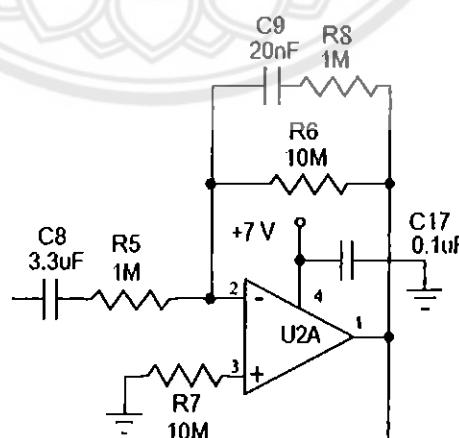
จากรูปมีการต่อ $R = 1M$ เพื่อชดเชยให้สามารถวัดความถี่ที่ 20 Hz ได้

$$A_{V(\max, \text{ชดเชย})} = \frac{R_4}{R_1} = \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 1$$

คำนวณความถี่ cut-off จากการชดเชย

$$f_{\text{ชดเชย}} = \frac{1}{2\pi \times R_4 \times C_7} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 7.95774 \text{ Hz}$$

ในตำแหน่ง U2A ใช้วงจรอนิทิเกรเตอร์เพื่อช่วยในการชดเชยการตอบสนองความถี่ที่ตกลงของไมโครโฟนแสดงดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U2A

การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off จากสมการ (3.1)

เราจะได้ความถี่ cut-off ด้านต่ำ เท่ากับ

$$f_L = \frac{1}{2\pi \times R_5 \times C_8} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (3.3 \times 10^{-6})} = 0.04822 \text{ Hz}$$

และความถี่ cut-off ด้านสูง เท่ากับ

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times R_6 \times C_9} = \frac{1}{2\pi \times (10 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 0.79577 \text{ Hz}$$

คำนวณหาอัตราขยาย

$$A_{V(\max)} = \frac{R_6}{R_5} = \frac{10 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 10$$

หรือ

$$A_{V(\max)}(dB) = 20 \log(A_V) = 20 \text{ dB}$$

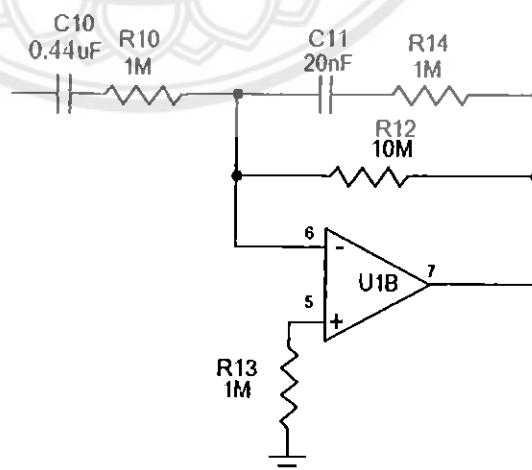
จากญี่ปุ่นการต่อ $R = 1M$ เพื่อชดเชยให้สามารถวัดความถี่ที่ 20 Hz ได้

$$A_{V(\max, \text{ชดเชย})} = \frac{R_8}{R_5} = \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 1$$

คำนวณความถี่ cut-off จากการชดเชย

$$f_{\text{ชดเชย}} = \frac{1}{2\pi \times R_8 \times C_9} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 7.95774 \text{ Hz}$$

ในตำแหน่ง U1B ใช้วงจรอินทิเกรเตอร์เพื่อช่วยในการชดเชยการตอบสนองความถี่ที่ตกลงของไมโครโฟนແສคงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 วงจร Integrator ในตำแหน่ง U1B

การคำนวณหาค่าความถี่ cut-off จากสมการ (3.1)

เราจะได้ความถี่ cut-off ด้านต่ำ เท่ากับ

$$f_L = \frac{1}{2\pi \times R_{10} \times C_{10}} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (0.44 \times 10^{-6})} = 0.36171 \text{ Hz}$$

และความถี่ cut-off ด้านสูง เท่ากับ

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times R_{12} \times C_{11}} = \frac{1}{2\pi \times (10 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 0.79577 \text{ Hz}$$

คำนวณหาอัตราขยาย

$$A_{V(\max)} = \frac{R_{12}}{R_{10}} = \frac{10 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 10$$

หรือ

$$A_{V(\max)}(dB) = 20 \log(A_V) = 20 \text{ dB}$$

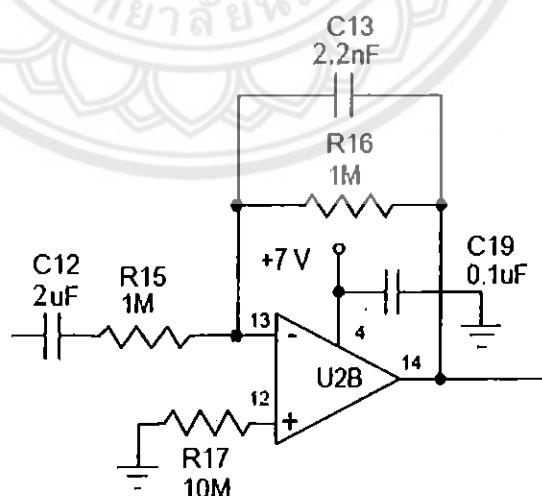
จากรูปมีการต่อ $R = 1M$ เพื่อชดเชยให้สามารถวัดความถี่ที่ 20 Hz ได้

$$A_{V(\max, \text{ชดเชย})} = \frac{R_{14}}{R_{10}} = \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 1$$

คำนวณความถี่ cut-off จากการชดเชย

$$f_{\text{ชดเชย}} = \frac{1}{2\pi \times R_{14} \times C_{11}} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (20 \times 10^{-9})} = 7.95774 \text{ Hz}$$

3.4.3 วงจร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B



รูปที่ 3.8 วงจร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B

การคำนวณหาบ้านความถี่ cut-off จากสมการ (3.1)

ดังนั้น เราจะได้ความถี่ cut-off ด้านต่ำ เท่ากับ

$$f_L = \frac{1}{2\pi \times R_{15} \times C_{12}} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (2 \times 10^{-6})} = 0.07957 \text{ Hz}$$

และความถี่ cut-off ด้านสูง เท่ากับ

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times R_{16} \times C_{13}} = \frac{1}{2\pi \times (1 \times 10^6) \times (2.2 \times 10^{-9})} = 72.34315 \text{ Hz}$$

คำนวณหาอัตราขยาย

$$A_{V(\max)} = \frac{R_{16}}{R_{15}} = \frac{1 \times 10^6}{1 \times 10^6} = 1$$

หรือ

$$A_{V(\max)}(dB) = 20 \log(A_V) = 0 \text{ dB}$$



บทที่ 4

ผลการทดสอบ

4.1 ระบบการทำงาน

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ

4.1.1 ภาครับสัญญาณเสียง



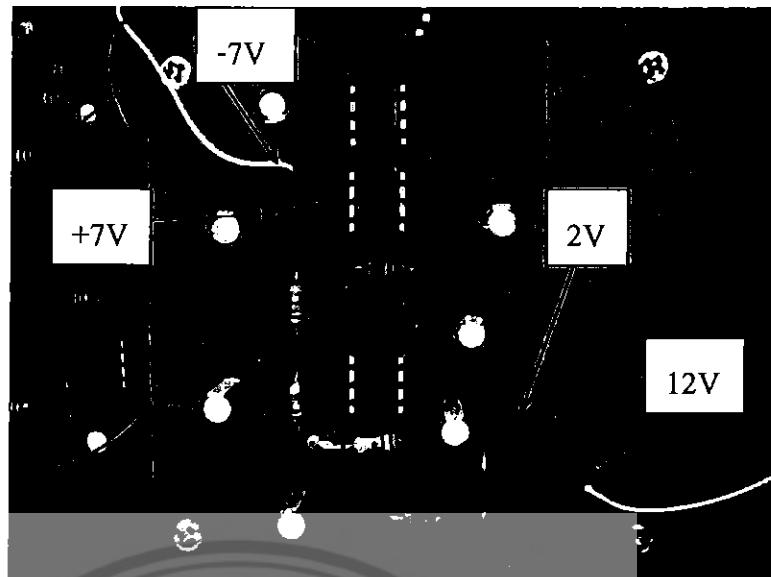
รูปที่ 4.1 ไมโครโฟน Panasonic WM-61A

ต่อไมโครโฟน WM-61A เข้ากับสายนำสัญญาณแบบสเตอริโอแล้วต่อ กับแจ็คตัวผู้

แบบสเตอริโอขนาด 3.5 mm

4.1.2 ภาคจ่ายไฟ

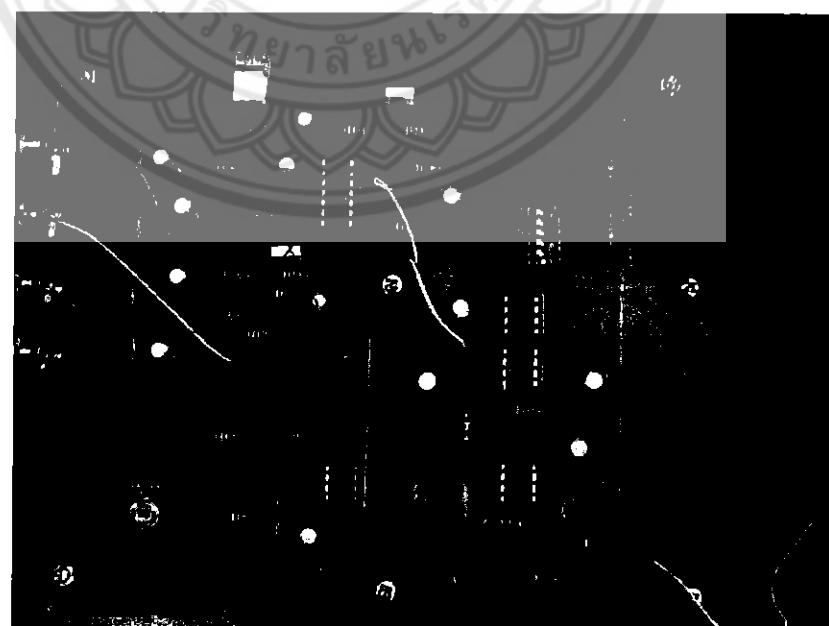
อุปกรณ์ในภาคประมวลผลรวมถึงคอนเดนเซอร์ในโทรศัพท์เป็นต้องมีภาคจ่ายไฟเพื่อที่จะให้อุปกรณ์ทำงาน โดยเราต้องจ่ายไฟเลี้ยงให้คอนเดนเซอร์ในโทรศัพท์ +2 โวลต์ จ่ายไฟเลี้ยงให้กับօปแอมป์ +7 โวลต์ และ -7 โวลต์



รูปที่ 4.2 ภาคจ่ายไฟ (Power supply)

4.1.3 ภาคประมวลผล

สัญญาณที่ได้รับจากไมโครโฟนจะถูกส่งไปในภาคประมวลผล แล้วได้สัญญาณออกมากที่เอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตที่ได้นี้สามารถนำไปต่อ กับ เครื่องอสซิลโลสโคป (oscilloscope) หรือเครื่องวัดสัญญาณต่างๆ เพื่อที่จะใช้ตรวจดูค่าด้านอินฟราเรดิกที่เกิดขึ้นได้



รูปที่ 4.3 แผงวงจรประมวลผลสัญญาณ

4.2 วิธีทำการทดลองและผลการทดลอง

จากการที่เราใช้ลำโพงในการกำเนิดสัญญาณเสียง เราจึงต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณเสียงเข้ามาช่วย และใช้เครื่องกำเนิดความถี่หรือ Function Generator เพื่อกำเนิดความถี่ที่เราต้องการ แล้วเครื่องกำเนิดความถี่สามารถจ่ายแรงดันได้เพียงอย่างเดียว เราจึงต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณเสียงเพื่อที่จะจ่ายกระแสให้ลำโพงด้วย

4.2.1 การวัดผลตอบสนองความถี่ของเครื่อง Stereo integrated amplifier

วิธีทำการทดลอง

1. ใช้โปรแกรม Scope กำเนิดสัญญาณเข้าเครื่อง Stereo integrated amplifier
2. นำสายไฟรับต่อ Channel 1 ของเครื่องอสซิลโลสโคป (oscilloscope) เพื่อวัดอินพุตที่เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) และนำสายไฟรับต่อ Channel 2 เพื่อวัดเอาต์พุตของเครื่อง Stereo integrated amplifier
3. ปล่อยสัญญาณ Sine wave ให้ใช้ความถี่ตามตารางที่ 4.1 บันทึกผล

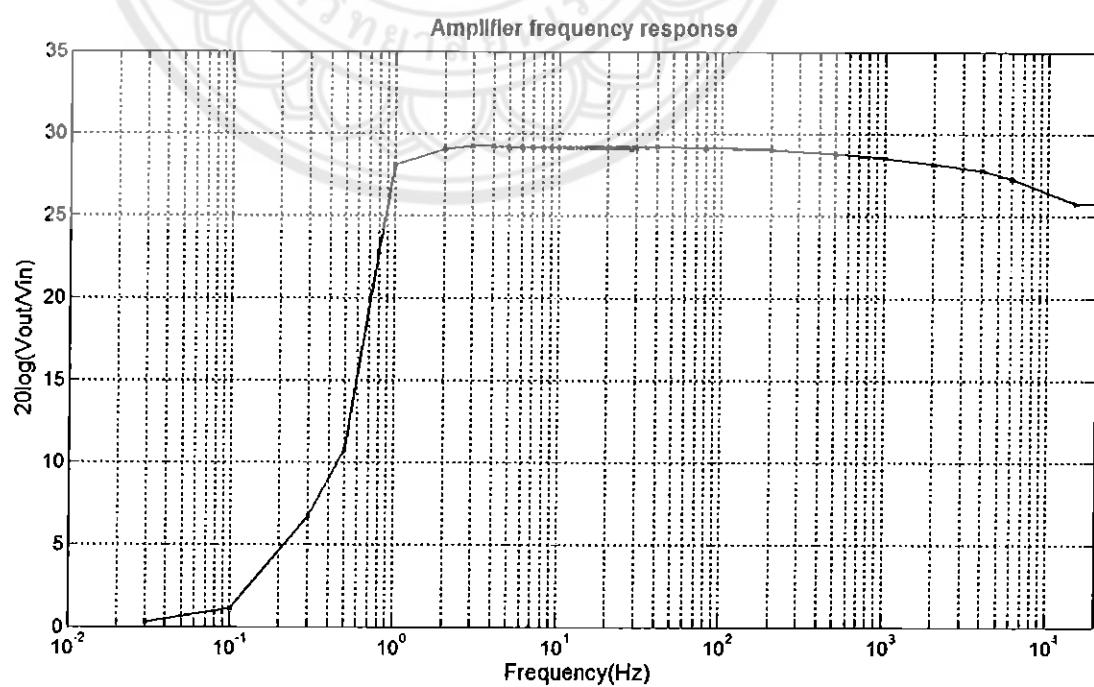
ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.1 ผลตอบสนองความถี่เครื่อง Stereo integrated amplifier

$f(\text{Hz})$	$V_{\text{in}}(\text{V}_{\text{rms}})$	$V_{\text{out}}(\text{V}_{\text{rms}})$	$f(\text{Hz})$	$V_{\text{in}}(\text{V}_{\text{rms}})$	$V_{\text{out}}(\text{V}_{\text{rms}})$
0.03	7.31	7.55	20	7.15	204.90
0.1	6.88	7.79	21	7.15	205.30
0.3	7.03	15.21	22	7.15	205.10
0.5	7.24	24.92	23	7.15	204.90
0.8	7.14	98.19	24	7.15	205.00
1	7.30	184.30	25	7.16	205.10
2	7.22	203.20	26	7.15	205.00
3	7.11	205.30	27	7.15	205.10
4	7.12	205.40	28	7.15	201.90
5	7.14	205.10	29	7.16	204.90
6	7.17	206.20	30	7.17	205.10
7	7.17	206.10	35	7.12	204.70

f(Hz)	$V_{in}(V_{rms})$	$V_{out}(V_{rms})$	f(Hz)	$V_{in}(V_{rms})$	$V_{out}(V_{rms})$
8	7.17	205.20	40	7.14	205.40
9	7.16	205.50	80	7.15	204.10
10	7.16	205.30	120	7.14	203.20
11	7.16	205.20	200	7.11	201.40
12	7.16	205.00	500	7.21	197.70
13	7.15	204.80	1k	7.30	194.90
14	7.16	204.90	2k	7.47	191.00
15	7.16	205.10	4k	7.45	181.40
16	7.16	205.00	6k	7.47	172.60
17	7.16	205.00	15k	7.38	143.10
18	7.15	204.90	20k	7.43	143.30
19	7.15	204.90	-	-	-

สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง V_{out}/V_{in} กับความถี่แสดงในรูปของ dB โดยแสดงเป็นกราฟได้ดัง

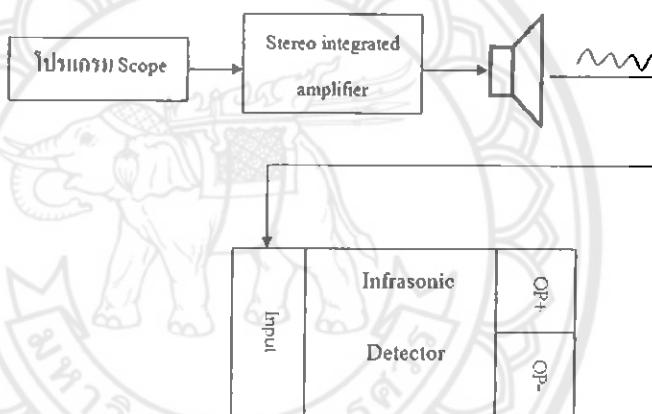


รูปที่ 4.4 ผลตอบสนองของเครื่อง Stereo integrated amplifier

จากรูปที่ 4.4 จะเห็นว่าการตอบสนองเครื่อง Stereo integrated amplifier นั้นคัดออกความถี่ที่ 1 Hz ซึ่งอาจเป็นผลต่ออุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ทำให้ไม่สามารถให้ความถี่ที่ต่ำกว่า 1Hz ได้

4.2.2 การวัดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ร่วมกับภาคประมวลผลของเครื่อง Stereo integrated amplifier

ตัวอย่างการทดสอบลำโพงยี่ห้อ Obom เราได้ใช้โปรแกรม Scope เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียงผ่านเข้าเครื่องขยายสัญญาณ Stereo integrated amplifier จากนั้นต่อออกลำโพง เพื่อที่จะสังเกตุการกระเพื่อมของลำโพงว่ามีการตอบสนองความถี่ต่ำร่วมกับเครื่อง Stereo integrated amplifier หรือไม่ และสัญญาณที่ออกจากลำโพงจะเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณเสียงคือไมโครโฟน จากนั้นทำการวัดที่เอาท์พุตของวงจรรวมสัญญาณแสดงดังรูปที่ 4.5

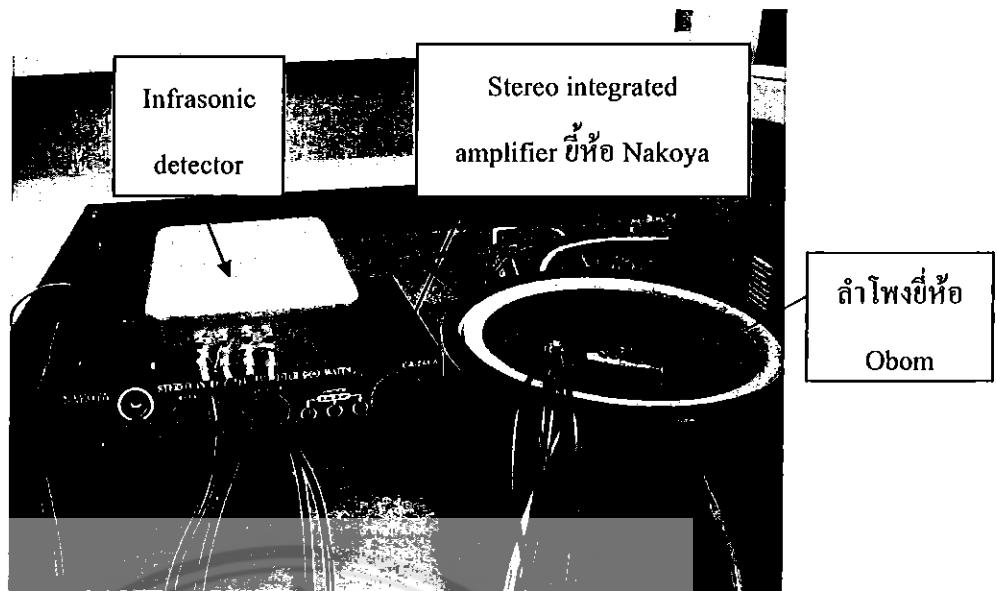


รูปที่ 4.5 แสดงการทดสอบลำโพง

การทดลองใช้อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียงดังตารางต่อไปนี้

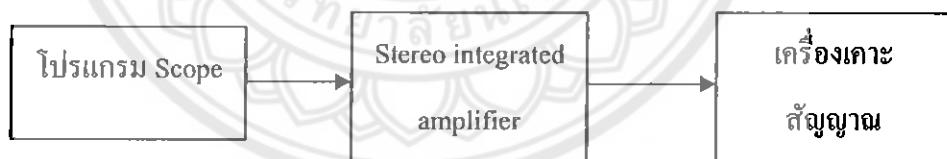
ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดลำโพงที่ใช้ในการทดสอบ

ลำโพง				
ขนาด (นิ้ว)	ยี่ห้อ	Max. Power	Impedance	Usable frequency
6	SAAG	1,000 W	8 Ω	20Hz-2kHz
8	Nakoya	50 W	8 Ω	50Hz-2kHz
8	Anaba	200 W	4 Ω	20Hz-2kHz
10	Obom	150 W	8 Ω	35Hz-3kHz
15	V.I.P.	100 W	4 Ω	35Hz-2kHz

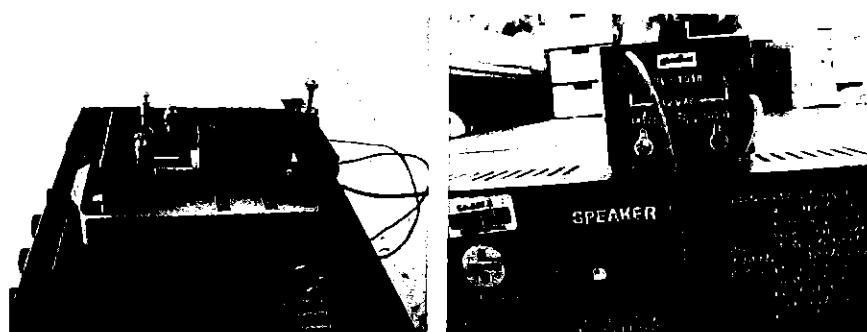


รูปที่ 4.6 ตัวอย่างการทดสอบลำโพงปี่ห้อ Obom

อิกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราได้นำมาทดสอบเป็นอุปกรณ์กำนิดสัญญาณเสียงคือ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ขนาด 12 V.AC. รุ่น ITL-1018 ทำการทดลองเป็นดังนี้คือ ต่อ Stereo integrated amplifier ขนาด 900 W, 220 V, 50 Hz กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลา แล้วทำการป้อนสัญญาณจากโปรแกรม Scope ผลที่ได้คือ เครื่องเคาะสัญญาณเวลาตอบสนองความถี่ต่ำสุดที่ 0.5 Hz แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้รูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 แสดงการทดสอบเครื่องเคาะสัญญาณเวลา



รูปที่ 4.8 การต่อเครื่องขยายสัญญาณ Stereo integrated amplifier กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลา

การป้อนความถี่ต่างๆจากโปรแกรม Scope ได้ผลการทดลองดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 ตารางผลการทดลองลำโพง

ลำโพง	ขนาด (นิ้ว)	ยี่ห้อ	Max. Power	Impedance	Usable frequency	การตอบสนองความถี่ต่ำที่สุดที่ได้จากการทดลอง
6	SAAG		1,000 W	8 Ω	20Hz-2kHz	8 Hz
8	Nakoya		50 W	8 Ω	50Hz-2kHz	10 Hz
8	Anaba		200 W	4 Ω	20Hz-2kHz	1Hz
10	Obom		150 W	8 Ω	35Hz-3kHz	2 Hz
15	V.I.P.		100 W	4 Ω	35Hz-2kHz	11 Hz

เนื่องจากว่าลำโพงไม่สามารถตอบสนองความถี่ต่ำกว่า 1Hz หรือไม่มีการกระเพื่อที่ความถี่น้อยกว่า 1 Hz ซึ่งอาจเป็นเพราะเครื่อง Stereo integrated amplifier ไม่ได้ตอบสนองความถี่ต่ำกว่า 1Hz จึงจำเป็นต้องต่อวงจรขยายเพื่อให้ตอบสนองความถี่ต่ำกว่า 1Hz ซึ่งจะแสดงในส่วนของผลการทดลองเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge ในครั้งต่อไป

4.2.3 การวัดผลตอบสนองความถี่ของเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge

วิธีทำการทดลอง

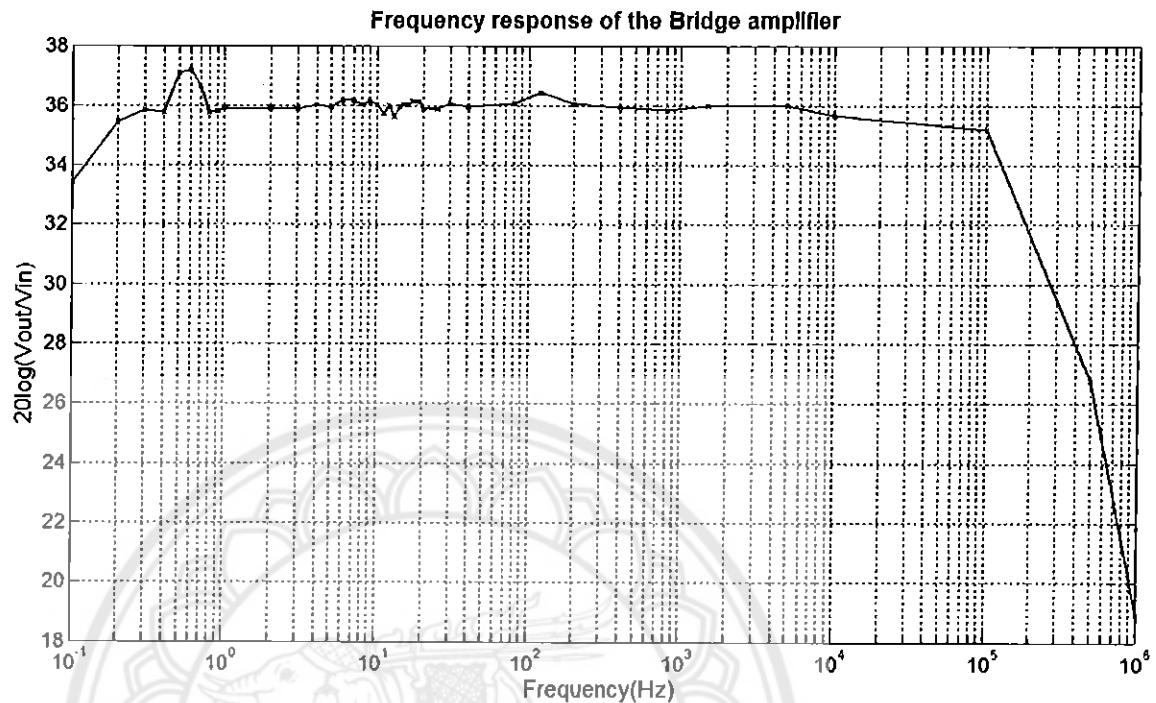
1. ต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) เข้าเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge
2. นำสายไฟรับต่อ Channel 1 ของเครื่องออสซิลโลสโคป (oscilloscope) เพื่อวัดอินพุตที่เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) และนำสายไฟรับต่อ Channel 2 เพื่อวัดเอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge
3. ปล่อยสัญญาณ Sine wave ใช้ความถี่ตามตารางที่ 4.4 บันทึกผล

ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.4 ผลตอบสนองความถี่เครื่องขยายเสียงแบบ Bridge

f (Hz)	V_{in} (V _{p-p})	V_{out} (V _{p-p})	f (Hz)	V_{in} (V _{p-p})	V_{out} (V _{p-p})
0.1	528.00 m	24.80	14	2.80	176.00
0.2	920.00 m	54.40	15	2.84	180.00
0.3	696.00 m	43.20	16	2.84	180.00
0.4	872.00 m	53.60	17	2.84	182.00
0.5	808.00 m	57.60	18	2.84	182.00
0.6	808.00 m	58.40	19	2.84	182.00
0.7	920.00 m	62.40	20	2.96	184.00
0.8	880.00 m	54.00	25	2.92	182.00
0.9	1.152	71.00	30	2.92	186.00
1	1.00	62.40	40	2.96	186.00
2	1.26	78.40	80	2.92	186.00
3	1.68	104.80	120	2.84	188.00
4	1.96	124.00	200	2.92	186.00
5	2.20	138.00	400	3.00	188.00
6	2.30	148.00	800	3.00	186.00
7	2.42	156.00	1.5k	2.92	184.00
8	2.56	162.00	5k	2.92	184.00
9	2.64	169.00	10k	3.00	182.00
10	2.68	170.00	100k	2.88	166.00
11	2.84	174.00	500k	2.84	62.00
12	2.76	174.00	1M	2.72	24.00
13	2.88	174.00	-	-	-

สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง V_{out}/V_{in} กับความถี่แสดงในรูปของ dB โดยแสดงเป็นกราฟได้ดัง

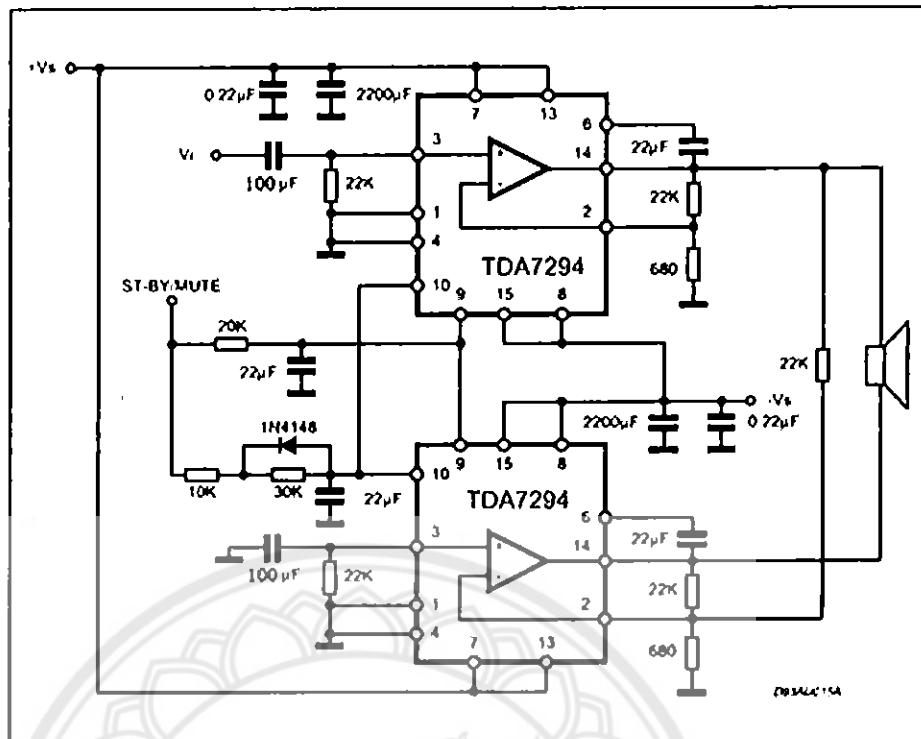


รูปที่ 4.9 ผลตอบสนองความถี่เครื่องขยายเสียงแบบ Bridge

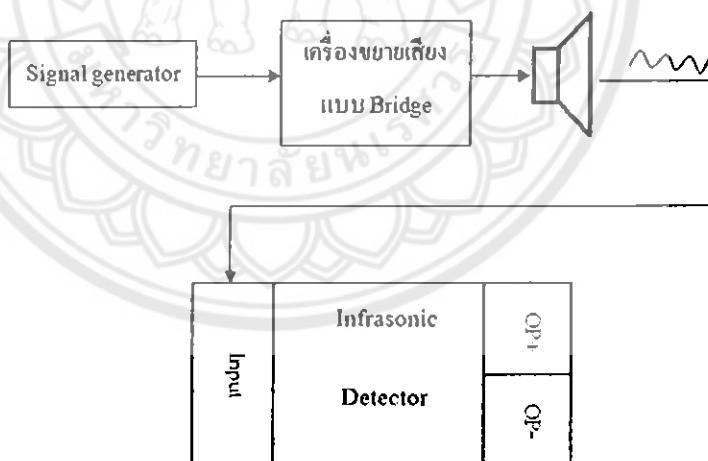
จากรูปที่ 4.9 จะเห็นว่าการตอบสนองเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge นั้นคัดกอฟความถี่ที่ 0.1 Hz ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ทำให้สามารถกำเนิดเสียงความถี่ต่ำกว่า 1 Hz ได้

4.2.4 การวัดอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียง (ลำโพง) ร่วมกับภาคประมวลผลของเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge

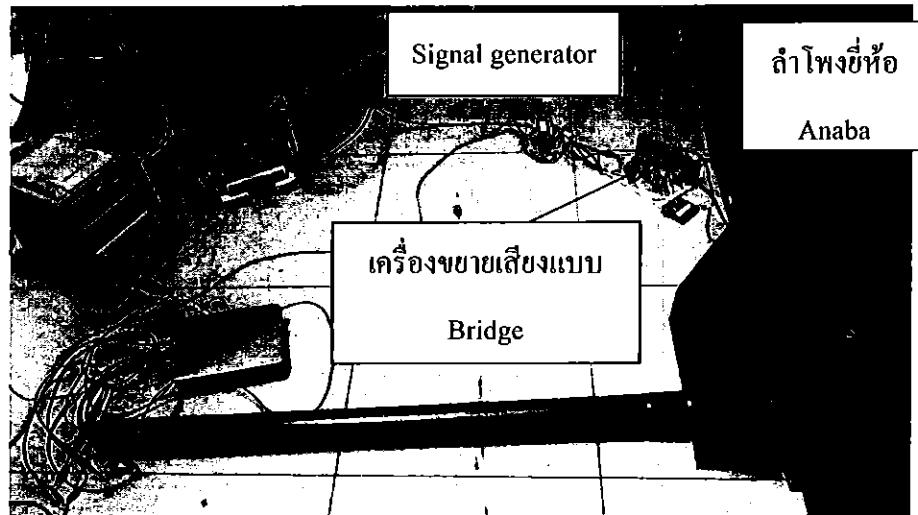
ตัวอย่างการทดสอบลำโพงยี่ห้อ Anaba เราได้ใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียงผ่านเข้าเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge วงจรตามรูปที่ 4.10 จากนั้นต่อ ออกลำโพงเพื่อที่จะสังเกตุการกระแสเพื่อนของลำโพงว่ามีการตอบสนองความถี่ต่ำร่วมกับเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge หรือไม่ สัญญาณที่ออกจากลำโพงจะเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณเสียงคือไมโครโฟน จากนั้นทำการวัดที่เอาท์พุตของวงจรรวมสัญญาณแสดงค้างรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.10 วงจรเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge



รูปที่ 4.11 แสดงการทดสอบลำโพง



รูปที่ 4.12 ตัวอย่างการทดสอบลำโพงยีห้อ Anaba

การทดสอบการตอบสนองของลำโพงยีห้อ Anaba ที่มีความถี่ต่ำกว่า 1 Hz กับ เครื่องขยายเสียงแบบ Bridge โดยใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) การทดสอบนี้ลำโพง มีการตอบสนองได้ดีในถึง 0.1 Hz หรือลำโพงกระเพื่อมได้ถึง 0.1 Hz ซึ่งจะสามารถใช้ทดสอบกับ เครื่องตรวจจับคลื่นอินฟราโซนิก (infrasonic detector) ได้ต่อไป

4.2.5 การทดสอบการกระเพื่อมของดอกลำโพง

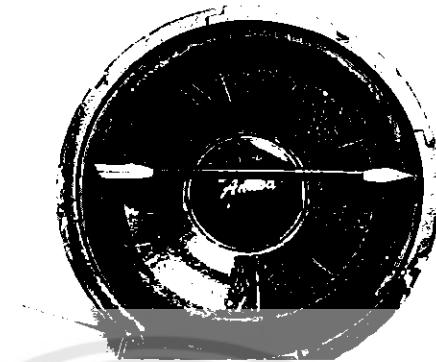
ในขั้นตอนแรกเราจะใช้คินสอดคิบันดอกลำโพงจากนั้นก็ทำการป้อนสัญญาณจากเครื่อง กำเนิดสัญญาณ (Signal generator) ผ่านตัวเครื่องขยายเสียงแบบ Bridge แล้วต่อออกทางด้านลำโพง แสดงการทำงานดังรูปที่ 4.13 ซึ่งลำโพงที่เรานำมาทดสอบการกระเพื่อมของดอกลำโพงเป็นลำโพง ยีห้อ Anaba รับกำลังไฟสูงสุด 200 W ขั้นตอนการทดสอบเป็นดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.13 ขั้นตอนการทดสอบลำโพง

วิธีการทดลอง

- นำคินสอที่ผ่าครึ่งทางด้านหัวและท้ายของคินสอนมาติดบนดอกลำโพงดังรูปที่ 4.14 และ 4.15

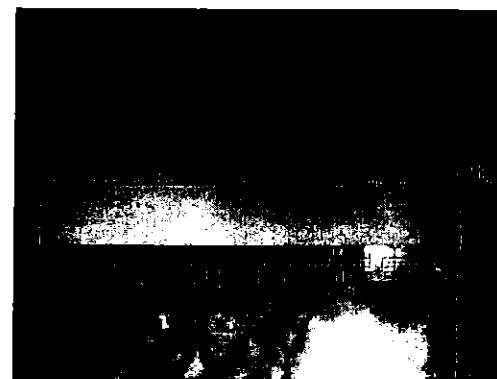


รูปที่ 4.14 ลักษณะการผ่าคินสอทางด้านหัวและท้ายของคินสอ



รูปที่ 4.15 การติดคินสอนนดอกลำโพง

- นำกระดาษมาติดบนไม้บรรทัดเหล็ก ในการติดกระดาษควรที่จะติดให้เห็นขีดของหน่วยนิลลิเมตรด้วยเพื่อความสะดวกในการวัดและบันทึกผล ดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 การติดกระดาษกับไม้บรรทัดเหล็ก

3. ทำการขัดเส้นตอนที่ดอกลำโพงบังไม่กระเพื่อมก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากระเพื่อมขึ้นหรือลงจาก เคิมเท่าไรดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 จินเส้นตอนที่ดอกลำโพงบังไม่กระเพื่อม

4. ทำการป้อนสัญญาณความถี่ $0.1\text{Hz}-20\text{Hz}$ แล้วบันทึกผลลงในตารางที่ 4.5



รูปที่ 4.18 ทำการวัดการกระเพื่อมของดอกลำโพง



รูปที่ 4.19 ผลการกระเพื่อมของดอกลำโพงที่ความถี่ $0.1\text{Hz} - 20\text{Hz}$

ผลการทดสอบ

ตารางที่ 4.5 ค่าแรงดันอินพุตที่ทำให้ลำโพงกระเพื่อมขึ้นที่ 4 mm. โดยมีค่ากลางที่ 5.5 mm.

f (Hz)	V_{in} (V _{p-p})	f (Hz)	V_{in} (V _{p-p})
0.1	370.00m	7	240.00m
0.2	370.00m	8	240.00m
0.3	370.00m	9	220.00m
0.4	350.00m	10	220.00m
0.5	350.00m	11	220.00m
0.6	320.00m	12	220.00m
0.7	320.00m	13	220.00m
0.8	320.00m	14	220.00m
0.9	320.00m	15	220.00m
1	300.00m	16	220.00m
2	300.00m	17	220.00m
3	270.00m	18	220.00m
4	260.00m	19	220.00m
5	240.00m	20	220.00m
6	240.00m	-	-

4.2.6 การทดสอบการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน WM-61A

วิธีการทดสอบ

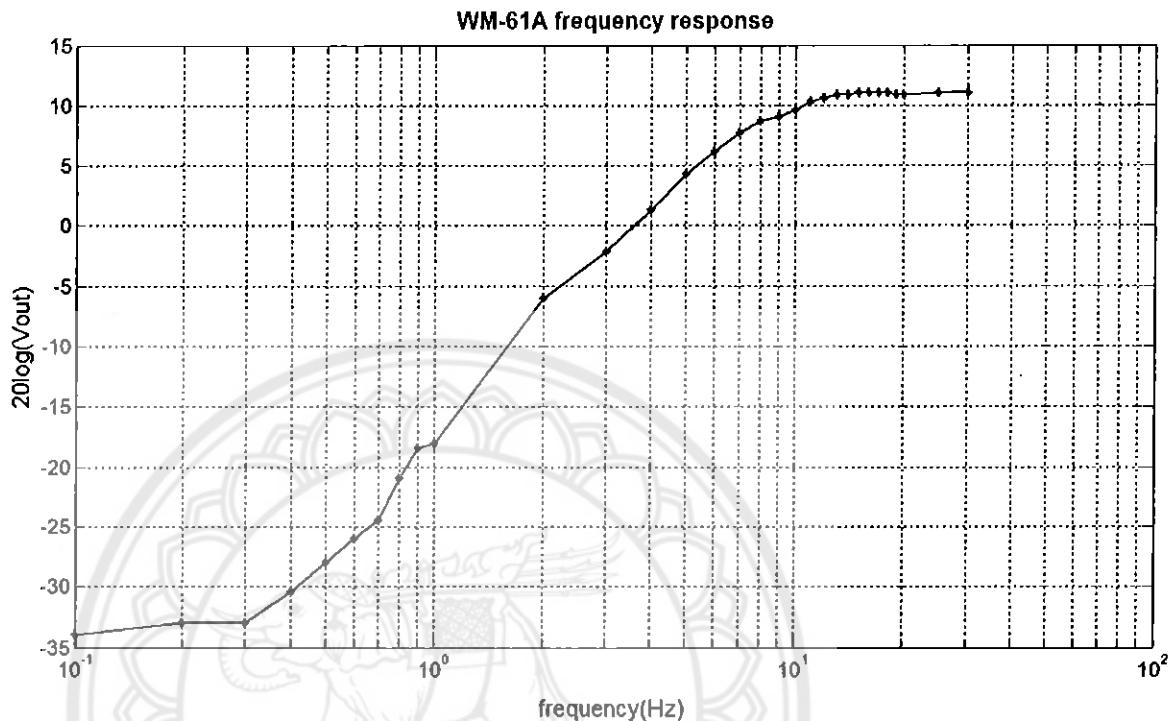
- ทำการป้อนสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) เข้าตัวขยายสัญญาณ แล้วต่อออกไปที่ลำโพง
- ทำการวัดสัญญาณโดยเครื่องจลนoscilloscope โดยอินพุตได้จากเครื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) และเอาท์พุตได้จากการรวมสัญญาณที่อยู่ในอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราไซนิก กำหนดให้ลำโพงกระเพื่อมเท่ากันหมวดที่ 4 mm. ไมโครโฟนอยู่ห่างจากลำโพง 20 cm.
- บันทึกผลในตารางที่ 4.6

ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.6 แสดงการทดสอบการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน WM-61A

f (Hz)	V_{out}(V_{p-p})	f (Hz)	V_{out}(V_{p-p})
0.1	20.00m	8	2.72
0.2	22.50m	9	2.84
0.3	22.50m	10	3.04
0.4	30.0m	11	3.28
0.5	40.00m	12	3.40
0.6	50.00m	13	3.52
0.7	60.00m	14	3.52
0.8	90.00m	15	3.56
0.9	120.00m	16	3.56
1	1128.00m	17	3.56
2	500.00m	18	3.56
3	780.00m	19	3.52
4	1.16	20	3.52
5	1.64	25	3.56
6	2.04	30	3.56
7	2.44	-	-

กราฟการทดสอบการตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน WM-61A แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับ V_{out} กำหนดให้ลำโพงกระเพื่อมเท่ากันหมวดที่ 4 mm. ในไมโครโฟนอยู่ห่างจากตอกลำโพง 20 cm.



รูปที่ 4.20 การตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ของไมโครโฟน WM-61A แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับ V_{out}

จากรูปที่ 4.20 จะเห็นได้ว่าไมโครโฟนมีการลดthonที่ตั้งแต่ 12 Hz ลงไปจนถึง 0.1 Hz ประมาณ 45dB ซึ่งเราจำเป็นต้องต่อวงจรดูบเชยความถี่ให้กับไมโครโฟนด้วย

4.2.7 ผลการตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรด

ในการทดสอบการตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดนี้ เราจะป้อนสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเข้าที่ตำแหน่งอินพุทของแต่ละวงจรตามรูปที่ 3.3 (ดูดสายแรงดัน 2V ออกก่อน) และวัดอินพุท-เอาต์พุทของแต่ละวงจรได้ดังนี้

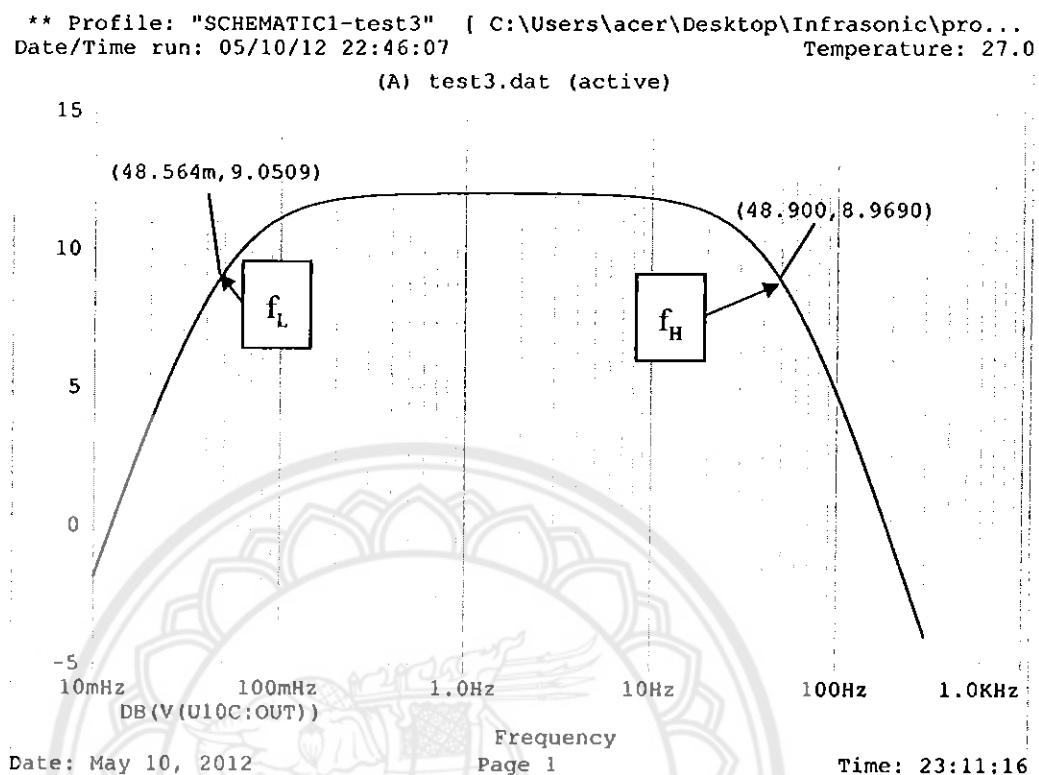
วงจรรวมสัญญาณ

ตามรูปที่ 3.4 อินพุทคือตำแหน่ง C1, C2, C3 หรือ C4 ที่ได้สัญญาณจะเข้าที่ขา 2 ของอปексอนบี U1A และเอาต์พุทคือขา 1 ของอปексอนบี U1A ให้ทดสอบสนองความถี่ดังตารางด้านไปนี้

ตารางที่ 4.7 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรรวมสัญญาณ

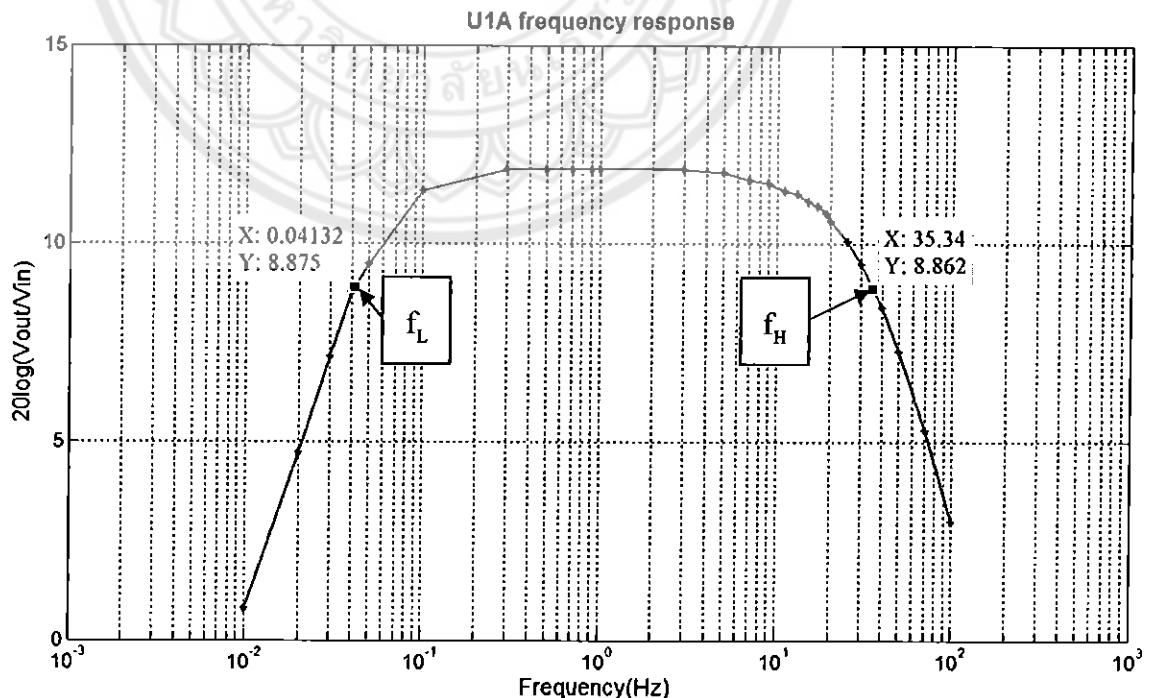
f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})	f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})
0.01	1.02	1.04	11	1.02	4.04
0.02	1.02	1.76	13	1.02	4.04
0.03	1.02	2.32	15	1.02	4.04
0.04	1.02	2.76	17	1.02	4.04
0.05	1.02	3.08	19	1.02	4.00
0.1	1.02	3.68	20	1.02	4.00
0.3	1.02	4.00	25	1.02	3.96
0.5	1.02	4.04	30	1.02	3.88
0.7	1.02	4.04	40	1.02	3.80
0.9	1.02	4.04	50	1.02	3.72
1	1.02	4.04	70	1.02	3.44
3	1.02	4.04	100	1.02	3.12
5	1.02	4.04	200	1.02	2.16
7	1.02	4.04	400	1.02	1.28
9	1.02	4.04	-	-	-

กราฟผลตอบสนองความถี่วงจรรวมสัญญาณที่ได้จากโปรแกรม Pspice



รูปที่ 4.21 ผลตอบสนองความถี่วงจรรวมสัญญาณที่ได้จากโปรแกรม Pspice

กราฟผลตอบสนองความถี่วงจรรวมสัญญาณ แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $V_{out}(V_{pp})$ กับ $V_{in}(V_{pp})$



รูปที่ 4.22 แสดงผลตอบสนองความถี่ของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

จากรูปที่ 4.22 ในด้านความถี่ต่ำหรือ f_L เรา cut-off ไว้ที่ 0.04822 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.04346 Hz เป็นผลมาจากตัวเก็บประจุ 10nF อนุกรมกับตัวต้านทาน 330k อยู่ในตำแหน่ง U1A ตามรูปที่ 3.4 และในรูปที่ 4.22 และในด้านความถี่ต่ำหรือ f_H เรา cut-off ไว้ที่ 48.22877 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ที่ 35.34 Hz เป็นผลมาจากตัวเก็บประจุ 10uF ขนานกับตัวต้านทาน 330k อยู่ในตำแหน่ง U1A ตามรูปที่ 3.4 และจากรูปที่ 4.21 ซึ่งเป็นกราฟผลตอบสนอง วงจรรวมสัญญาณที่ได้จากโปรแกรม Pspice มีลักษณะคล้ายกับผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

วงจรอินพิเกรตอร์ ในตำแหน่ง U1D

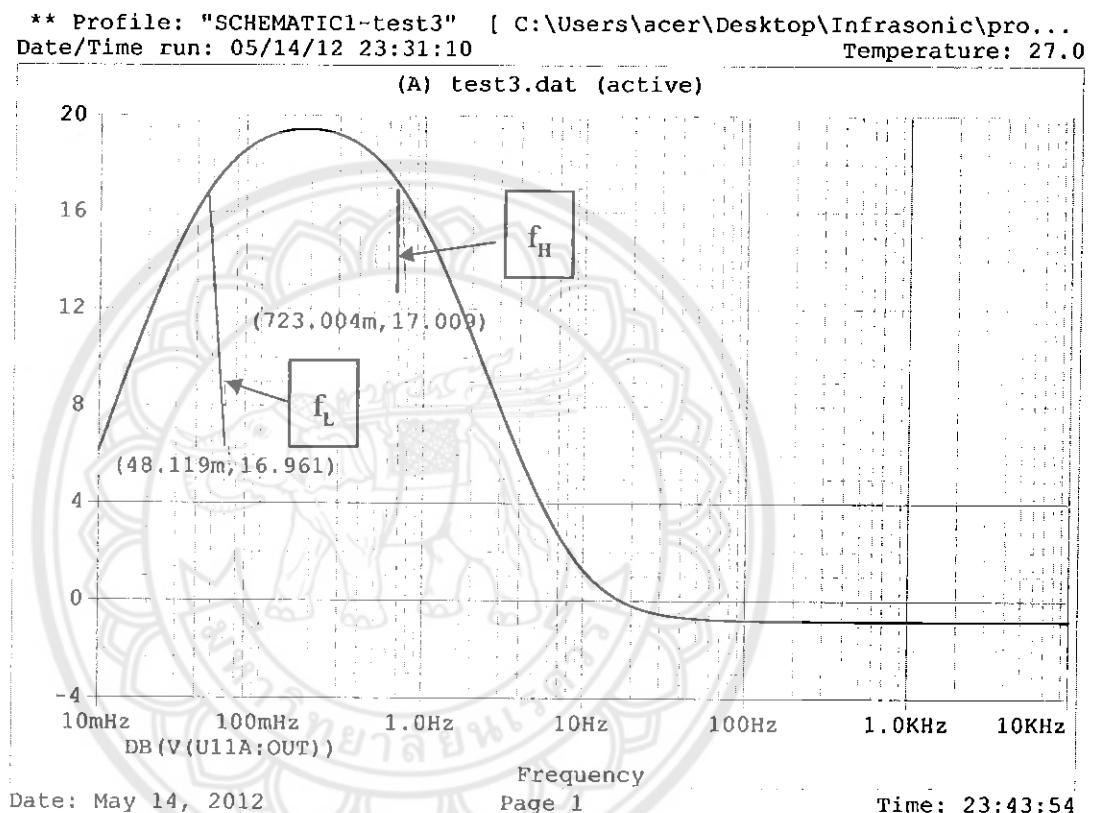
ตามรูปที่ 3.5 อินพุทคือตำแหน่ง C6 3.3uF สัญญาณจะเข้าที่ขา 13 ของอปแอมป์ U1D และเอาต์พุทของอปแอมป์ U1D คือที่ตำแหน่งขา 14 ได้ผลตอบสนองดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.8 แสดงอินพุตและเอาต์พุทของวงจร Band Pass Filter

f (Hz)	$V_{in}(V_{p-p})$	$V_{out}(V_{p-p})$	f (Hz)	$V_{in}(V_{p-p})$	$V_{out}(V_{p-p})$
0.01	1.02	2.24	13	1.02	1.16
0.02	1.02	4.00	15	1.02	1.12
0.03	1.02	5.60	17	1.02	1.08
0.04	1.02	6.40	19	1.02	1.06
0.05	1.02	7.20	20	1.02	1.04
0.1	1.02	9.00	25	1.02	1.00
0.3	1.02	9.00	30	1.02	1.00
0.5	1.02	8.08	40	1.02	960m
0.7	1.02	7.04	50	1.02	960m
0.9	1.02	6.16	70	1.02	960m
1	1.02	5.84	100	1.02	960m
3	1.02	2.52	200	1.02	960m
5	1.02	1.76	500	1.02	960m
7	1.02	1.46	1k	1.02	960m

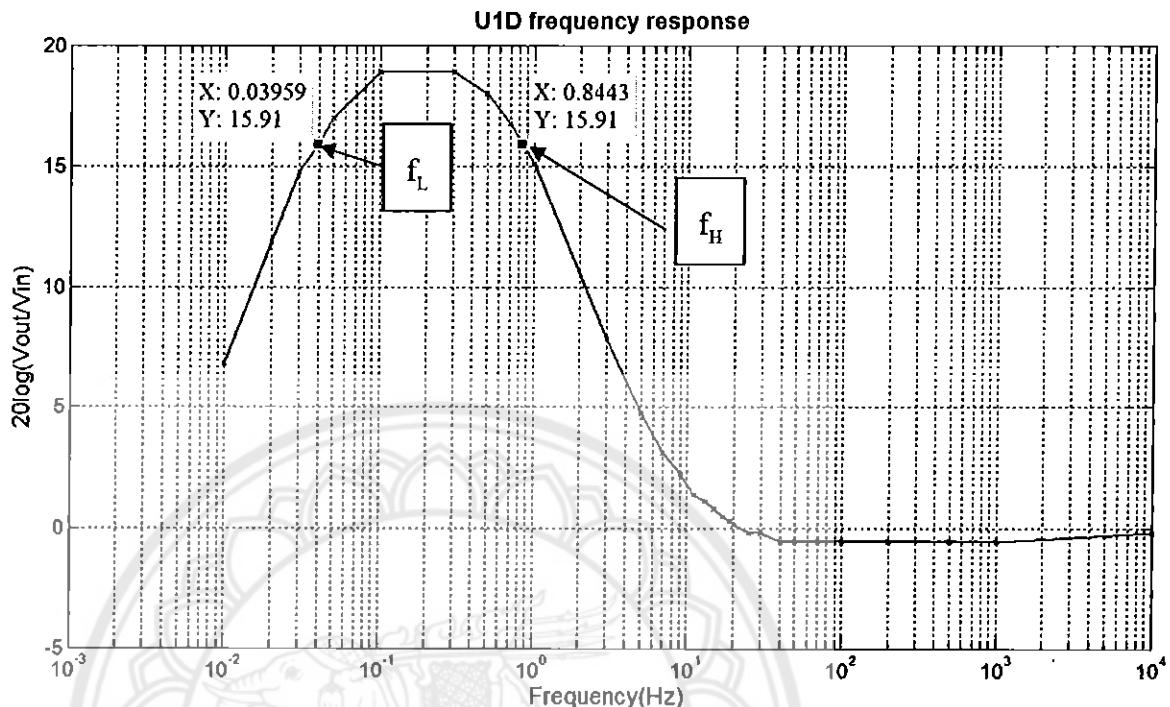
f (Hz)	Vin(V_{p-p})	Vout(V_{p-p})	f (Hz)	Vin(V_{p-p})	Vout(V_{p-p})
9	1.02	1.32	10k	1.02	1.00
11	1.02	1.20	-	-	-

กราฟผลตอบสนองความถี่วงจรอินทิเกรเตอร์ในคำแนะนำ U1D ที่ได้จากโปรแกรม Pspice



รูปที่ 4.23 ผลตอบสนองความถี่วงจรอินทิเกรเตอร์ในคำแนะนำ U1D ที่ได้จากโปรแกรม Pspice

กราฟผลตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1D แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $V_{out}(V_{pp})$ กับ $V_{in}(V_{pp})$



รูปที่ 4.24 แสดงผลตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1D ที่ได้จากการทดลอง

จากรูปที่ 4.24 ในค้านความถี่ต่ำหรือ f_L เรา cut-off ไว้ที่ 0.04822 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.03959 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 3.3nF อนุกรมกับตัวด้านท่าน 1M อยู่ในตำแหน่ง U1D ตามรูปที่ 3.5 และในรูปที่ 4.24 และในค้านความถี่สูงหรือ f_H เรา cut-off ไว้ที่ 0.79577 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.8443 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF 串联 กับตัวด้านท่าน 10M อยู่ในตำแหน่ง U1D ตามรูปที่ 3.5 และการซัดเชยเรซิตเซย์ที่ความถี่ 7.9577 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF อนุกรมกับตัวด้านท่าน 1M มีอัตราขยายของการซัดเชย 0 dB และจากรูปที่ 4.23 ซึ่งเป็นกราฟผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง Pspice นี้ลักษณะคล้ายกับผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

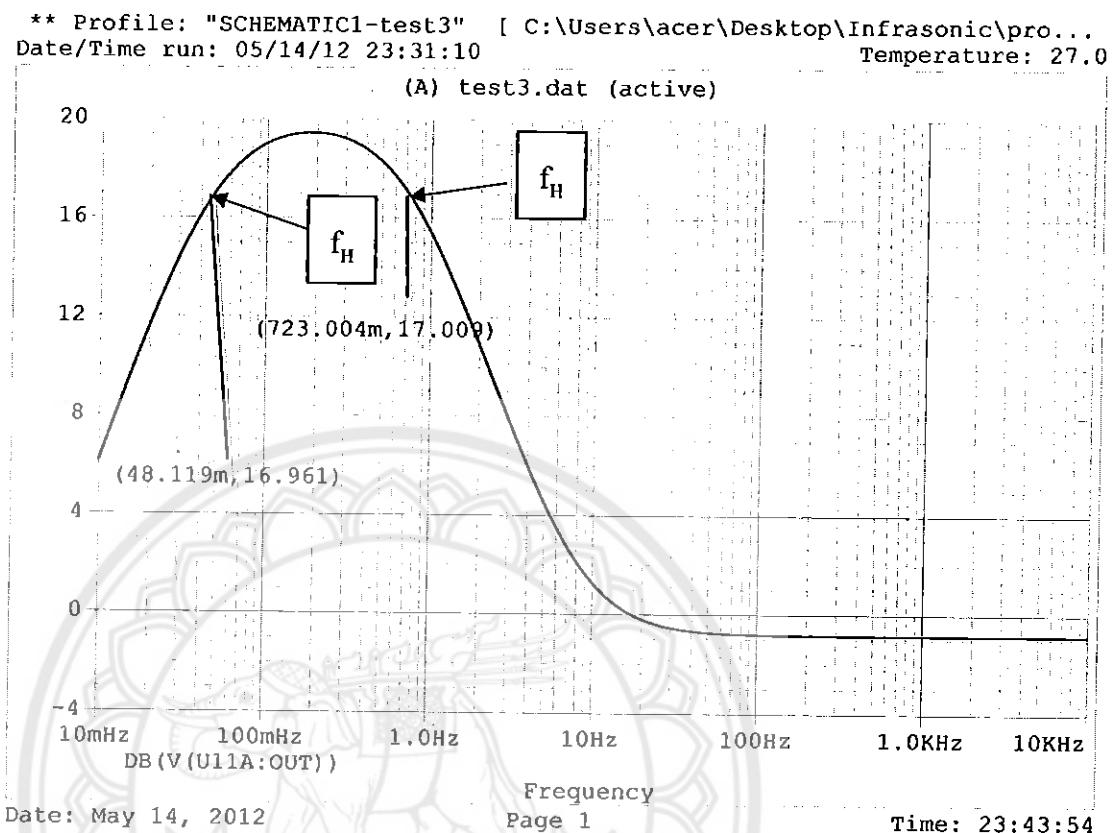
วงจรอินทิเกรเตอร์ ในตำแหน่ง U2A

ในตำแหน่ง U2A ตามรูปที่ 3.6 อินพุทคือตำแหน่ง C8 3.3nF สัญญาณจะเข้าที่ขา 2 ของ ออปเปอเรเตอร์ U2A และเอาต์พุทของอปเปอเรเตอร์ U2A ก็อที่ตำแหน่งขา 1 ได้ผลตอบสนองความถี่ดัง ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.9 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A

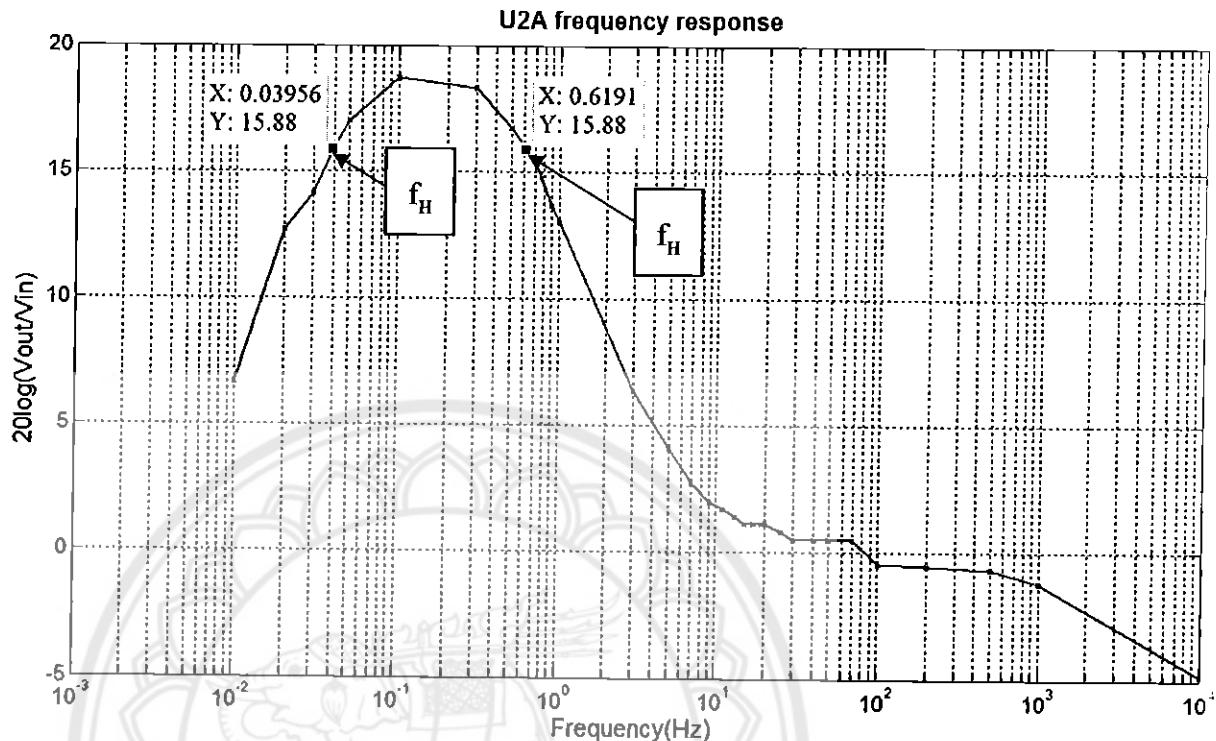
f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})	f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})
0.01	1.02	2.20	13	1.02	1.20
0.02	1.02	4.40	15	1.02	1.16
0.03	1.02	5.20	17	1.02	1.16
0.04	1.02	6.40	19	1.02	1.16
0.05	1.02	7.20	20	1.02	1.16
0.1	1.02	8.80	25	1.02	1.12
0.3	1.02	8.40	30	1.02	1.08
0.5	1.02	7.00	40	1.02	1.08
0.7	1.02	6.00	50	1.02	1.08
0.9	1.02	4.92	70	1.02	1.08
1	1.02	4.56	100	1.02	968m
3	1.02	2.12	200	1.02	960m
5	1.02	1.64	500	1.02	944m
7	1.02	1.40	1k	1.02	888m
9	1.02	1.28	10k	1.02	584m
11	1.02	1.24	-	-	-

กราฟผลตอบสนองความถี่วงจรอินพิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A ที่ได้จากโปรแกรม Pspice



รูปที่ 4.25 ผลตอบสนองความถี่วงจรอินพิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2A ที่ได้จากโปรแกรม Pspice

กราฟผลตอบสนองความถี่ของวงจรอินพิเกรเตอร์ U2A แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $V_{out}(V_{pp})$ กับ $V_{in}(V_{pp})$



รูปที่ 4.26 แสดงผลตอบความถี่สัมของของวงจรอินพิเกรเตอร์ในตัวแหน่ง U2A ที่ได้จากการทดลองจากรูปที่ 4.26 ในค่านความถี่ต่ำหรือ f_L เรา cut-off ไว้ที่ 0.04822 Hz แต่ในการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.03956 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 3.3uF อนุกรมกับตัวต้านทาน 1M อยู่ในตัวแหน่ง U2A ตามรูปที่ 3.6 และในรูปที่ 4.26 และในค่านความถี่สูงหรือ f_H เรา cut-off ไว้ที่ 0.76191 Hz แต่ในการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.8443 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF ขนานกับตัวต้านทาน 10M อยู่ในตัวแหน่ง U1D ตามรูปที่ 3.6 และการซัดเชยราชซัดเชยที่ความถี่ 7.9577 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF อนุกรมกับตัวต้านทาน 1M มีอัตราขยายของการซัดเชย 0 dB และจากรูปที่ 4.25 ซึ่งเป็นกราฟผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการโปรแกรม Pspice มีลักษณะคล้ายกับผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

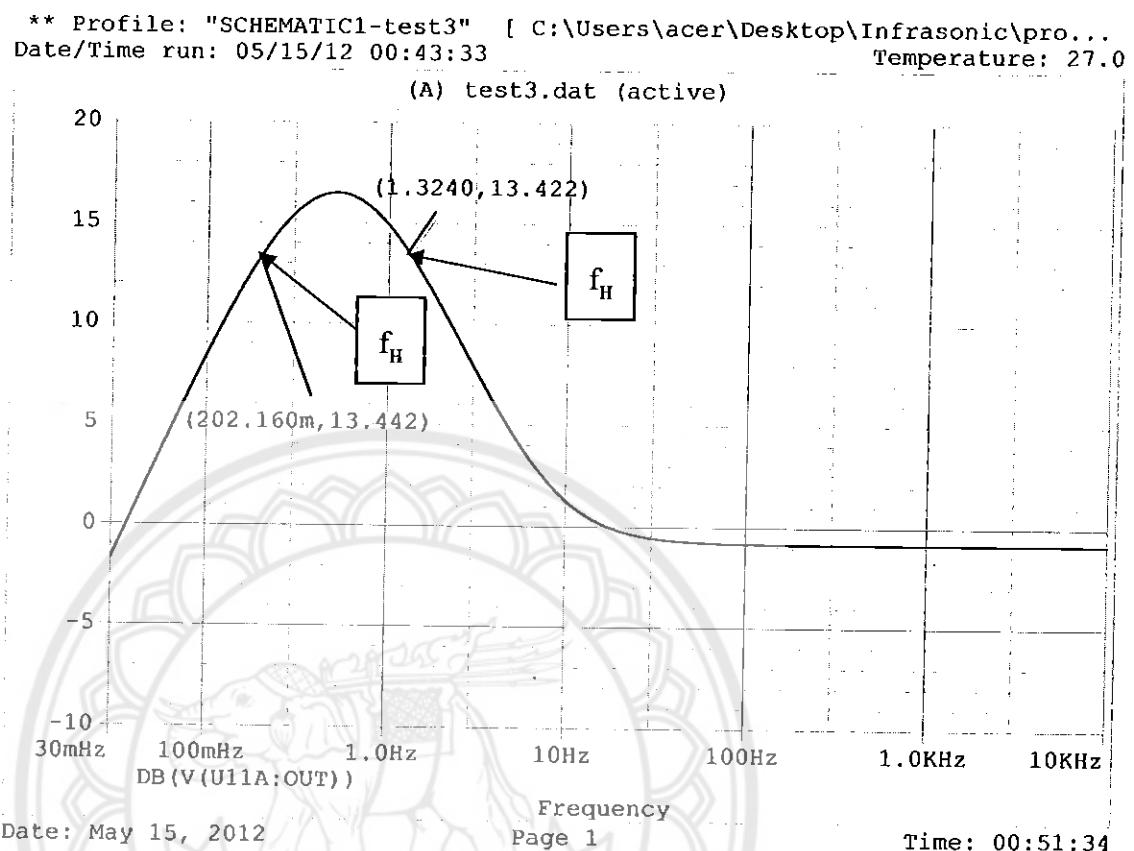
วงจรอินทิเกรเตอร์ ในตำแหน่ง U1B

ในตำแหน่ง U1B ตามรูปที่ 3.7 อินพุตคือตำแหน่ง C10 0.44uF สัญญาณจะเข้าที่ขา 6 ของอອปแอมป์ U1B และเอาต์พุทของอອปแอมป์ U1B คือที่ตำแหน่งขา 7 ได้ผลตอบสนองความถี่ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.10 แสดงอินพุตและเอาต์พุทของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B

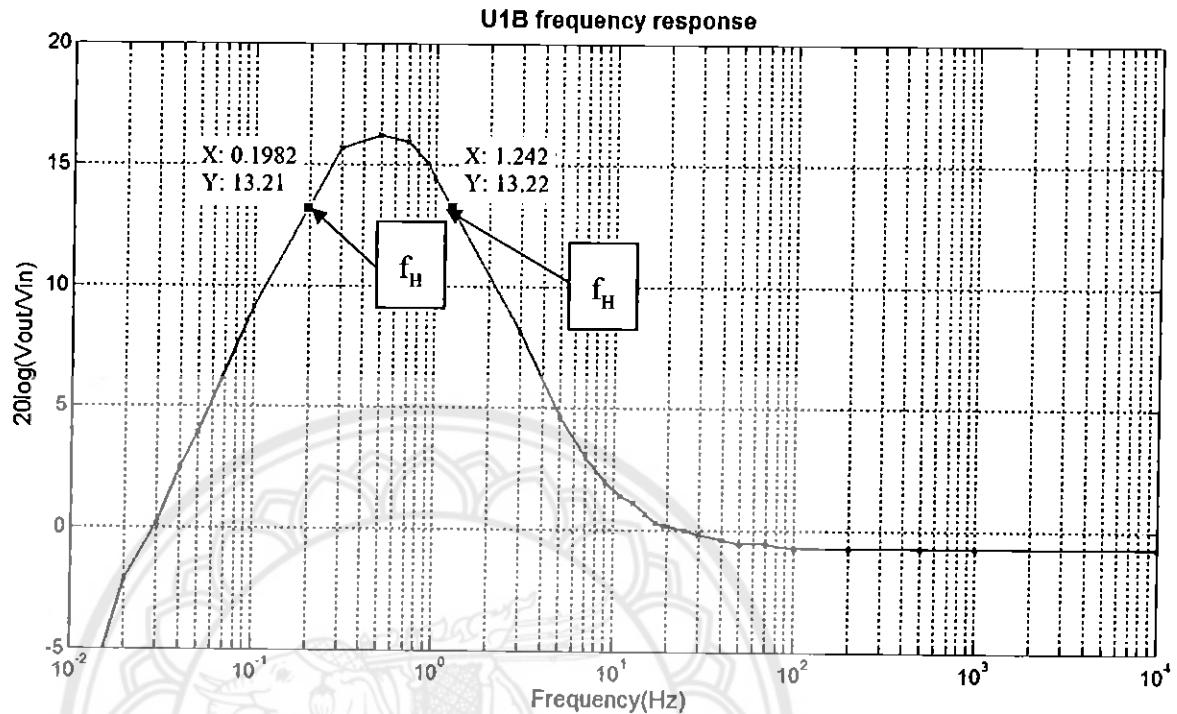
f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})	f (Hz)	V_{in}(V_{p-p})	V_{out}(V_{p-p})
0.01	1.02	340m	13	1.02	1.16
0.02	1.02	800m	15	1.02	1.10
0.03	1.02	1.04	17	1.02	1.06
0.04	1.02	1.36	19	1.02	1.04
0.05	1.02	1.60	20	1.02	1.04
0.1	1.02	2.92	25	1.02	1.02
0.3	1.02	6.20	30	1.02	1.00
0.5	1.02	6.60	40	1.02	980m
0.7	1.02	6.40	50	1.02	960m
0.9	1.02	5.80	70	1.02	960m
1	1.02	5.40	100	1.02	940m
3	1.02	2.60	200	1.02	940m
5	1.02	1.74	500	1.02	940m
7	1.02	1.44	1k	1.02	940m
9	1.02	1.28	10k	1.02	940m
11	1.02	1.20	-	-	-

กราฟผลตอบสนองความถี่วงจรอินพิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice



รูปที่ 4.27 ผลตอบสนองความถี่วงจรอินพิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U1B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice

กราฟผลตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ UIB แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $V_{out}(V_{pp})$ กับ $V_{in}(V_{pp})$



รูปที่ 4.28 แสดงผลตอบสนองความถี่ของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง UIB ที่ได้จากการทดลอง
จากรูปที่ 4.28 ในค่านความถี่ต่ำหรือ f_L เรา cut-off ไว้ที่ 0.3617 Hz แต่ในผลการทดลองเรา¹
ได้ cut-off ที่ 0.1982 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 0.44uF อนุกรมกับตัวด้านทาน 1M อยู่ใน
ตำแหน่ง UIB ตามรูปที่ 3.7 และในรูปที่ 4.28 และในค่านความถี่สูงหรือ f_H เรา cut-off ไว้ที่
0.79577 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 1.242 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF ขนาด
กับตัวด้านทาน 10M อยู่ในตำแหน่ง UIB ตามรูปที่ 3.7 และการซัดเซยเรขาคณิตที่ความถี่ 7.9577
Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 20nF อนุกรมกับตัวด้านทาน 1M มีอัตราขยายของการซัดเซย 0 dB
และจากรูปที่ 4.27 ซึ่งเป็นกราฟผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากโปรแกรม Pspice มี
ลักษณะคล้ายกับผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

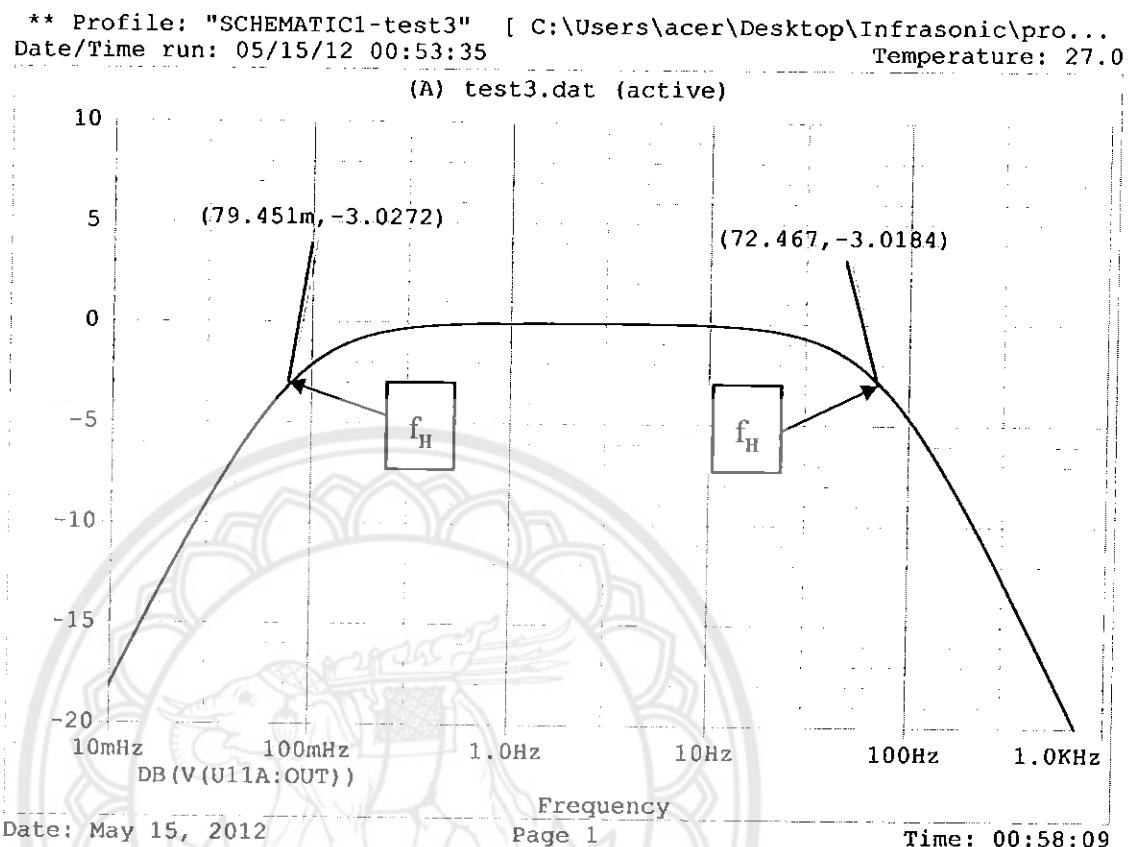
วงจร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B

ในตำแหน่ง U2B ตามรูปที่ 3.8 อินพุตคือตำแหน่ง C12 2uF สัญญาณจะเข้าที่ขา 13 ของอปีแอมป์ U2B และเอาต์พุตของอปีแอมป์ U2B คือที่ตำแหน่งขา 14 ได้ผลตอบสนองความถี่ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.11 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของวงจรอินทิเกรเตอร์ในตำแหน่ง U2B

f (Hz)	$V_{in}(V_{p-p})$	$V_{out}(V_{p-p})$	f (Hz)	$V_{in}(V_{p-p})$	$V_{out}(V_{p-p})$
0.01	1.02	160.00m	11	1.02	1.02
0.02	1.02	280.00m	13	1.02	1.02
0.03	1.02	400.00m	15	1.02	1.02
0.04	1.02	480.00m	17	1.02	1.00
0.05	1.02	560.00m	19	1.02	1.00
0.1	1.02	800.00m	20	1.02	1.00
0.3	1.02	1.00	25	1.02	980.00m
0.5	1.02	1.00	30	1.02	940.00m
0.7	1.02	1.02	40	1.02	900.00m
0.9	1.02	1.02	50	1.02	860.00m
1	1.02	1.02	70	1.02	740.00m
3	1.02	1.02	100	1.02	620.00m
5	1.02	1.02	200	1.02	372.00m
7	1.02	1.02	500	1.02	180.00m
9	1.02	1.02	-	-	-

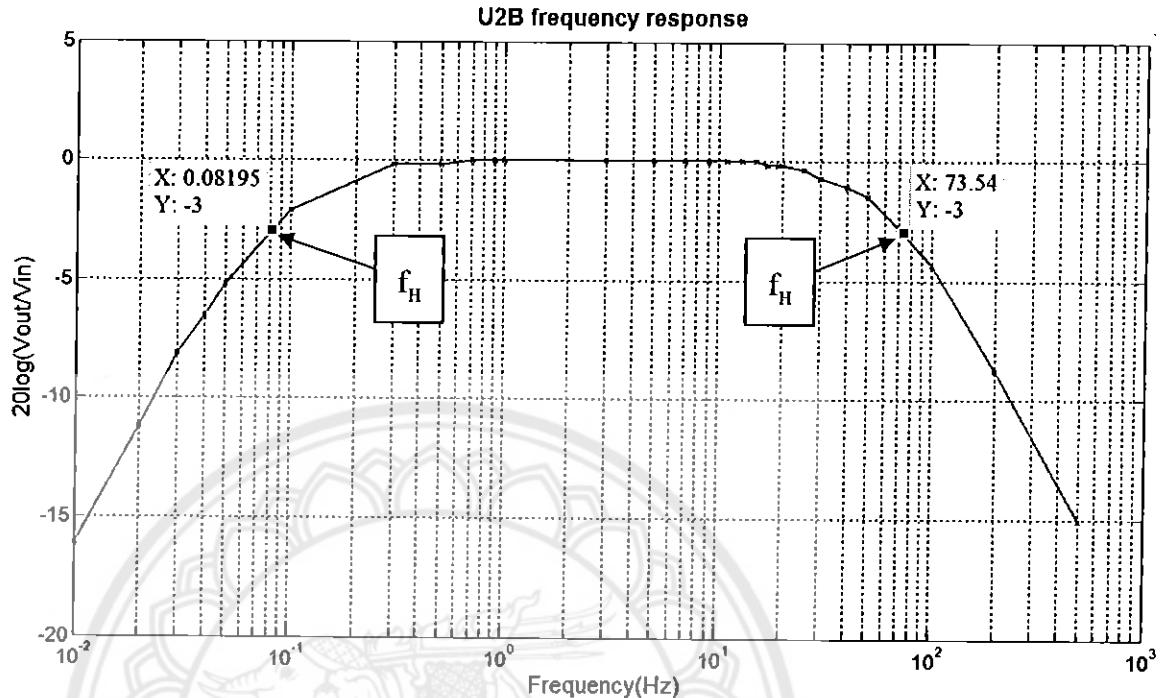
กราฟผลตอบสนองความถี่ของ Band pass filter ในตำแหน่ง U2B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice



รูปที่ 4.29 ผลตอบสนองความถี่ของ Band pass filter ในตำแหน่ง U2B ที่ได้จากโปรแกรม Pspice

กราฟผลตอบสนองความถี่ของ Band pass filter ในตำแหน่ง U2B แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

$V_{out}(V_{pp})$ กับ $V_{in}(V_{pp})$



รูปที่ 4.30 แสดงผลตอบสนองความถี่ของวงจร Band pass filter ในตำแหน่ง U2B

ที่ได้จากการทดลอง

จากรูปที่ 4.30 ในค้านความถี่ต่ำหรือ f_L เรา cut-off ไว้ที่ 0.07957 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 0.08195 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 0.44uF อนุกรมกับตัวด้านท่าน IM อู้ในตำแหน่ง U2B ตามรูปที่ 3.8 และในรูปที่ 4.30 และในค้านความถี่สูงหรือ f_H เรา cut-off ไว้ที่ 72.3431 Hz แต่ในผลการทดลองเราได้ cut-off ที่ 73.54 Hz เป็นผลมาจากการตัวเก็บประจุ 2.2nF ขนาดกับตัวด้านท่าน IM อู้ในตำแหน่ง U1B ตามรูปที่ 3.8 และจากรูปที่ 4.29 ซึ่งเป็นกราฟผลตอบสนองของวงจรรวมสัญญาณที่ได้จากการทดลอง

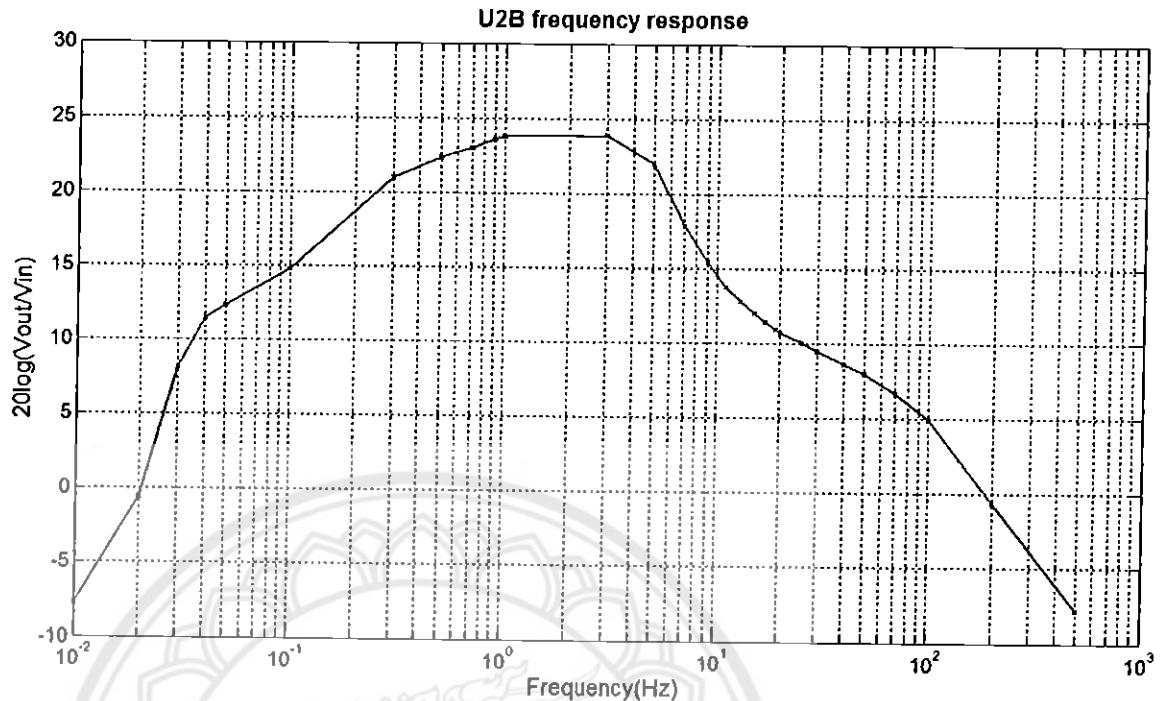
ผลตอบสนองของอุปกรณ์ Infrasonic detector

ตามรูปที่ 3.3 อินพุตคือตัวแหน่ง C1, C2, C3 หรือ C4 ที่ได้ สัญญาณจะเข้าที่ขา 2 ของอุปกรณ์ U1A และเอาต์พุตคือตัวแหน่ง U2B สัญญาณจะออกที่ขา 14 ได้ผลตอบสนองดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.12 แสดงอินพุตและเอาต์พุตของอุปกรณ์ Infrasonic detector

f (Hz)	Vin(V_{p-p})	Vout(V_{p-p})	f (Hz)	Vin(V_{p-p})	Vout(V_{p-p})
0.01	1.02	420m	11	1.02	4.96
0.02	1.02	960m	13	1.02	4.48
0.03	1.02	2.60	15	1.02	4.08
0.04	1.02	3.80	17	1.02	3.80
0.05	1.02	4.20	19	1.02	3.60
0.1	1.02	5.60	20	1.02	3.52
0.3	1.02	11.40	25	1.02	3.24
0.5	1.02	13.40	30	1.02	3.04
0.7	1.02	14.40	40	1.02	2.76
0.9	1.02	15.40	50	1.02	2.56
1	1.02	15.80	70	1.02	2.20
3	1.02	16.00	100	1.02	1.80
5	1.02	12.80	200	1.02	952m
7	1.02	8.00	500	1.02	416m
9	1.02	6.00	-	-	-

กราฟผลตอบสนองของอุปกรณ์ Infrasonic detector ในภาคเอาต์พุทที่ตำแหน่ง U2B

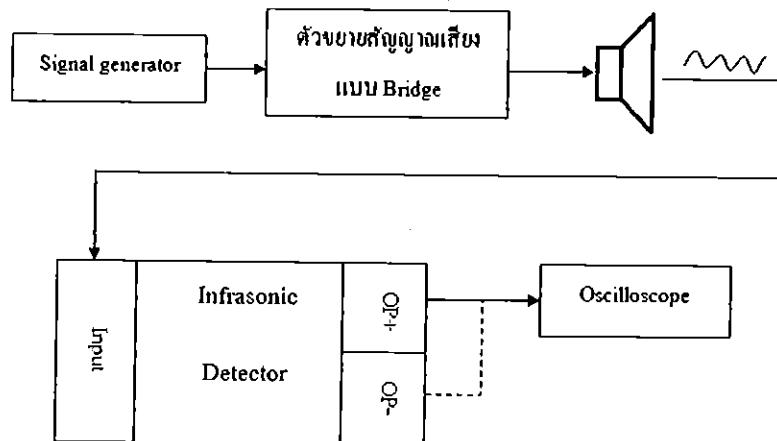


รูปที่ 4.31 ผลตอบสนองของอุปกรณ์ Infrasonic detector

จากรูปที่ 4.31 อินพุทคือตำแหน่ง C1, C2, C3 หรือ C4 ที่ได้ สัญญาณจะเข้าที่ขา 14 ของอปแอมป์ U1A และเอาต์พุทคือตำแหน่ง U2B สัญญาณจะออกที่ขา 14 เป็นการวัดผลตอบสนองของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิก

4.2.8 ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิกที่ผ่านการทดสอบของไมโครโฟน แม้ว (ใช้อุปกรณ์ขยายสัญญาณแบบ Bridge)

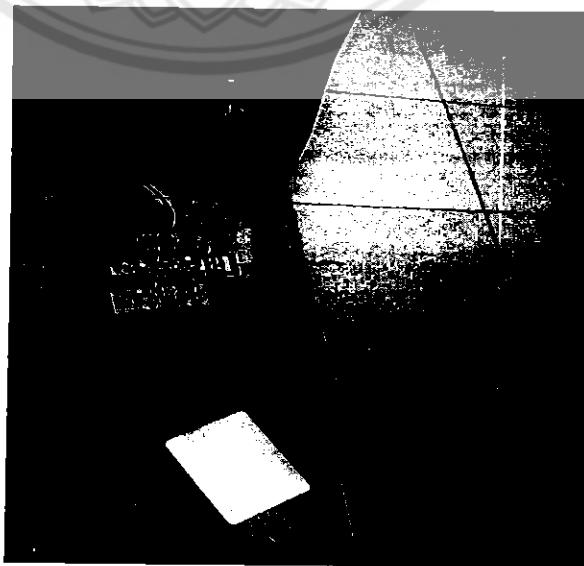
ในการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิกนี้ ได้ทำการเปลี่ยนนาฬิกาทัวร์ขยายสัญญาณเดี่ยงแบบ Bridge แทน เพราะว่าสามารถตอบสนองความถี่ต่ำได้ถึง 0.1 Hz ซึ่งจากเดิมใช้เครื่อง Stereo integrated amplifier ตอบสนองความถี่ต่ำได้เพียง 1 Hz เท่านั้นแสดงค้างรูปที่ 4.4 และเปลี่ยนแหล่งกำเนิดสัญญาณจากเดิมใช้โปรแกรม Scope เปลี่ยนมาใช้คลื่องกำเนิดสัญญาณ (Signal generator) แทน และการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราไนนิกได้ดังรูปที่ 4.32



รูปที่ 4.32 แสดงการทดสอบอุปกรณ์ตรวจขับคลื่นอินฟราเรด

วิธีการทดลอง

1. ต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณเข้ากับตัวขยายสัญญาณแบบ Bridge
2. จากนั้นต่อตัวขยายสัญญาณแบบ Bridge เข้าลำโพงที่เราจะนำมาทดสอบ
3. ให้ไมโครโฟนห่างจากลำโพง 20 cm. แสดงดังตัวอย่างในรูปที่ 4.33
4. ป้อนความถี่ต่างๆ ตามตารางที่ 4.13 วัดค่า V_{out} โดยเครื่องออสซิลโลสโคป (oscilloscope) ทำการบันทึกผลที่ได้ กำหนดให้ลำโพงกระเพื่อมเท่ากันคือ 4 mm.
5. กลับไปทำข้อ 4 ใหม่แต่เปลี่ยนระยะห่างระหว่างไมโครโฟนกับลำโพงเป็น 50 และ 80 cm. ตามลำดับ



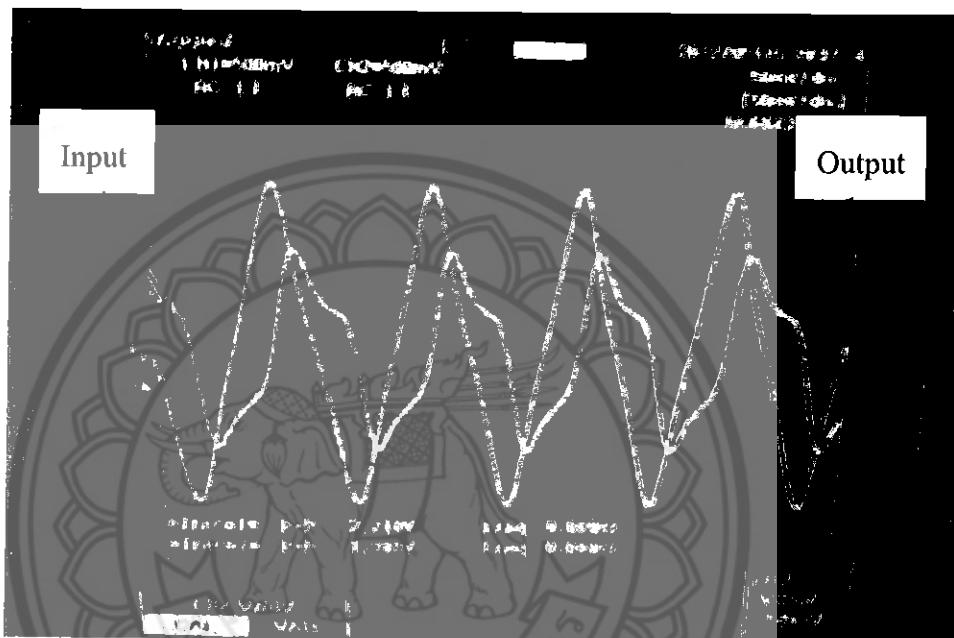
รูปที่ 4.33 ตัวอย่างแสดงถูกย่อของการวางไมโครโฟนห่างจากตัวลำโพง

การใช้ห่อ PVC เพื่อที่จะให้ลำโพงจ่าขคลีนความถี่ต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้เลื่อนขึ้นลงเพื่อกำหนดระบบท่ำของในໂຄຣໂຟນກັບຄອດຄໍາໂພງໃນກາຮັບຄລືນອິນຝຣາໂໂນິກ

ຜອກກາຮັບຄອດຄໍາ

ຮູບສ້າງຍາມທີ່ໄດ້ຈາກກາຮັບຄອດຄໍາອຸປະກອບຕ່າງໆ

- ຕ້ວອຍ່າງສ້າງຍາມທາງເວລາທີ່ຄວາມຖີ່ 9 Hz



ຮູບທີ່ 4.34 ສ້າງຍາມທາງເວລາທີ່ຄວາມຖີ່ 9 Hz ໂດຍໃນໂຄຣໂຟນທ່າງຈາກຄໍາໂພງຮະຍະ 50 cm.

ໂດຍທີ່ Trace1 ເປັນເອົາທີ່ພູຫຼັກ ມີ V/Div = 500 mV ແລະ Time/Div = 50 ms

Trace2 ເປັນອິນຝຣາໂໂນິກ ມີ V/Div = 500 mV ແລະ Time/Div = 50 ms

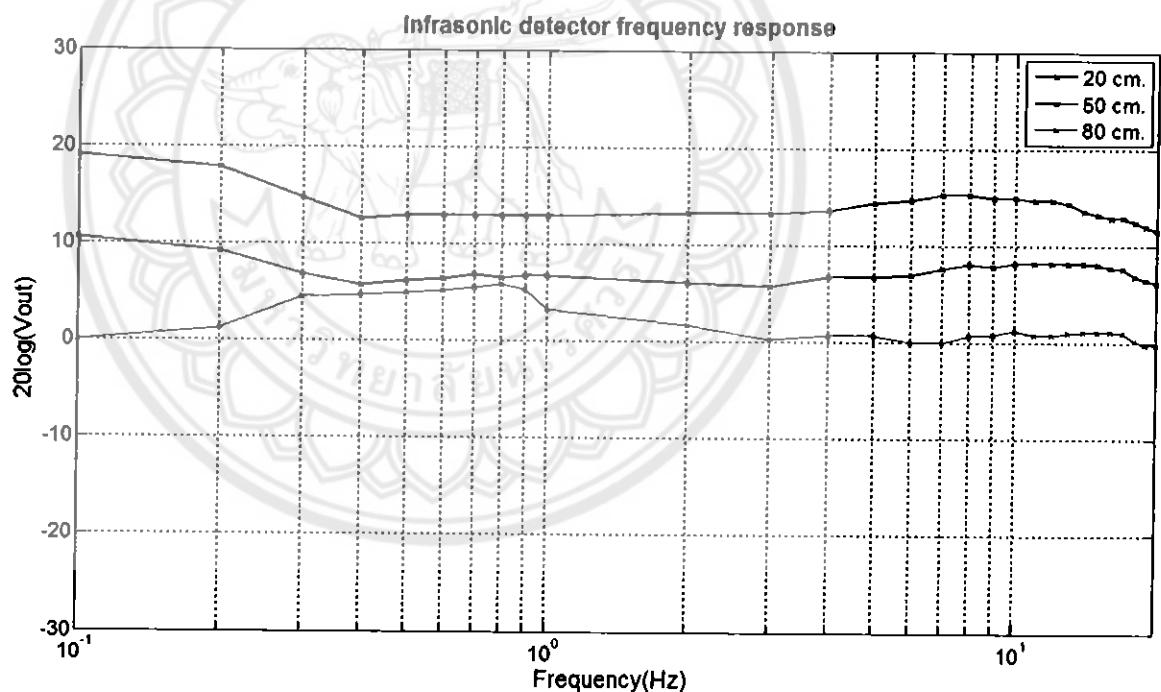
ຕາມທີ່ແສດກກາຮັບຄອດຄໍາໄວ້ດັ່ງຮູບທີ່ 4.34 ສ້າງຍາມທີ່ອິນຝຣາໂໂນິກ (Input) ທຳການວັດຈາກເອົາທີ່ພູຫຼັກຂອງ ວັດຈະ Summing ຕາມຮູບທີ່ 3.3 ເປັນສ້າງຍາມທີ່ໄດ້ຈາກຕ້າວໃນໂຄຣໂຟນຮັບສ້າງຍາມເຂົ້າຜ່ານວົງຈຽວນ ສ້າງຍາມທີ່ອູ້ໃນອຸປະກອບຕ່າງໆ ຢັງຈັນຄລືນອິນຝຣາໂໂນິກ ສ່ວນສ້າງຍາມເອົາທີ່ພູຫຼັກ (Output) ໄດ້ມາຈາກ ອຸປະກອບຕ່າງໆ ຢັງຈັນຄລືນອິນຝຣາໂໂນິກໃນກາຮັບຄອດຄໍາເອົາທີ່ພູຫຼັກ (Op-amp U2B ຫາ 14)

ตารางที่ 4.13 แสดง V_{out} (V_{pp}) ที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดโดยการซดเชยการตกของไมโครโฟน กำหนดให้ลำโพงกระเพื่อมเท่ากันคือ 4 mm. โดยที่ไมโครโฟนห่างจากลำโพงระยะ 20, 50 และ 80 cm.

f (Hz)	V_{out} at 20 cm.	V_{out} at 50 cm	V_{out} at 80 cm
0.1	9.00	3.36	1.00
0.2	7.80	2.88	1.16
0.3	5.44	2.20	1.68
0.4	4.24	1.92	1.72
0.5	4.40	2.04	1.76
0.6	4.40	2.08	1.80
0.7	4.40	2.20	1.88
0.8	4.40	2.12	1.96
0.9	4.40	2.16	1.84
1	4.40	2.16	1.46
2	4.60	2.00	1.22
3	4.60	1.92	1.02
4	4.80	2.16	1.08
5	5.20	2.16	1.08
6	5.40	2.24	1.00
7	5.80	2.40	1.00
8	5.80	2.52	1.08
9	5.60	2.48	1.10
10	5.60	2.56	1.16
11	5.40	2.56	1.10
12	5.40	2.56	1.10
13	5.20	2.56	1.12
14	4.80	2.56	1.14

f (Hz)	Vout at 20 cm.	Vout at 50 cm	Vout at 80 cm
15	4.60	2.52	1.14
16	4.40	2.44	1.14
17	4.40	2.40	1.12
18	4.20	2.20	1.02
19	4.00	2.12	980m
20	3.80	2.04	980m

กราฟผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดนิค แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับ V_{out} (V_{pp}) กำหนดให้ลำโพงกระเพื่อมเท่ากันคือ 4 mm. โดยที่ไม่โกรไฟนกับลำโพงห่างกัน 20, 50 และ 80 cm



รูปที่ 4.35 ผลการทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดนิค แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับ V_{out} (V_{pp}) โดยไม่โกรไฟนกับลำโพงห่างกัน 20, 50 และ 80 cm.

จากรูปที่ 4.35 เครื่องตรวจจับคลื่นอินฟราโซนิก (Infrasonic detector) สามารถวัดสัญญาณความถี่ต่ำสุดได้ถึง 0.1 Hz จนถึง 20 Hz จากที่ได้ทำการทดสอบในโทรศัพท์มือถือ และส่งผลให้สัญญาณรบกวนที่เข้ามานั้นน้อยลงไปด้วยการทำให้ได้สัญญาณเอาร์พุตเป็นรูป Sine wave ในส่วนของสัญญาณความถี่ต่ำกว่า 1 Hz ไม่ค่อยเป็น Sine wave อาจเกิดจากสัญญาณรบกวนภายในตัวอุปกรณ์เอง

เมื่อมีการเพิ่มระดับในโทรศัพท์มือถือขึ้นจะเกิดการลดthonของสัญญาณขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับ DIP Switch เพื่อที่จะเพิ่มอัตราขยายให้กับสัญญาณที่เข้ามาได้



บทที่ 5

สรุปผล

ในบทนี้จะกล่าวถึงสรุปการดำเนินการที่ได้ทำไป ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5.1 สรุปผลของโครงการ

จากการสร้างอุปกรณ์ตัววัดคลื่นอินฟราเรด โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางวิศวกรรมทำให้โครงงานประสบความสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย จากการทดลองใช้ในโทรศัพท์ WM-61A ทำการรับสัญญาณเสียงเข้ามา ผ่านวงจรกรองความถี่รวมถึงวงจรอินพิเกรเตอร์ ซึ่งสามารถวัดคลื่นอินฟราเรด ได้ตามผลการทดลอง ถึงแม้ว่าความสามารถในการรับซ่างความถี่อินฟราเรดจะอยู่ช่วงสั้นๆ ประมาณ 1 m. จากลำโพงกีต้าม แต่ประสิทธิภาพที่สามารถรับซ่างความถี่ธรรมชาติทำได้ใกลกว่านั้น จากผลการทดลอง โดยใช้แหล่งกำเนิดสัญญาณเสียงเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 6 นิ้ว จะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงของโทรศัพท์ห่างจากตัวลำโพงนั้น ซึ่งไกลจากลำโพงมากเท่าใด ความสามารถของอุปกรณ์จะลดลงตามไปด้วย เนื่องจากความสามารถของตัวโทรศัพท์ WM-61A ด้วย จากการที่ตัวโทรศัพท์มีความต่ำสุดในช่วง 20-10,000 Hz ได้คึกว่าในช่วง 0.1-20 Hz นั้นเอง

การทดสอบประสิทธิภาพของ Power Amplifier ในตัวที่เราใช้เป็นตัวขยายสัญญาณตามท้องตลาดทั่วๆ ไป ซึ่งผลที่ได้คือตัวขยายสัญญาณไม่ตอบสนองที่ความถี่ต่ำกว่า 1 Hz จึงได้สร้างตัวขยายสัญญาณขึ้นเอง โดยใช้ไอซี Power Amplifier เบอร์ TDA7294 ทำการต่อวงจรแบบ BRIDGE ผลที่ได้คือตัวขยายสัญญาณตอบสนองได้ถึง 0.1 Hz เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวขยายสัญญาณ ทำให้ทราบถึงความสามารถของโทรศัพท์ได้

การทดสอบการตอบสนองของโทรศัพท์ในโทรศัพท์ เราทำการป้อนสัญญาณจากเครื่องกำเนิดสัญญาณผ่านเข้าตัว Power Amplifier แล้วออกลำโพง จากนั้นนำโทรศัพท์ไปวัดที่ลำโพง ผลการตอบสนองของตัวโทรศัพท์ WM-61A ที่ความถี่ 12-0.1 Hz ทดลองประมาณ 45 dB ซึ่งในตัวอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราเรด ได้ทำการซัดเชยในส่วนของโทรศัพท์แล้ว

5.2 ปัญหาที่พบ

5.2.1 ปัญหาทางด้านแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง

1. ลำโพงที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์มีขนาดเล็ก จึงได้ซึ่งลำโพงขนาดใหญ่นั้นมีราคาสูง
2. ความสามารถของลำโพงถูกจำกัด
3. ประสิทธิภาพการทำงานของลำโพงไม่สูงมากนัก เนื่องจากลำโพงที่มีขนาดเล็ก

5.2.2 ปัญหาทางด้านตัวขยายสัญญาณ

1. ประสิทธิภาพของตัวขยายสัญญาณมีจำกัด
2. ใน การใช้งานตัวขยายสัญญาณเกิดความร้อนที่สูงมาก ทำให้การใช้งานในแต่ละครั้งมีเวลาที่จำกัด

5.2.3 ปัญหาทางด้านไมโครโฟน

1. ความสามารถของไมโครโฟนมีจำกัด
2. ในไมโครโฟนที่ตอบสนองสัญญาณเสียงในช่วงคลื่นเสียงอินฟราเรดมีราคาที่สูงมาก
3. ในไมโครโฟนที่ดีๆ ส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีขาย ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งก็ต้องใช้เวลานานในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง

5.3 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ

5.3.1 แก้ไขปัญหาทางด้านแหล่งกำเนิดสัญญาณเสียง

1. การใช้ลำโพงขนาดใหญ่ๆ จะได้ผลการทดลองที่ดีขึ้นตามนั้นหมายถึงการเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อบริการซึ่งก็มีราคาที่สูงพอสมควร
2. ในการเพิ่มขีดความสามารถของลำโพงให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของเรานั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาทางด้านการออกแบบลำโพงที่ดีและให้มีประสิทธิภาพ
3. เปลี่ยนไปใช้ลำโพงที่มีขนาดใหญ่กว่า เพื่อจะได้ประสิทธิภาพในการวัดสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น

5.3.2 แก้ไขปัญหาทางด้านตัวขยายสัญญาณ

1. เนื่องจากประสิทธิภาพของตัวขยายสัญญาณมีจำกัด จึงจำเป็นต้องสร้างตัวขยายขึ้นมาใหม่โดยให้มีประสิทธิ์ในการทำงานที่เพิ่มขึ้นและตอบสนองกับช่วงสัญญาณเสียงที่เราใช้งาน หรือจะนำเอาตัวขยายสัญญาณเดิมที่เรามี ที่มีขายทั่วๆ ไปตามห้องตลาด มาแก้ไข

- ความถี่คัตอฟ (cut-off frequency) ให้ตอบสนองในช่วงความถี่ที่เราใช้งาน
2. ความร้อนที่สูงมากจากตัวขยายสัญญาณนั้น อาจนำไปโดยการเปลี่ยนขนาดของฮีทซิ้งค์ ระบบความร้อน (Heat sink) ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

5.3.3 แก้ไขปัญหาทางด้านไมโครโฟน

1. ควรลองเปลี่ยนไปใช้ตัวไมโครโฟนที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นประมาณ 2 นิ้ว เพื่อให้การรับสัญญาณเสียงได้ดีขึ้น
2. ถ้าต้องการใช้ในโทรศัพท์เป็นตัวรับสัญญาณเสียงจริงๆ การใช้ในโทรศัพท์ที่ตอบสนองสัญญาณเสียงในช่วงคลื่นเสียงอินฟราโซนิกดีกว่า นั้นก็ต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อขึ้นด้วย
3. ลองเปลี่ยนตัวรับสัญญาณเสียงใหม่จากเดิมที่ใช้ในโทรศัพท์ เป็นตัวเปลี่ยนไปใช้อ่ายอ่นแทน

5.4 แนวทางในการพัฒนาเพิ่มเติม

1. พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอินฟราโซนิกให้แสดงผลและเก็บบันทึกผลต่างๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์โดยตรง
2. ลองเพิ่มจำนวนไมโครโฟนจากเดิมใช้ 4 ตัว ลองใช้เป็น 8, 12, 16 ตัวตามลำดับ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสัญญาณเสียง
3. อาจใช้วงจรparaเมตริก อิครอไลเซอร์ (Parametric EQ) ที่จะใช้ในการกรองความถี่ที่ไม่จำเป็นออก

เอกสารอ้างอิง

- Donald P. Leach. (1992). **Discrete and Integrated Circuit Electronics.** Santa Clara University.
- P. J. McChesney . (2002). **Description of Four Microphone Infrasonic Summing Amplifier.**
- Volcanology research., The University of New Hampshire. Retrieved June 29, 2011,
<http://volcanomodels.sr.unh.edu/jbj/MICROPHONES/PMC4.pdf>
- ผู้จัดการอน ໄลต์. (2005). เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวใต้สมุทร. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=31312
- น.สพ. กานต์ เกษภุก्त. (พฤษภาคม 2551). ชนรนสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย.
 หนึ่งแพนด้ารูส่องหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่?. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
<http://zoowildlifevet.com/?p=223>
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (มีนาคม 2555). ตัวต้านทาน. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
[http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99](http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99)
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (มีนาคม 2555). ตัวเก็บประจุ. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0>
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (มีนาคม 2555). แผ่นดินไหว. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7>
- วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (มีนาคม 2555). ไดโอด. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2554, จาก
<http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94>

ກາຄມວກ

Microphone WM-61A

Panasonic

Microphone Cartridges

Omnidirectional Back Electret Condenser Microphone Cartridge

Series: **WM-61A**
WM-61B (pin type)



■ Features

- Small microphones for general use
- Back electret type designed for high resistance to vibrations, high signal-to-noise ratio
- High sensitivity type
- Microphone with pins for flexible PCB (WM-61B type)

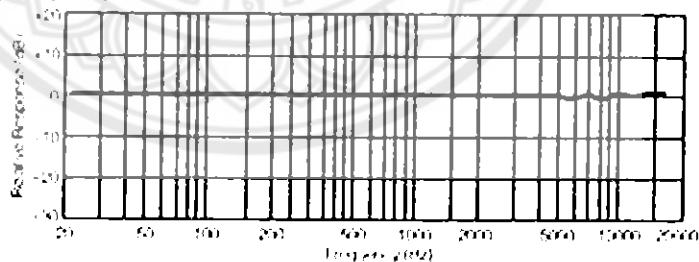
■ Sensitivity

$V_s = 2.0V$	$-35 \pm 4dB$
$R_L = 2.2k\Omega$	

■ Specifications

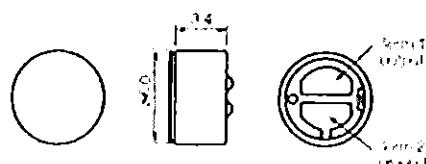
Sensitivity	$-35 \pm 4dB$ (0db = 1V/pa, 1kHz)
Impedance	Less than 2.2 k Ω
Directivity	Omnidirectional
Frequency	20–20 000 Hz
Max. operation voltage	10V
Standard operation voltage	2V
Current consumption	Max. 0.5 mA
Sensitivity reduction	Within -3 dB at 1.5V
S/N ratio	More than 62 dB

■ Typical Frequency Response Curve

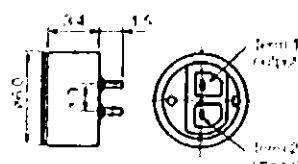


■ Dimensions in mm (not to scale)

WM-61A



WM-61B



Design and specifications are subject to change without notice. Ask factory for technical specifications before purchase and/or use.
Whenever a doubt about safety arises from this product, please contact us immediately for technical consultation.

LT1014

LT1014, LT1014A, LT1014D
QUAD PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS

SLOS039C - JULY 1989 - REVISED SEPTEMBER 1999

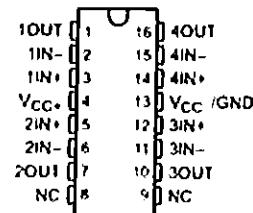
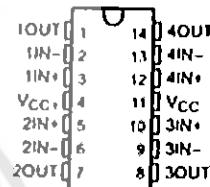
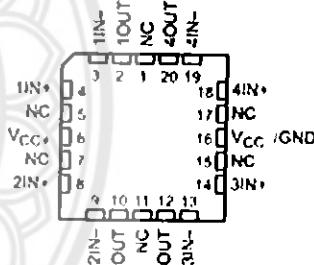
- **Single-Supply Operation:** Input Voltage Range Extends to Ground, and Output Swings to Ground While Sinking Current
- Input Offset Voltage 300 μV Max at 25°C for LT1014
- Offset Voltage Temperature Coefficient 2.5 $\mu\text{V}/\text{C}$ Max for LT1014
- Input Offset Current 1.5 nA Max at 25°C for LT1014
- High Gain 1.2 V/ μV Min ($R_L = 2 \text{ k}\Omega$), 0.5 V/ μV Min ($R_L = 600 \text{ }\Omega$) for LT1014
- Low Supply Current 2.2 mA Max at 25°C for LT1014
- Low Peak-to-Peak Noise Voltage 0.55 μV Typ
- Low Current Noise 0.07 pA/ $\sqrt{\text{Hz}}$ Typ

description

The LT1014, LT1014A, and LT1014D are quad precision operational amplifiers with 14-pin industry-standard configuration. They feature low offset-voltage temperature coefficient, high gain, low supply current, and low noise.

The LT1014, LT1014A, and LT1014D can be operated with both dual +15-V and single 5-V power supplies. The common-mode input voltage range includes ground, and the output voltage can also swing to within a few millivolts of ground. Crossover distortion is eliminated.

The LT1014C and LT1014AC are characterized for operation from 0°C to 70°C. The LT1014I and LT1014DI are characterized for operation from -40°C to 105°C. The LT1014M, LT1014AM and LT1014DM are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

**DW PACKAGE
(TOP VIEW)****JOR H PACKAGE
(TOP VIEW)****FK PACKAGE
(TOP VIEW)**

NC -- No internal connection



Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

PRODUCTION DATA. Datasheets are current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of Texas Instruments Standard Terms and Conditions. Periodic product review done by necessary. Actual testing of all parameters.

Copyright © 1999, Texas Instruments Incorporated

**TEXAS
INSTRUMENTS**
DESIGN YOUR WORLD

IC7660

intersil

Data Sheet

April 1999 File Number 3072.4

CMOS Voltage Converters

The Intersil ICL7660 and ICL7660A are monolithic CMOS power supply circuits which offer unique performance advantages over previously available devices. The ICL7660 performs supply voltage conversions from positive to negative for an input range of +1.5V to +10.0V resulting in complementary output voltages of -1.5V to -10.0V and the ICL7660A does the same conversions with an input range of +1.5V to +12.0V resulting in complementary output voltages of -1.5V to -12.0V. Only 2 noncritical external capacitors are needed for the charge pump and charge reservoir functions. The ICL7660 and ICL7660A can also be connected to function as voltage doublers and will generate output voltages up to +18.6V with a +10V input.

Contained on the chip are a series DC supply regulator, RC oscillator, voltage level translator, and four output power MOS switches. A unique logic element senses the most negative voltage in the device and ensures that the output N-Channel switch source-substrate junctions are not forward biased. This assures latchup free operation.

The oscillator, when unloaded, oscillates at a nominal frequency of 10kHz for an input supply voltage of 5.0V. This frequency can be lowered by the addition of an external capacitor to the 'OSC' terminal, or the oscillator may be overdriven by an external clock.

The "LV" terminal may be tied to GROUND to bypass the internal series regulator and improve low voltage (LV) operation. At medium to high voltages (+3.5V to +10.0V for the ICL7660 and +3.5V to +12.0V for the ICL7660A), the LV pin is left floating to prevent device latchup.

Ordering Information

PART NO.	TEMP. RANGE (°C)	PACKAGE	PKG. NO.
ICL7660CBA	0 to 70	8 Ld SOIC (N)	M8.15
ICL7660CBA-T	0 to 70	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	M8.15
ICL7660CPA	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
ICL7660ATV†	0 to 70	8 Pin Metal Can	T8.C
ICL7660ACBA	0 to 70	8 Ld SOIC (N)	M8.15
ICL7660ACBA-T	0 to 70	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	M8.15
ICL7660ACPA	0 to 70	8 Ld PDIP	E8.3
ICL7660ABA	-40 to 85	8 Ld SOIC (N)	M8.15
ICL7660ABA-T	-40 to 85	8 Ld SOIC (N) Tape and Reel	M8.15
ICL7660APIA	-40 to 85	8 Ld PDIP	E8.3

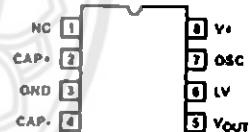
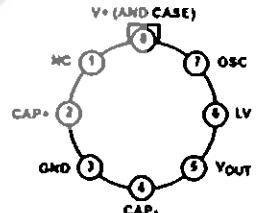
† Add .8830 to part number # 8838 processing is required

Features

- Simple Conversion of +5V Logic Supply to ±5V Supplies
- Simple Voltage Multiplication ($V_{OUT} = (\pm)nV_{IN}$)
- Typical Open Circuit Voltage Conversion Efficiency 99.9%
- Typical Power Efficiency 98%
- Wide Operating Voltage Range
 - ICL7660 1.5V to 10.0V
 - ICL7660A 1.5V to 12.0V
- ICL7660A 100% Tested at 3V
- Easy to Use - Requires Only 2 External Non-Critical Passive Components
- No External Diode Over Full Temp. and Voltage Range

Applications

- On Board Negative Supply for Dynamic RAMs
- Localized µProcessor (8080 Type) Negative Supplies
- Inexpensive Negative Supplies
- Data Acquisition Systems

PinoutsICL7660, ICL7660A (PDIP, SOIC)
TOP VIEWICL7660 (METAL CAN)
TOP VIEW

LT1355

LT1355/LT1356**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS** (Note 1)

Total Supply Voltage (V^+ to V^-)	36V	Operating Temperature Range (Note 7) ...	-40°C to 85°C
Differential Input Voltage (Transient Only) (Note 2)	$\pm 10V$	Specified Temperature Range (Note 8) ...	-40°C to 85°C
Input Voltage	$\pm V_S$	Maximum Junction Temperature (See Below)	
Output Short-Circuit Duration (Note 3)	Indefinite	Plastic Package	150°C
		Storage Temperature Range	-65°C to 150°C
		Lead Temperature (Soldering, 10 sec)	300°C

PACKAGE/ORDER INFORMATION

TOP VIEW	ORDER PART NUMBER	TOP VIEW	ORDER PART NUMBER
	LT1355CN8		LT1355CS8
			S8 PART MARKING
			1355
TOP VIEW	ORDER PART NUMBER	TOP VIEW	ORDER PART NUMBER
	LT1356CN		LT1356CS

Consult factory for Industrial and Military grade parts.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA = 25°C, VCM = 0V unless otherwise noted.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	V _{SUPPLY}	MIN	TYP	MAX	UNITS
V _{OS}	Input Offset Voltage		$\pm 15V$	0.3	0.8		mV
			$\pm 5V$	0.3	0.8		mV
			$\pm 2.5V$	0.4	1.0		mV
I _{OS}	Input Offset Current		$\pm 2.5V$ to $\pm 15V$	20	70		nA
I _B	Input Bias Current		$\pm 2.5V$ to $\pm 15V$	80	300		nA
e _n	Input Noise Voltage	f = 10kHz	$\pm 2.5V$ to $\pm 15V$	10			nV/Hz
I _n	Input Noise Current	f = 10kHz	$\pm 2.5V$ to $\pm 15V$	0.6			pA/Hz
R _{IN}	Input Resistance	V _{CM} = $\pm 12V$	$\pm 15V$	70	160		MΩ
	Input Resistance	Differential	$\pm 15V$	11			MΩ
C _{IN}	Input Capacitance		$\pm 15V$	3			pF

LINEAR

LP2951

Connection Diagrams

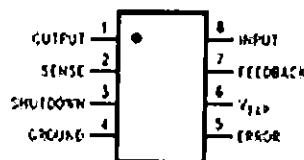
TO-92 Plastic Package (Z)



TL/H-8544-2

Order Number LP2950ACZ-3.0, LP2950CZ-3.0,
LP2950ACZ-3.3, LP2950CZ-3.3 LP2950ACZ-5.0
or LP2950CZ-5.0

See NS Package Number Z03A

Dual-In-Line Packages (N, J)
Surface-Mount Package (M)

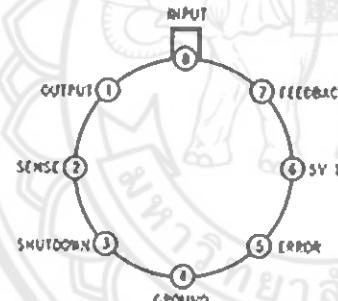
TL/H-8544-24

Order Number LP2951CJ, LP2951ACJ, LP2951J,
LP2951J/883 or 5962-3870501MPA
See NS Package Number J08A

Order Number LP2951ACH, LP2951CN, LP2951ACH-3.0,
LP2951CN-3.0, LP2951ACH-3.3 or LP2951CN-3.3
See NS Package Number N08E

Order Number LP2951ACM, LP2951CM,
LP2951ACM-3.0, LP2951CM-3.0,
LP2951ACM-3.3 or LP2951CM-3.3
See NS Package Number M08A

Metal Can Package (H)

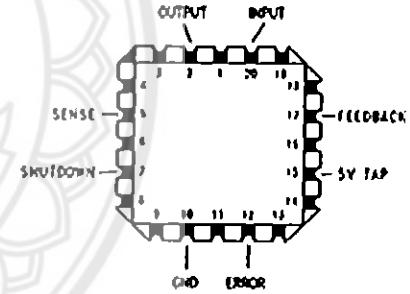


Top View

TL/H-8544-13

Order Number LP2951H/883 or
5962-3870501MGA
See NS Package Number H08C

Leadless Chip Carrier (E)



Top View

TL/H-8544-24

Order Number LP2951E/883 or 5962-3870501M2A
See NS Package Number E20A

P6KE6V8(C)A

P6KE6V8(C)A - P6KE440(C)A



Transient Voltage Suppressors P6KE6V8(C)A - P6KE440(C)A

Features

- Glass passivated junction.
- 600W Peak Pulse Power capability at 1.0 ms.
- Excellent clamping capability.
- Low incremental surge resistance.
- Fast response time; typically less than 1.0 ns from 0 volts to BV for unidirectional and 5.0 ns for bidirectional.
- Typical I_{g} less than 1.0 μA above 10V.



DO-15
COLOR BAND DENOTES CATHODE
ON UNIDIRECTIONAL DEVICES ONLY. NO
COLOR BAND ON BI-DIRECTIONAL DEVICES

DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS

- Bidirectional types use CA suffix.
- Electrical Characteristics apply in both directions.

600 Watt Transient Voltage Suppressors**Absolute Maximum Ratings*** $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_{PPM}	Peak Pulse Power Dissipation at $T_A = 1\text{ms}$	600	W
I_{PPM}	Peak Pulse Current	see table	A
P_0	Power Dissipation 375 " lead length @ $T_A = 75^\circ\text{C}$	5.0	W
I_{FSU}	Non-repetitive Peak Forward Surge Current superimposed on rated load (JEDEC method) (Note 1)	100	A
T_{STG}	Storage Temperature Range	-65 to +175	C
T_J	Operating Junction Temperature	+175	C

* These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.
Note 1: Measured on 8.3 ms single half sine wave. Duty cycle = 4 pulses per minute maximum.

TDA7294

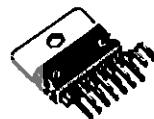


TDA7294

100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY

- VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE ($\pm 40V$)
- DMOS POWER STAGE
- HIGH OUTPUT POWER (UP TO 100W MUSIC POWER)
- MUTING/STAND-BY FUNCTIONS
- NO SWITCH ON/OFF NOISE
- NO BOUCHEROT CELLS
- VERY LOW DISTORTION
- VERY LOW NOISE
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- THERMAL SHUTDOWN

MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY



Multiwatt15
ORDERING NUMBER: TDA7294V

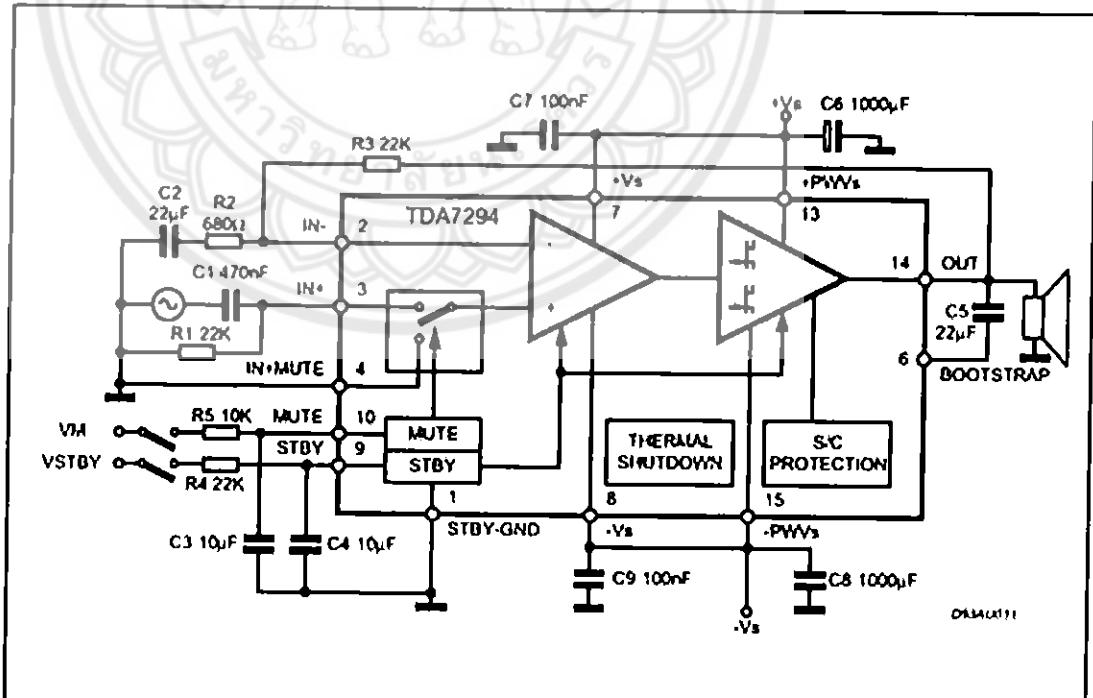
DESCRIPTION

The TDA7294 is a monolithic integrated circuit in Multiwatt15 package, intended for use as audio class AB amplifier in Hi-Fi field applications (Home Stereo, self powered loudspeakers, Top-class TV). Thanks to the wide voltage range and

to the high out current capability it is able to supply the highest power into both 4Ω and 8Ω loads even in presence of poor supply regulation, with high Supply Voltage Rejection.

The built in muting function with turn on delay simplifies the remote operation avoiding switching on-off noises.

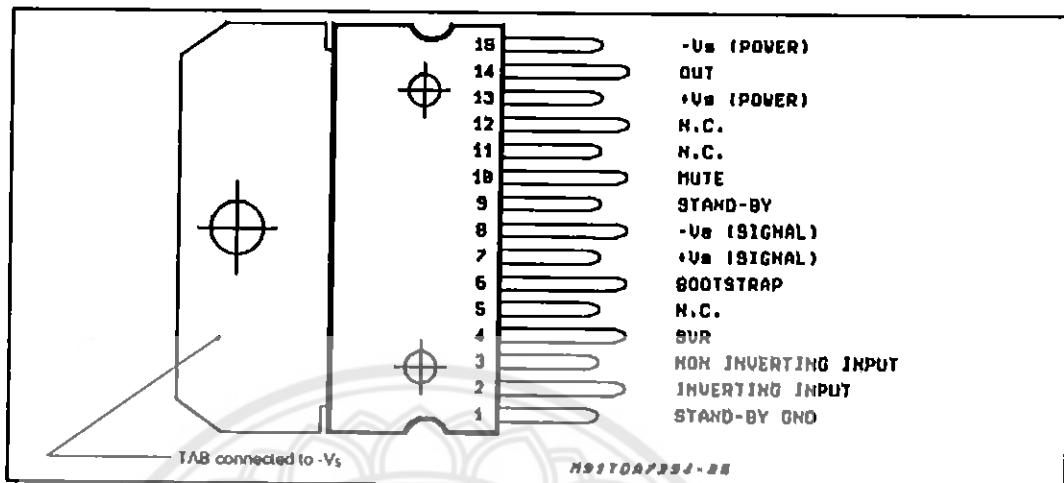
Figure 1: Typical Application and Test Circuit



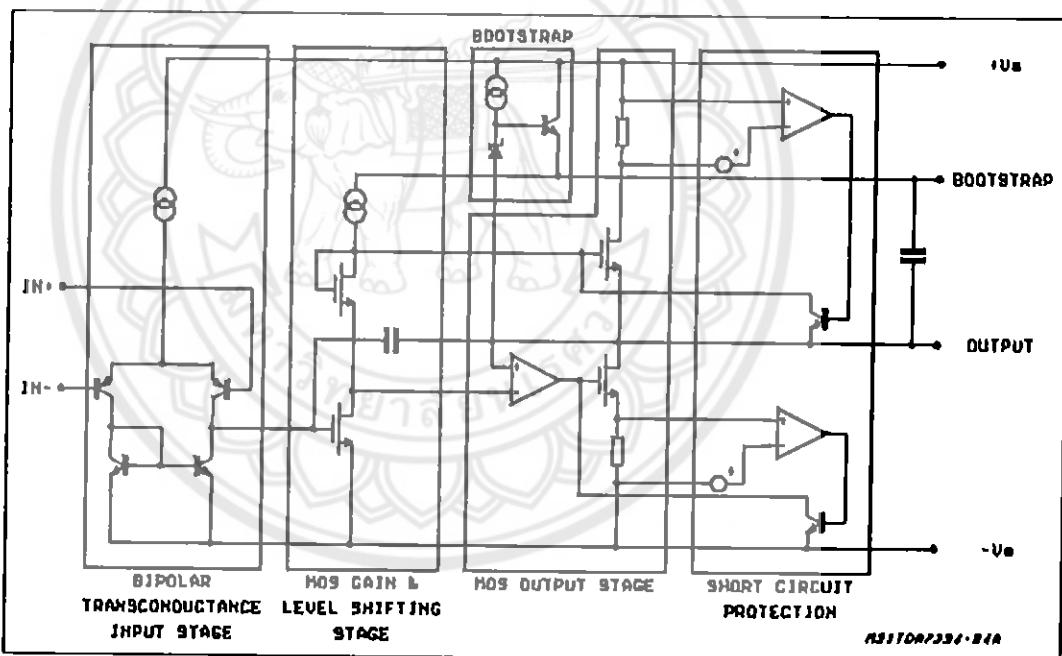
TDA7294 (Top)

TDA7294

PIN CONNECTION (Top view)



BLOCK DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V _S	Supply Voltage (No Signal)	±50	V
I _O	Output Peak Current	10	A
P _{tot}	Power Dissipation T _{case} = 70 °C	50	W
T _{op}	Operating Ambient Temperature Range	0 to 70	°C
T _{stg} , T _J	Storage and Junction Temperature	150	°C

TDA7294 (10)

TDA7294

BRIDGE APPLICATION

Another application suggestion is the BRIDGE configuration, where two TDA7294 are used, as shown by the schematic diagram of figure 25.

In this application, the value of the load must not be lower than 8 Ohm for dissipation and current capability reasons.

A suitable field of application includes HI-FI/TV subwoofers realizations.

The main advantages offered by this solution are:

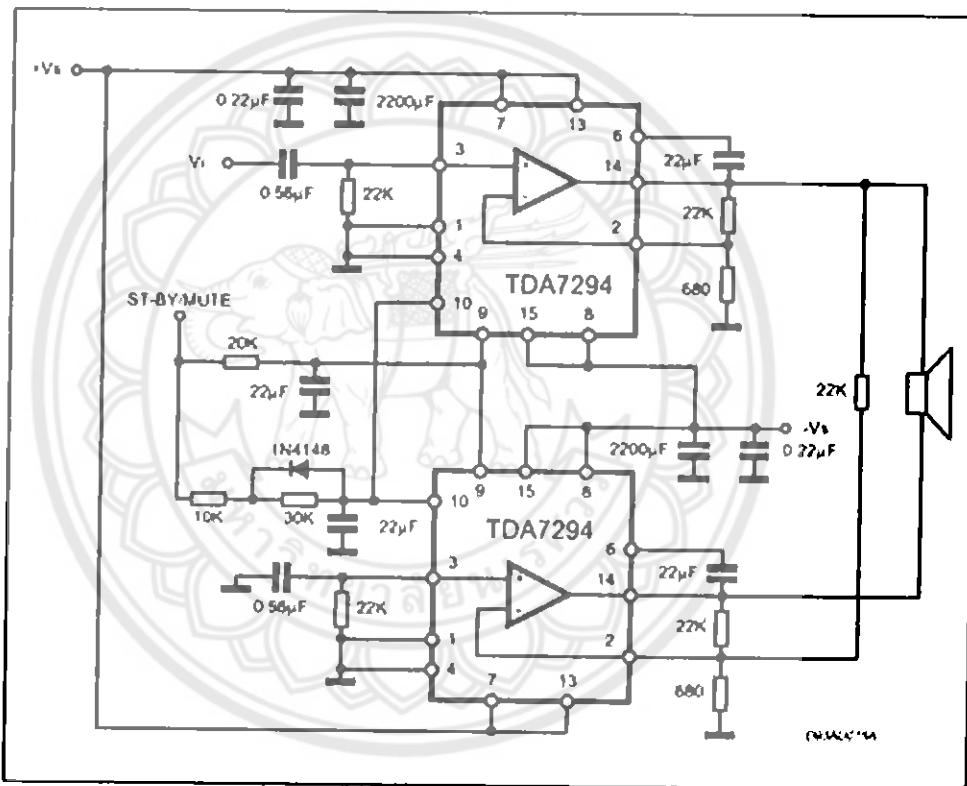
- High power performances with limited supply voltage level

- Considerably high output power even with high load values (i.e. 16 Ohm).

The characteristics shown by figures 27 and 28, measured with loads respectively 8 Ohm and 16 Ohm.

With $R_L = 8$ Ohm, $V_S = \pm 25V$ the maximum output power obtainable is 150 W, while with $R_L = 16$ Ohm, $V_S = \pm 35V$ the maximum P_{out} is 170 W.

Figure 25: Bridge Application Circuit



TDA7294 (ต่อ)

TDA7294

Figure 26: Frequency Response of the Bridge Application

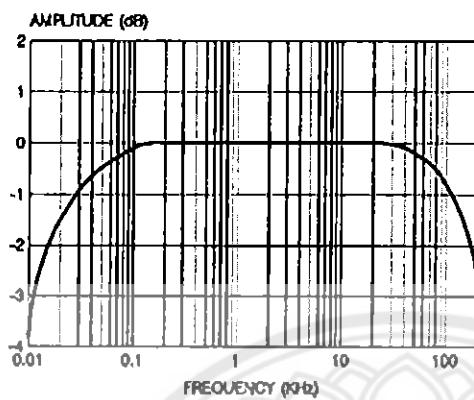


Figure 27: Distortion vs. Output Power

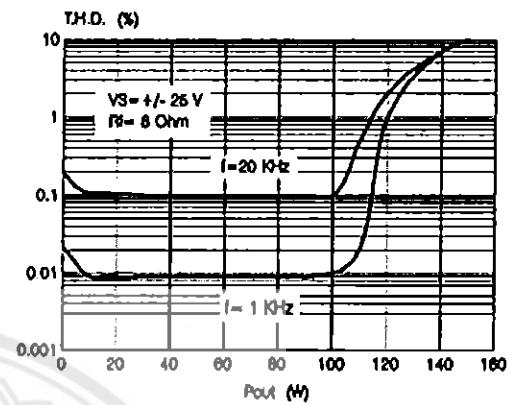


Figure 28: Distortion vs. Output Power

